Schriftenreihe des Instituts für Keramik im Maschinenbau IKM 53

Mikrostrukturelle Einflüsse auf das R-Kurvenverhalten bei Siliciumnitridkeramiken

Stefan Fünfschilling



Stefan Fünfschilling

Mikrostrukturelle Einflüsse auf das R-Kurvenverhalten bei Siliciumnitridkeramiken

Schriftenreihe des Instituts für Keramik im Maschinenbau IKM 53

Institut für Keramik im Maschinenbau, Karlsruher Institut für Technologie

Mikrostrukturelle Einflüsse auf das R-Kurvenverhalten bei Siliciumnitridkeramiken

von Stefan Fünfschilling

Institut für Keramik im Maschinenbau (IKM), Karlsruher Institut für Technologie



Dissertation, Karlsruher Institut für Technologie Fakultät für Maschinenbau, Tag der mündlichen Prüfung: 15.12.2009

Impressum

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) KIT Scientific Publishing Straße am Forum 2 D-76131 Karlsruhe www.uvka.de

KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft





Diese Veröffentlichung ist im Internet unter folgender Creative Commons-Lizenz publiziert: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/

KIT Scientific Publishing 2010 Print on Demand

ISSN: 1436-3488 ISBN: 978-3-86644-470-6

Mikrostrukturelle Einflüsse auf das R- Kurvenverhalten bei Siliciumnitridkeramiken

Zur Erlangung des akademischen Grades

eines

Doktors der Ingenieurwissenschaften

von der Fakultät für Maschinenbau des

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

genehmigte

Dissertation

von

Dipl.- Ing. Stefan Fünfschilling

aus Lörrach

Tag der mündlichen Prüfung:	15.12.2009
Hauptreferent:	Prof. Dr. rer. nat. M. J. Hoffmann
Korreferent :	Prof. Dr. rer. nat. G. A. Schneider

Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Keramik im Maschinenbau (IKM) des Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Das von mir bearbeitete Projekt war Teil des Sonderforschungsbereichs 483 "Hochbeanspruchte Gleit- und Friktionssysteme auf Basis ingenieurkeramischer Werkstoffe".

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. M. J. Hoffmann, dafür dass er mir die Möglichkeit gab, diese Arbeit an seinem Institut durchführen zu können. Seine stete Unterstützung und seine wertvollen Anregungen trugen essentiell zum Gelingen dieser Arbeit bei.

Weiterhin möchte ich Herrn Prof. Dr. G. A. Schneider für die Übernahme des Korreferats und für die Zurverfügungstellung der R- Kurvenmessanlage danken.

Darüber hinaus möchte ich mich sehr herzlich bei Herrn Dr. T. Fett für seine unzähligen Erklärungen zu seinen Veröffentlichungen und bruchmechanischen Errungenschaften bedanken. Seine Tür stand mir jederzeit offen, um meine Ergebnisse mit ihm zu erörtern. Ohne ihn wären viele Aspekte dieser Arbeit nicht berücksichtigt worden.

Herrn P.F. Becher danke ich für die Durchführung der Nanoindentationen in den oxinitridischen Gläsern und für die anregenden Diskussionen.

Dem "Karlsruhe House of Young Scientists" möchte ich für die finanzielle Unterstützung meines vier monatigen Forschungsaufenthalts in den USA danken.

Für das Gelingen meiner Arbeit war das sehr angenehme Arbeitsklima am Institut sehr wichtig, wofür ich mich bei meinen Kollegen am Institut sehr herzlich bedanken möchte. Herrn Dr. R. Oberacker möchte ich für seine Anregungen und sein Interesse danken.

Tatkräftige Unterstützung erfuhr ich durch meine studentischen Hilfskräfte Nicole Bühler, Florian Reinhardt, Florian Schwarz und Raphael Blistein, sowie meinen Studienarbeitern Christine Gerlinger und Volker Walter.

Schlussendlich möchte ich mich noch ganz besonders bei meiner Frau Cindy bedanken, die mich immer mit Geduld und großer Zuversicht unterstützte.

Inhaltsverzeichnis

1	I	Einl	eitu	ng	1
2	I	Ken	Intni	sstand	3
	2.1	1	Silic	ciumnitrid	3
		2.1.	1	Sintern	3
	2	2.1.	2	Kornwachstum	7
		2.1.	3	Grenzflächenfestigkeit	9
	2.2	2	Bru	chmechanik	.11
		2.2.	1	Einfluss der R- Kurve auf die Festigkeit	. 19
		2.2.	2	Einfluss der R- Kurve auf das unterkritische Risswachstum / zyklisc	hes
	I	Riss	swad	chstum	.21
3	I	Exp	erim	nentelle Durchführung	. 25
	3.1	1	Ker	amikherstellung	. 25
	;	3.1.	1	Pulverherstellung	. 25
	(3.1.	2	Grünkörperherstellung	. 26
	;	3.1.	3	Sinterung	. 26
	3.2	2	Gef	ügecharakterisierung	. 28
	(3.2.	1	Dichtebestimmung	. 28
	(3.2.	2	Herstellung von keramographischen Schliffen	. 29
	(3.2.	3	Röntgenographische Analysen	. 30
	(3.2.	4	Mikroskopie	. 30
	3.3	3	Med	chanische Kenngrößen	. 30
	(3.3.	1	Härte, 4- Punktbiegefestigkeit, Bruchzähigkeit	. 31
	(3.3.	2	Rissspitzenzähigkeitsbestimmung mit dem COD Verfahren	. 33
	;	3.3.	3	R- Kurven von 1-dimensionalen Rissen	. 34
	ć	3.3.	4	R- Kurven von 2-dimensionalen Rissen	.36
4	I	Erg	ebni	sse	. 39
	4.1	1	Sint	terung	. 39

4	.2 Mik	rostruktur	40
4	.3 Me	chanische Eigenschaften	44
	4.3.1	Härte	44
	4.3.2	Festigkeit	45
	4.3.3	Zähigkeit	47
	4.3.4	Rissspitzenzähigkeit	47
	4.3.5	R- Kurven (1- dimensionale Risse)	53
	4.3.6	Brückenspannungsbestimmung	59
	4.3.7	R Kurven (2-dimensionale Risse)	65
5	Diskuss	sion	69
6	Zusammenfassung93		

1 Einleitung

Die immer höher werdenden Anforderungen an die Werkstoffe, verlangen ein immer besseres Verständnis des Werkstoffverhaltens um dadurch gezielt die benötigenden Eigenschaften einstellen zu können. Das zum Bereich der Strukturkeramik zählende Siliciumnitrid, bietet neben hoher Festigkeit und Bruchzähigkeit auch sehr gute Hochtemperatureigenschaften. Durch das Variieren der Mikrostruktur und der Wahl der Sinteradditive kann das Werkstoffverhalten der Siliciumnitridkeramik verändert werden. Siliciumnitrid wird heute überwiegend als Schneidkeramik bei der Gusseisenbearbeitung, sowie bei der Aluminiumverarbeitung eingesetzt. Ein neuer Anwendungsbereich ist das Warmwalzen von Drähten, wobei Siliciumnitrid als Walzenwerkstoff verwendet wird. Alle Anwendungen dieses Werkstoffs haben eines gemeinsam: Die hohe mechanische Beanspruchung der Keramik. Von großer Bedeutung ist hierbei der Widerstand der Keramik gegen instabile, katastrophale Rissausbreitung. Die mechanische Kenngröße der Keramik gegen instabile Rissausbreitung, ist die Bruchzähigkeit. Im Fall von Siliciumnitrid ist die Bruchzähigkeit kein einzelner, fester Wert, sondern dieser steigt mit der Rissverlängerung. Dieses Verhalten wird als R- Kurveneffekt bezeichnet, wobei die R- Kurve von einem Startwert, der sogenannten Rissspitzenzähigkeit, in den meisten Fällen bis zu einem Plateauwert ansteigt. Durch Experimente und theoretische Berechnungen ist bekannt, dass die R- Kurve keine Materialeigenschaft ist, sondern von der Art der Belastung und der Proben- und Rissgeometrie abhängig ist. Das einzige, unabhängige Materialgesetz, dass von den R- Kurven abgeleitet werden kann, ist das Brückenspannungsgesetz.

Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit bereits bestehende Methoden zur R-Kurvenmessung aufgegriffen und verfeinert, bzw. neue entwickelt, um daraus das Brückenspannungsgesetz ableiten zu können. Des Weiteren soll geprüft werden, ob das Brückenspannungsgesetz verwendet werden kann, um mit dessen Hilfe R- Kurven für bestimmte Belastungen vorhersagen zu können.

Das R- Kurvenverhalten von Siliciumnitridkeramiken kann sowohl über die Mikrostruktur, d.h. vor allem über die Korngrößen- und Streckungsgradverteilung, als auch über die Grenzflächenfestigkeit zwischen Siliciumnitridkorn und Sekundärphase beeinflusst werden. Es ist bekannt, dass eine schwache Grenzflächenfestigkeit einen flacheren Anstieg der R- Kurve hervorruft. Des Weiteren erhöhen große, langgestreckte Siliciumnitridkörner die Lage des Plateauwerts. Dennoch fehlt bislang eine Beschreibung für das R-Kurvenverhalten in Siliciumnitridkeramiken, welche alle Aspekte und Einflussgrößen bewertet und berücksichtigt. Aus diesem Grund sollen werden. Siliciumnitrid-Varianten untersucht die unterschiedliche Grenzflächenfestigkeiten und Mikrostrukturen aufweisen.

Ziel dieser Arbeit ist das Entwickeln von neuen Mess- und Auswertemethoden von R- Kurven und Brückenspannungen. Weiterhin soll eine Beschreibung der Einflussgrößen, wie Mikrostruktur und Grenzflächenfestigkeit, auf die R- Kurve von Siliciumnitrid heraus gearbeitet werden, um mit diesen Erkenntnissen die zuvor erwähnten Materialeigenschaften gezielt an die Belastung des Bauteils (z.B. Walzen) anzupassen.

2 Kenntnisstand

2.1 Siliciumnitrid

Siliciumnitrid ist eine über den Flüssigphasensinterprozess hergestellte Strukturkeramik, die in zwei kristallographischen Modifikationen vorliegen kann. Beide Modifikationen bestehen aus Tetraeder Einheiten mit jeweils einem Siliziumatom, welches von drei Stickstoffatomen umgeben ist. Diese SiN₃-Tetraeder sind über die Stickstoffatome miteinander verbunden. Die metastabile α- Modifikation weist die Stapelfolge ABCD auf und unterbricht dadurch die in der β-Modifikation auftretenden Kanäle. Hardie und Jack [Har-57] wiesen die Einheitszelle des β -Si₃N₄, bestehend aus Si₆N₈, der P6₃/m Raumgruppe zu. Die α - Modifikation, bestehend aus Si₁₂N₁₆, wurde der Raumgruppe P3₁/c zugeteilt. Eine weitere mögliche Raumgruppe für die β -Modifikation ist die P6₃, welche Ching et al. [Chi-00] mit einer auf der Density-Functional Theory (DFT) basierenden "ab initio" Berechnung aufzeigte. Eine kubische Spinellform von Si₃N₄, mit der Raumgruppe Fd₃/m, existiert nicht in Siliciumnitridkeramiken. Durch Experimente [Zer-99] und anhand von "ab initio" Berechnungen konnte die Spinellform jedoch nachgewiesen werden [Chi-00]. Aufgrund des hohen kovalenten Bindungsanteils von Siliciumnitrid ist die Selbstdiffusion zu langsam, um über sie mit vertretbarem Aufwand (Sinterzeiten kleiner 10 Stunden) technische Keramiken herzustellen. Frühere Versuche aus α-Si₃N₄ Kristallen, durch Glühen bei 1800 °C, β -Si₃N₄ Kristalle herzustellen schlugen fehl [Tho-67].

2.1.1 Sintern

In den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden erste poröse Siliciumnitrid Keramiken über reaktionsgebundenes Silizium hergestellt, wofür Teile aus gepresstem Siliziumpulver nitriert wurden [Col-55]. Erst bei Verwendung von Sinterhilfsmitteln, meistens Metalloxide oder Oxide der seltenen Erdmetalle, die beim Sintern mit dem Sauerstoff an den Siliciumnitridpartikeln eine Schmelze bilden, ist eine komplette Verdichtung von Siliciumnitrid möglich. Erste dichte Siliciumnitrid- Keramiken konnten 1961 mit Hilfe von MgO als Sinterhilfsmittel und einer Heißpresse erzeugt werden [Dee-61].

Das Modell des Flüssigphasensinterns wurde als erstes von Kingery [Kin-58a], [Kin-58b] erarbeitet und später von Messier et al. [Mes-78] und Hampshire et al. [Ham-81] erfolgreich auf Siliciumnitridkeramiken übertragen. Der Großteil der technischen Si₃N₄- Keramiken werden aus α - reichen Si₃N₄- Pulvermischung hergestellt. Es lassen sich drei Stadien beim Flüssigphasensintern von Pulvermischungen unterscheiden.

Während des **ersten** Stadiums erfolgt das Umlagern von Partikeln durch Kapillarkräfte. Dies geschieht, sobald beim Aufheizen die erste Flüssigphase (oxidische Schmelze) gebildet wird. Diese Umlagerung zu einer höheren Packungsdichte ist abhängig von der Menge und der Viskosität der Flüssigphase.

Im **zweiten** Stadium finden Lösungs- und Wiederausscheidungsvorgänge statt, wobei sich die metastabile α - Modifikation in der Schmelze bis zur Sättigungsgrenze auflöst und sich anschließend in der stabilen β -Modifikation an bestehenden β -Si₃N₄ Keimen wieder ausscheidet. Im Ausgangspulver ist ein geringer Prozentsatz (~5-10 vol%) von β - Keimen enthalten. Mikrostrukturuntersuchungen ergaben, dass nicht alle β -Si₃N₄ Keime wachsen [Krä-93]. Ob ein β -Si₃N₄ Keim während des Sinterns wachsen kann, hängt vom kritischen Partikeldurchmesser, d_{krit}, ab (Abbildung 2-1). Partikel mit einem kleineren Durchmesser als d_{krit} lösen sich auf, wobei die Größeren wachsen.



Abbildung 2-1: Schematische Darstellung der Häufigkeitsverteilung von β-Si₃N₄ Keimdurchmessern [Pet-02]

Während des zweiten Sinterstadiums ist, durch das Auflösen des α -Siliciumnitrids, aus der Oxidschmelze eine oxinitridische Schmelze entstanden. Im Allgemeinen kann der Verdichtungsverlauf mit folgender Gleichung 2-1 [Ham-81] beschrieben werden. V₀ entspricht dem Anfangsvolumen, ΔV der Volumenänderungsrate und t der Zeit.

$$\frac{\Delta V}{V_0} \propto t^{\frac{1}{n}}$$
 2-1

In frühen Arbeiten zur Geschwindigkeit der Phasenumwandlung in Siliciumnitrid, wurden zwei Abläufe heraus gearbeitet: Erstens die Geschwindigkeit des Lösens und Wiederausscheidens (grenzflächenkontrolliert) mit einem Exponent n~3 (MgO als Additiv), und zweitens die Diffusionsgeschwindigkeit (diffusionskontrolliert) der Silizium- und Stickstoffatome in der Flüssigphase mit einem Exponent n~5 (Y₂O₃ als Additiv) [Ham-07]. Das grenzflächenkontrollierte Kornwachstum kann weiter in die Reaktionen an der Grenzfläche von α - Si₃N₄ Korn und Flüssigphase und die Reaktionen an der Grenzfläche von Flüssigphase und β -Si₃N₄ Korn zerlegt werden [Krä-93].

Das dritte Stadium ist die Ostwaldreifung, in welcher Kornwachstum stattfindet. Neuere Untersuchungen von Lehner et al. [Leh-06] zur α / β Umwandlung von Siliciumnitrid durch Variation der Sinterparameter zeigen, dass die Umwandlung durch einen Anstieg des Stickstoffgehalts in der Flüssigphase beschleunigt wird. Weitere Untersuchungen zur α / β Umwandlung an hochreinen α - Si₃N₄ Einkristallen (0,2 gew.% bestätigen, dass Flüssigphase O) die der Schlüsselfaktor zur Umwandlung ist. Bei Glühexperimenten zur Umwandlung Sinteradditive, bei Temperaturen bis 2200°C und ohne zu einem Stickstoffgasdruck von 70MPa, konnte keine Umwandlung nachgewiesen werden. Die sehr dünne SiO₂- Schicht auf den α- Si₃N₄ Einkristallen stellt, laut den Autoren Suematsu et al. [Sue-97], nicht genügend Flüssigphase zur Umwandlung bereit. Erst bei Verwendung von Sinteradditiven konnte eine Umwandlung erreicht werden.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wird Si₃N₄ ausschließlich unter Verwendung einer Stickstoffatmosphäre gesintert, da sich Si₃N₄ bei den zur Sinterung notwendigen Temperaturen in Si und N zersetzt. Um die Zersetzung zu verhindern, muss bei 1880 °C mindestens ein Stickstoffgasdruck von 1 bar herrschen [Ril-00].

$$Si_3N_4(s) = 3Si(g,l) + 2N_2(g)$$
 2-2

Neueste Ergebnisse von Plucknett et al. [Plu-05] und Wada et al. [Wad-01],[Wad-04] zeigen jedoch, dass bei Einhaltung folgender Kriterien Proben mit bis zu 98%tD unter Laboratmosphäre gesintert werden können: Verwendung eines Pulverbettes, 12 Gewichtsprozent Yttriumoxid und 8 Gewichtsprozent Aluminiumoxid als Sinteradditive und einer Anordnung der Proben in einem offenen Aluminiumoxidtiegel. Die Proben wurden in einem Molybdänofen bei 1750 °C gesintert.

Nach dem Abkühlen bildet die Flüssigphase eine Sekundärphase, welche meistens zu einem oxinitridischen Glas erstarrt. Man unterteilt hierbei die Sekundärphase in zwei Bereiche. Einerseits in die Korngrenzfilme, d.h. dünne Filme (wenige nm) von Glasphase zwischen zwei dicht beieinander liegenden Körnern, und andererseits in Tripelpunkte, d.h. Bereiche an denen sich mehrere Körner treffen und eine Art Tasche für die Sekundärphase bilden. Die Dicke des Korngrenzfilmes variiert zwischen 0,5 nm und 1,5 nm [Kle-93]. Bisherige Untersuchungen gehen davon aus, dass die Dicke des Korngrenzfilms alleinig von der Zusammensetzung und nicht von der Quantität der Glasphase bestimmt wird [Wan-96],[Ste-98]. Ergebnisse an Yttriumoxid dotiertem Si₃N₄ von Döblinger et al. [Döb-06], zeigen jedoch, dass bei Verwendung von sehr geringen Mengen an Sekundärphase, dies nicht mehr gültig ist.

Die Zusammensetzung und Menge des oxynitridischen Glases beeinflusst nicht nur das Sinterverhalten und die sich entwickelnde Mikrostruktur, sondern auch das mechanische Verhalten der Keramik. Durch einen Anstieg des Stickstoffgehalts im oxinitridischen Glas, erhöhen sich dessen physikalischen Eigenschaften, wie die Glasübergangstemperatur, der E- Modul, die Viskosität, die Härte aber auch der Widerstand gegen das unterkritische Risswachstum [Lof-04]. Im Gegensatz dazu sinkt der thermische Ausdehnungskoeffizient bei einer Erhöhung des Stickstoffgehaltes, was auf einen Anstieg der Verknüpfungen der Stickstoffatome im Glas zurückzuführen ist [Ham-08]. Tripelpunkte sind die einzigen Bereiche an Sekundärphase, die je nach Zusammensetzung und Wärmebehandlung teilweise kristallisieren können. Diese kristallinen Bereiche sind jedoch immer von einem amorphen Film umgeben [Hof-95].

6

Die partielle Kristallisation der Glasphase wurde als eine Möglichkeit zur Verbesserung der Hochtemperatureigenschaften von Siliciumnitrid untersucht. Eine Verbesserung konnte jedoch nicht immer festgestellt werden [Hof-99]. Zurückzuführen ist dieses Verhalten auf die in der Sekundärphase enthaltenen Verunreinigungen, die sich in Abhängigkeit der sich bildenden kristallinen Sekundärphasen in den Korngrenzfilmen anreichern oder verarmen können. Eine Anreicherung in den Korngrenzfilmen ist dann zu erwarten, wenn die Verunreinigungen keine Löslichkeit in der kristallinen Sekundärphase zeigen. Dies führt dann in der Regel zu einer Verschlechterung der Hochtemperatureigenschaften[Hof-95a].

2.1.2 Kornwachstum

Das anisotrope Kornwachstum der β- Si₃N₄ Körner in der c- Achse [001], welches zu einem stängelförmigen Habitus der Körner führt, ist ein maßgebender Faktor für die guten mechanischen Eigenschaften von Siliciumnitridkeramiken. Die Anisotropie lässt sich auf unterschiedliche Kornwachstumsgeschwindigkeiten der Körner auf den Prismenflächen (parallel zur c-Achse [100]) und den Basalflächen (senkrecht zur c-Achse [001]) zurückführen. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist auf den glatten Prismenflächen grenzflächenkontrolliert, dadurch ist sie langsamer als die auf den rauheren Basalflächen, welche diffusionskontrolliert ist. Satet [Sat-04] zeigte an oxinitridischen Gläsern, dass über die Größe des seltenen Erdions die Wachstumsgeschwindigkeit und somit der Streckungsgrad der Körner beeinflusst werden kann. Je größer der Ionenradius, desto größer der Streckungsgrad. Der Zusammenhang von Wachstumsgeschwindigkeit zu Ionenradius des verwendeten seltenen Erdions ist in Abbildung 2-2a dargestellt.



Abbildung 2-2: a) Einfluss des Ionenradius auf den Streckungsgrad [Sat-04] und b) unterschiedliche Adsorptionsneigung für La- und Lu- Ionen auf Basal und Prismenflächen [Win-05]

Die Sekundärphase unterscheidet sich in ihrer Zusammensetzung zwischen den Korngrenzfilmen und den Tripelpunkten. Verschiedene Autoren [Shi-05], [Dwy-06], [Win-05] konnten mit Rastertransmissionsaufnahmen an Siliciumnitridkeramiken mit unterschiedlichen seltenen Erdionen als Sinterhilfsmitteln zeigen, dass sich in Abhängigkeit von der Ionengröße des seltenen Erdions, unterschiedliche Adsorptionsneigungen zu den Prismenflächen der β -Si₃N₄ Körnern ergeben. Die Abhängigkeit der Absorbtionsneigung der seltenen Erdionen (Lutetium und Lanthan) an den Prismenflächen ist in Abbildung 2-2b anhand von Rastertransmissions-aufnahmen gezeigt.

Das unterschiedliche Adsorptionsverhalten konnte mit First-principal Berechnungen belegt werden [Pai-04]. Das Adsorptionsverhalten beeinflusst das Kornwachstum, in dem es die Diffusion von Si und N zum Korn hin behindert. Lanthan zeigt eine deutlich größere Adsorptionsneigung, als das vergleichsweise kleinere Lutetiumion, was beim Lanthan zu einer langsameren Diffusion der Si und N Atome zur Prismenfläche führt. Um dieses Verhalten näher beschreiben zu können, wurde die "Differential Binding Energy" (DBE) Methode entwickelt, mit dem Ziel den Einfluss der Änderung der Zusammensetzung auf das Adsorptionsverhalten des seltenen Erdions bestimmen zu können. Ist beispielsweise der DBE Wert eines gegebenen Kations negativ, so ist es für das Kation energetisch günstiger an der stickstoffreichen Kornoberfläche zu bleiben, als für das Siliziumatom. Satet et al. und Becher et al. konnte dies an Experimenten mit oxinitridischen Gläsern, bestehend aus MgO und SE₂O₃ (SE = seltenes Erdoxid, SE = Sc, Lu, Yb, Y, Sm, La) belegen [Sat-04], [Bec-08].

Des Weiteren zeigte Becher kürzlich, dass bei Verwendung von seltenen Erdoxiden und Magnesiumoxid, als Sinterhilfsmittel bei Si₃N₄ Keramiken, das α/β Umwandlungsverhalten zu höheren Temperaturen, von Lu über Gd zu La, hin verschoben wird. Ebenfalls erhöht sich mit steigendem Ionenradius die Abscheidungs- und Adsorptionsneigung an den Si₃N₄ Körnern [Bec-08]. Arbeiten von Kitayama et al. [Kit-06] zum α/β Umwandlungsverhalten von dichtem, heißgepresstem Siliciumnitrid mit RE₂O₃ Additiven (RE = La, Nd, Gd, Yb) zeigen bis auf das Yb eine lineare Abhängigkeit über die gesamte Glühdauer. Das nicht lineare Verhalten des Yb erklärt der Autor über eine diffusions- und grenzflächenkontrollierte Umwandlung, wohingegen La, Nd und Gd reines grenzflächenkontrolliertes Verhalten aufweisen. Die ermittelten Aktivierungsenergien, bei Annahme von linearem Verhalten, sind wie folgt: La (677 kJ/mol), Nd (546 kJ/mol), Gd (487 kJ/mol) und für Yb (424 kJ/mol). Dies zeigt einen guten Zusammenhang zwischen Aktivierungsenergien und den Ionenradien der seltenen Erdatomen.

2.1.3 Grenzflächenfestigkeit

Das Adsorptionsverhalten beeinflusst über das Bindungsverhalten von Korn zur Glasphase auch die mechanischen Eigenschaften der Keramik. Schwächere Korngrenzfestigkeiten bewirken, über eine vermehrte Aktivierung von Steigerung Verstärkungsmechanismen, Bruchzähigkeit eine der bei Rissverlängerung von Si₃N₄ Keramiken [Sat-05]. Der Riss kann dabei entlang der Grenzfläche Korn/ Korngrenzfilm oder im Korngrenzfilm wachsen. Eine Schwächung der Korngrenzflächenfestigkeit kann bei Verwendung von Al₂O₃ und Y₂O₃ als Sinteradditive erfolgen, in dem das Verhältnis von Al/O reduziert wird. Weiterhin konnte Becher [Bec-05] zeigen, dass eine Steigerung des Y-Gehalts ebenfalls eine Schwächung der Korngrenzflächenfestigkeit bewirkt.

Untersuchungen zur Korngrenzflächenfestigkeit führt Becher an oxinitridischen Gläsern mit eingelagerten β - Körnern durch. Mit Hilfe eines Eindringkörpers (Vickers Indenter) wurden Risse in der Nähe der Körner erzeugt und anschließend die Ablöselänge I_{db} (Debonding) zwischen Korn und Glasphase, sowie der Winkel Θ des eintreffenden Risses zum Korn vermessen. Der schematische Zusammenhang ist in Abbildung 2-3a dargestellt. In Abbildung 2-3b ist das Ergebnis für ein oxinitridisches Glas mit einem niedrigen Verhältnis von Al/Y abgebildet.



Abbildung 2-3: a) Schematische Darstellung des Zusammenhangs Θ und I_{db} , b) Messergebnisse für verschiedene YAI- dotierte oxinitridische Gläser [Bec-96].

Ab einem kritischen Ablenkwinkel Θ_{krit} wird der Riss nicht mehr am Korn abgelenkt, sondern schneidet das Korn. Ablöselänge und kritischer Ablenkwinkel sind mit der Ablöseenergie verknüpft. Je größer Θ_{krit} , desto mehr Körner werden als Verstärkungselemente (Reibbrücken, Pull- Out) aktiviert und je größer I_{db} , desto höher ist die Reibung zwischen Korn und Glasphase [Bec-96], [Sun-99].

Über das anisotrope Kornwachstum der β- Si₃N₄ Körner lässt sich eine bimodale Mikrostruktur über die Wahl der Sinterparameter und Keramikzusammensetzung einstellen. Diese besteht aus fein verteilten stängelförmigen Si₃N₄- Körnern mit hohem Streckungsgrad, in einer feinkörnigen Matrix aus uniaxialen Si₃N₄-Körnern. Bei derartigen Mikrostrukturen können intakte, stängelförmige Körner die Rissflanken eines Risses zusammenhalten und somit die Risspitze vor weiterer Belastung schützen. Ausführliche Untersuchungen zum Einfluss der Korngröße, der Kornmorphologie und des Streckungsgrads auf das mechanische Verhalten von Siliciumnitrid führte Becher in den späten 90igern durch [Bec-98], [Sun-98]. Belmonte untersuchte ebenfalls das Kornwachstum in Siliciumnitrid, mit Al₂O₃ und Y₂O₃ als Sinteradditive und unter Zugabe von β -Keimen im Ausgangspulver. Bei Zusammensetzungen ohne Zugabe von β -Keimen steigerte eine Erhöhung des Al₂O₃- Gehalts das Kornwachstum, was jedoch bei Zusammensetzungen mit β - Keimen nicht nachgewiesen werden konnte. Belmonte schließt daraus, dass sich das Kornwachstum bei der Zugabe von β -Keimen von diffusionskontrolliert zu grenzflächenkontrolliert verschiebt [Bel-08]. Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse von Belmonte et al. [Bel-08] wird eher das Verhältnis der Geschwindigkeiten der Basalflächen und Prismenflächen der Siliciumnitridkristalle geändert, als wie von ihm angegeben der komplette Mechanismus.

2.2 Bruchmechanik

Die Bruchmechanik geht bei ihrer Betrachtung von ebenen Defekten mit scharfer Spitze aus. Diese Defekte werden Risse genannt, wobei natürliche Defekte (Poren, Poren mit Saumriss, Einschlüsse, Ansammlung von Korngrenzphase) auch ein kleines Volumen aufweisen können.

Das Risswachstum in Keramiken kann von zwei Seiten aus betrachtet werden: einerseits aus der Sicht der Energiefreisetzung und andererseits mit Hilfe des Spannungsintensitätsfaktors. Des Weiteren kann man drei Arten von Risswachstum unterscheiden: (i) instabile oder katastrophale Rissausbreitung, (ii) unterkritisches Risswachstum und (iii) stabiles Risswachstum [Mun-07]. Die Einführung in die Bruchmechanik ist, wenn nicht durch andere Zitate angegeben, aus dem Buch Ceramics von Munz und Fett [Mun-99] übernommen.

Ein Riss wächst, wenn die vorhandene Energie für Risswachstum größer ist, als die Energie die zur Erzeugung der neuen Oberflächen nötig ist. Griffith [Gri-20] und Irwin [Irw-56] waren die ersten, die das Kriterium für die Energiefreisetzung bei Risswachstum beschrieben. Die Energie für Risswachstum besteht aus zwei Teilen. Erstens aus der Arbeit, die von einer äußeren Kraft A verrichtet wird, und zweitens aus der im Bauteil gespeicherten elastischen inneren Energie U. Dabei ist die Energiefreisetzung definiert als die Energie, die bei einer virtuellen Vergrößerung eines Risses um eine Flächeneinheit, dS, frei wird. Dieser Zusammenhang wird mit Formel 2-3 ausgedrückt.

$$G_I = \frac{dA}{dS} - \frac{dU}{dS}$$
 2-3

Erreicht die Energiefreisetzung einen vom Material abhängigen Wert G_I, welcher sich aus der spezifischen Oberflächenenergie γ der beiden Rissflächen zusammensetzt, kommt es zu Rissfortschritt.

$$G_{IC} = 2\gamma$$
 2-4

Der Spannungsintensitätsfaktor K beschreibt die singuläre Spannung vor der Rissspitze. Er wird aus der charakteristischen Spannung σ , der Risslänge a und einem Geometriefaktor Y beschrieben. In diesem Fall gibt die charakteristische Spannung σ , die Spannung im nicht rissbehafteten Bauteil, wie beispielsweise die Zugspannung auf der Zugseite im Biegeversuche, wieder. Die Formel zur Berechnung des Spannungsintensitätsfaktors ist in 2-5 gegeben.

$$K_{I} = \sigma \sqrt{a} Y(\frac{a}{W})$$
 2-5

Erreicht der Spannungsintensitätsfaktor einen kritischen Wert, kommt es wie bei der Energiebetrachtung zu einem instabilen Risswachstum. Dieser kritische Spannungsintensitätsfaktor, K_c, wird als Bruchzähigkeit bezeichnet. Folgende Formel 2-6 zeigt die Verknüpfung des Spannungsintensitätsfaktors, K, und der Energiefreisetzungsrate, G, mit dem Elastizitätsmodul E.

$$K_I^2 = G_I E'$$
 2-6

E' ist wie folgt definiert:

$$E' = \begin{cases} E & Ebener Spannungszus \tan d \\ E/(1-v^2) Ebener Dehnungszus \tan d \end{cases}$$
 2-7

Im Fall des ebenen Dehnungszustands ist v die Querkontraktionszahl. Durch einsetzen der Gleichungen 2-4 und 2-7 in Gleichung 2-6 ergibt sich für den kritischen Spannungsintensitätsfaktor folgende Gleichung (2-8):

$$K_{lc}^{2} = \frac{G_{lc}E}{1-v^{2}} = \frac{2\gamma E}{1-v^{2}}$$
2-8

Die Beanspruchung der Rissspitze kann in 3 Belastungsmodi unterschieden werden:

- 1. Mode I: Zugbeanspruchung senkrecht zur Rissebene
- 2. Mode II: Scherbeanspruchung in Risswachstumsrichtung
- 3. Mode III: Schubbeanspruchung in der Rissebene

Für die Bruchmechanik ist der Mode I in den meisten Fällen ausschlaggebend, da Zugspannungen die kritischste Belastung darstellen.

Einige Materialien, so auch Siliciumnitridkeramiken, weisen keinen konstanten kritischen Spannungsintensitätsfaktor auf, sondern einen, der mit der Rissverlängerung ansteigt. Die Bruchzähigkeit kann damit nicht mehr mit einem einzigen Bruchzähigkeitswert angegeben werden, sondern es wird eine graphische Darstellung, in welcher die K_R- Werte (Risswiderstand) über der Rissverlängerung aufgetragen sind, verwendet. Die graphische Darstellung ist als Risswiderstandskurve (R-Kurve) bekannt. Zur instabilen Rissausbreitung kommt es, wenn die Steigung der Beanspruchung G_I oder K_I, der K_R- Δa Kurve der Funktionswert identisch wird entspricht und ist. Dies als Tangentenbedingung bezeichnet und ist in Gleichung 2-9 dargestellt.

$$K_{I,appl} = K_{I,R}$$

$$\frac{\partial K_{I,appl}}{\partial a} = \frac{\partial K_{I,R}}{\partial a}$$
2-9

Die Bruchzähigkeit ist im Allgemeinen kein Materialkennwert, sondern ist von der Art der Belastung und der Länge des Ausgangsrisses abhängig.

Die Verstärkungsmechanismen, die die R- Kurve bei Keramiken hervorruft, basiert im Allgemeinen auf drei Effekten:

 Rissflankeneffekte: Diese beruhen auf einer Abschirmung der Rissspitze vom anliegenden Spannungsintensitätsfaktor durch "elastische Brücken", "Reibungsbrücken" und durch "mechanische Verhakungen" der Rissflanken.

- Phasenumwandlung: Das Spannungsfeld eines Risses erzeugt in einigen Keramiken (z.B. Zirconia) eine Phasenumwandlung, welche mit einer Volumenzunahme der umwandelnden Phase verbunden ist. Die, durch die Volumenzunahme erzeugten Druckspannungen schirmen die Rissspitze von der anliegenden Belastung ab.
- Mikrorissbildung und Rissverzweigung: Durch Bildung von Mikrorissen oder durch Rissverzweigungen wird der effektive E- Modul der Keramik im Bereich von der Rissspitze herabgesetzt und somit auch der Spannungsintensitätsfaktor an der Rissspitze.

Bei Siliciumnitrid Keramiken wirken vorwiegend die Verstärkungseffekte 1 und 3, wobei Effekt 1 den Hauptanteil zum R- Kurvenverhalten beiträgt. Rödel [Röd-92] und Swanson et al. [Swa-87] konnten an verschiedenen Keramiken die unterschiedlichen Rissflankeneffekte mit dem Rasterelektronenmikroskop, sowie mit einem optischen Mikroskop nachweisen.

Die Verstärkungsmechanismen, vorwiegend die Effekte 1 und 3, führen dazu, dass die am Bauteil anliegenden Spannungen auch über den Riss übertragen werden können. Diese Spannungen werden als Brückenspannungen bezeichnet und schirmen die Rissspitze von der anliegenden Belastung ab. Dies führt zu einer Herabsetzung des an der Rissspitze anliegenden Spannungsintensitätsfaktors, K_{tip}.

$$K_{I,tip} = K_{I,appl} + K_{I,br}; \quad K_{I,br} < 0$$
 2-10

In Formel 2-10 ist $K_{l,tip}$ der Spannungsintensitätsfaktor an der Rissspitze und $K_{l,appl}$ der anliegende Spannungsintensitätsfaktor, der den Riss öffnende K-Faktor. Der Brückenspannungsintensitätsfaktor, $K_{l,br}$, leitet sich von den Brückenspannungen ab. Stabiles oder instabiles Risswachstum tritt auf, wenn K_{tip} gleich der Rissspitzenzähigkeit, K_0 , ist. Ob stabiles oder instabiles Risswachstum eintritt hängt von der Tangentenbedingung ab. Die Rissspitzenzähigkeit ist der Anfangswert der R-Kurve und eine vom Material abhängige Kenngröße. Sie kann über Messung der Rissöffnungsverschiebung, Crack Opening Displacement (COD), bestimmt werden [Fet-96],[Kru-03],[Fet-

05a]. Dabei können die einzelnen Spannungsintensitätsfaktoren in Gleichung 2-10 wie folgt dargestellt werden:

$$K_{I,appl} = \int_{0}^{a} h(x,a)\sigma_{appl}(x)dx$$
 2-11

$$K_{I,br} = \int_{0}^{a} h(x,a)\sigma_{br}(x)dx$$
 2-12

Die Spannungsintensitätsfaktoren berechnen sich aus den jeweiligen Spannungen und einer Gewichtsfunktion h(x,a). σ_{br} entspricht den Spannungen, die durch die Verstärkungsmechanismen übertragen werden können und σ_{appl} den Spannungen im ungerissenen Bereich des Bauteils, zum Beispiel die Zugspannung in der Randfaser bei einem Biegeversuch. Die Gewichtsfunktion ist eine Funktion der Risslänge, a, und der Koordinate, x (Abbildung 2-4). Die Gewichtsfunktion wird nur von der Geometrie der Probe und nicht von der anliegenden Belastung beeinflusst. Die Grundform der Gewichtsfunktion ist in Formel 2-13 gezeigt.

$$h(x,a) = \frac{E'}{K_I} \frac{\partial \delta(x,a)}{\partial a}$$
2-13
$$a \longrightarrow b$$



Die Brückenspannungen hängen direkt mit dem Rissöffnungsprofil, δ , und der anliegenden Spannung, σ_{appl} , zusammen. Diese Abhängigkeit ist in Gleichung 2-14 zu sehen.

$$\delta(x) = \frac{1}{E'} \int_{x}^{a} h(x,a') \left[\int_{0}^{a'} h(x',a') \left[\sigma_{appl}(x') + \sigma_{br}(\delta(x')) \right] dx' \right] da'$$
 2-14

Durch die Anwendung einer bekannten σ_{br} - δ - Beziehung kann Gleichung 2-14 nach σ_{br} aufgelöst werden [Fet-93]. Die σ_{br} - δ - Beziehung kann durch Experimente, durch Mikrostrukturmodelle oder durch Annahmen hergeleitet werden und wird als Brückenspannungsgesetz bezeichnet. Die nachfolgende Tabelle zeigt einige in der Literatur verwendete Brückenspannungsgesetze.

[Bal-84]	$\boldsymbol{\sigma}_{Br} = \boldsymbol{\sigma}_0 \left(1 - \frac{\boldsymbol{\delta}}{\boldsymbol{\delta}_0}\right)^m$	2-15
[Fet-93]	$\sigma_{Br} = \sigma_0 \exp\left(-\frac{\delta}{\delta_0}\right)$	2-16
[Fet-95b]	$\sigma_{\scriptscriptstyle Br} = \sigma_{\scriptscriptstyle 0} {\delta \over \delta_{\scriptscriptstyle 0}}$	2-17
[Fet-95b]	$\sigma_{Br} = \sigma_0 \frac{\delta}{\delta_0} \left(1 + \frac{\delta}{\delta_0} \right) \exp \left(- \frac{\delta}{\delta_0} \right)$	2-18
[Fet-00]	$\sigma_{Br} = \sigma_0 \exp\left(-\frac{\delta}{\delta_0}\right) \tanh\left(\frac{\lambda \delta}{\delta_0}\right)$	2-19

Tabelle 2-1: Verschiedene Brückenspannungsgesetze

Das Brückenspannungsgesetz nach Ballarini et al. [Bal-84] wurde mit einem Exponent m=2 für faserverstärkten Mörtel und m=1 für Beton hergeleitet. Durch das Einbeziehen einer angenommen Korngrößenverteilung und dem Exponenten m=1 konnte Fett et al. [Fet-93] das Brückenspannungsgesetz von Ballarini verfeinern (Gleichung 2-16).

Für elastische Brücken entwickelten Fett et al. [Fet-95b] das Gesetz 2-17 und erweiterte dieses mit einer angenommenen Korngrößenverteilung zur Gleichung 2-18.

Fett et al. [Fet-00] leitete für zwei Aluminiumoxid Keramiken das oben erwähnte Brückenspannungsgesetz 2-19 ab, in dem er die Brückenspannungsverteilung mit Hilfe von R- Kurvenmessungen an DCB- Proben (Double Cantilever Beam) und PFT- Proben (Post Fracture Test) bestimmte.

Eine Möglichkeit, einen experimentellen Zusammenhang zwischen σ_{br} - δ herzuleiten ist die Raman Spektroskopie [Pez-99], [Pez-01], [Kru-05], welche mit Hilfe eines Lasers das Material in der Nähe des Risses "abrastert" und das

reflektierte Licht in einem Spektrometer auffängt. Aus der Abweichung, des für Siliciumnitrid relevanten 862cm⁻¹ Peaks können die Brückenspannungen berechnet werden. Unter Verwendung der gemessenen Rissöffnung lässt sich nun das Brückenspannungsgesetz berechnen.

Bei Materialien mit lang ansteigender R- Kurve kann das Brückenspannungsgesetz durch das Messen der Complianceänderung während des sukzessiven Heraustrennens der Brücken [Wit-91], [Kru-05] bestimmt werden. Eine weitere Möglichkeit ist das Messen des Rissöffnungsprofils [Fet-02], [Fet-05], wofür die am Riss anliegende Spannung bekannt sein muss.

Verstärkungsmechanismen, wie Rissflankeneffekte, die die beiden Rissflanken zusammenhalten, sind nur solange wirksam und schützen die Rissspitze, wie das Rissöffnungsprofil einen vom Material und Belastung abhängigen Wert nicht überschreitet. Überschreitet das Rissöffnungsprofil diesen Wert, können die Verstärkungsmechanismen keine Spannungen mehr übertragen, da die Rissflanken nicht mehr in Kontakt stehen.

Die meisten Keramiken zeigen einen Anstieg der R- Kurve zu einem Plateauwert, bei welchem die Geschwindigkeit der Bildung gleich der Auflösung der Verstärkungsmechanismen ist. Die Länge dieses Anstiegs zum Plateauwert hängt von der Art der Beanspruchung, der Probengeometrie, der Rissgeometrie und vom Gefüge der Keramik ab. Dies konnte Steinbrech [Ste-90] an Aluminiumoxidkeramiken mit Korndurchmessern von 4 μ m bis 16 μ m zeigen. Die Keramik mit 16 μ m Korndurchmesser benötigt im Vergleich zu der Keramik mit 4 μ m eine deutlich größere Rissverlängerung zum Erreichen des Plateauwerts. Die grobkörnige Keramik weist zusätzlich einen höheren Plateauwert auf. Den Einfluss der Mikrostruktur auf das R- Kurvenverhalten untersuchten ebenfalls Becher et al. an Siliciumnitrid Keramiken mit gleichen Zusammensetzungen (Al₂O₃, Y₂O₃), aber unterschiedlich eingestellter Mikrostruktur [Bec-98].

Wie die oberen Erläuterungen verdeutlicht haben, ist die Bruchzähigkeit, sowie die R- Kurve keine Materialkonstante, sondern sie hängen von der Art der Beanspruchung und der Anfangsrisslänge ab [Ste-90],[Fet-93]. Steinbrech et al. konnte 1988 an Al₂O₃- Proben unterschiedliche R- Kurven für natürliche Risse in Biegeproben und für SEPB- Proben aufzeigen [Ste-88]. Abbildung 2-5a zeigt von

Fett und Munz [Fet-92a] überarbeitete Ergebnisse aus der Arbeit von Steinbrech et al. [Ste-88]. Die unterschiedlichen R- Kurven für natürliche Risse wurden auch von anderen Autoren nachgewiesen [Mar-88], [Yu-90]. Natürliche Risse sind meistens 2- dimensionale, ellipsenförmige Fehler, die durch die Probenherstellung oder –bearbeitung entstehen. Sie können bei Risswachstum in zwei Dimensionen wachsen. Makrorisse, absichtlich induzierte Risse (SEVNB, SEPB) sind 1- dimensionale Risse und können in den meisten Fällen nur in eine Dimension, der Probenhöhe, wachsen.

Des Weiteren ist nicht nur die Art der Anfangsrisse von Bedeutung, sondern auch deren Länge. Bei langen Anfangsrissen tangiert die Belastungskurve, K_{appl}, die R- Kurve bei größeren Rissverlängerungen (Abbildung 2-5b, rechte Kurve). Andererseits tangieren die Belastungskurven bei kurzen Anfangsrissen die R-Kurve im Bereich der Rissspitzenzähigkeit K₁₀. Die R- Kurve hat in diesem Fall keinen Einfluss auf das Materialverhalten.



Abbildung 2-5: a) unterschiedliche R- Kurven für natürliche und Makrorisse [Fet-92a], b) Einfluss der Anfangsrisslänge auf die Bruchzähigkeit [Mun-07]

Die einzige materialabhängige, bruchmechanische Kenngröße die auf unterschiedliche Rissgeometrien übertragbar ist, ist das zuvor genannte Brückenspannungsgesetz. Ist das Brückenspannungsgesetz für ein Material bestimmt, lassen sich daraus für verschiedene Risslängen und Rissformen (1dimensionale, 2- dimensionale) die jeweiligen R- Kurven bestimmen [Fet-96].

2.2.1 Einfluss der R- Kurve auf die Festigkeit

Die Festigkeit von Keramiken ist abhängig von der Verteilung und der Größe der natürlichen Fehler und, wie zuvor erklärt, auch vom R- Kurvenverhalten [Fet-95]. Natürliche Fehler treten in Siliciumnitridkeramiken in der Größenordnung von einigen Dutzend Mikrometer auf. Bei der Festigkeitsmessung tritt instabiles Risswachstum ein, sobald der anliegende Spannungsintensitätsfaktor, Kappl, die R- Kurve tangiert. Bei Materialien mit flachem oder keinem R- Kurvenverhalten tangiert Kappl die R- Kurve immer im Bereich von K₁₀, der Rissspitzenzähigkeit. Ist die R- Kurve jedoch hinreichend steil erhält man stabiles Risswachstum und die angelegte Spannung muss, um instabiles Risswachstum zu erhalten, weiter erhöht werden. Keramiken mit ausgeprägtem R- Kurvenverhalten zeigen dadurch eine geringere Streuung der Festigkeiten, der Weibullmodul m als Maß für die Streuung steigt an. Es konnte eine Erhöhung der Bruchfestigkeiten bei Keramiken mit ausgeprägter R- Kurve [She-89], [Usa-86] im Vergleich zu Keramiken mit vergleichbarer Rissspitzenzähigkeit und flacher R- Kurve gezeigt werden. Dies zeigte Munz [Mun-07], indem er den Einfluss der R- Kurve auf die Streuung der Festigkeitswerte, mit Hilfe der von Ramachandran [Ram-91] entwickelten Gleichung 2-20, darstellte. Die darin enthaltene Größe, λ , ist ein Normalisierungsfaktor für die Risslänge. Die gestrichelten Linien in Abbildung 2-6 stellen mit $K_{Ic} = K_{max} = 8 \text{ MPam}^{1/2} \text{ und } K_{Ic} = K_{I0} = 4 \text{ MPam}^{1/2} \text{ die Grenzen des}$ Streubereichs dar. Die gemessenen Festigkeitswerte liegen innerhalb dieser Grenzen.

$$K_{R} = K_{\text{max}} - (K_{\text{max}} - K_{0}) \exp\left[-\frac{\Delta a}{\lambda}\right]$$
 2-20



Abbildung 2-6: a) Berechnete Streuung der Festigkeiten unter Einfluss des R-Kurvenverhalten [Mun-07] unter Verwendung der Gleichung 2-20

Bei Keramiken ohne R- Kurvenverhalten gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Ausgangsfehlergröße und Bruchfestigkeit (Formel 2-5). Existiert jedoch eine hinreichend steile R- Kurve, so ergibt sich kein linearer Zusammenhang in einer log-log Darstellung zwischen den Ausgangsfehlergrößen und den Bruchfestigkeiten. Keramiken mit R- Kurven werden dadurch unempfindlicher gegenüber der Ausgangsfehlergröße [Li-95], [Kru-08]. Diese Abhängigkeit ist in Abbildung 2-7 dargestellt.



Abbildung 2-7: Bruchspannung vs. Ausgangsfehlergröße. a) 3 Si₃N₄ Keramiken mit unterschiedlichen Korngrößen [Li-95], b) 3 Si₃N₄ Keramiken mit unterschiedlichen Sinteradditiven [Kru-08]

Der Einfluss der R- Kurve auf die Festigkeit, vor allem der Anstieg der R- Kurve zum Plateauwert, wurde von Kruzic [Kru-08] an 2 Siliciumnitrid- Varianten (MgO-Lu₂O₃ und MgO-La₂O₃) mit gleicher äquivalenter Zusammensetzung und

Mikrostruktur untersucht. Er konnte eine gute Übereinstimmung zwischen Festigkeitsvorhersagen aus R- Kurvenmessungen an Compact Tension (CT) Proben und Inertfestigkeitsmessungen an Biegestäbchen aufzeigen. Die MgO-La₂O₃ Probe zeigte einen flacheren Anstieg der R- Kurve, als die MgO- Lu₂O₃ Variante (Abbildung 2-8a). Dadurch ergab sich bei gleicher angenommener Defektgröße, eine niedrigere Festigkeit, siehe dazu Abbildung 2-8b. Bei Bruchzähigkeitsbestimmungen (SEVNB) der gleichen Siliciumnitrid- Varianten zeigte die MgO- La₂O₃ Variante einen höheren K_{IC}- Wert als die MgO-Lu₂O₃ Variante [Sat-02]. Somit sind Bruchzähigkeitswerte nahe dem Plateauwert nicht zwingend ausschlaggebend für die Festigkeit, vielmehr ist es der erste Bereich der R- Kurve.



Abbildung 2-8: a) Einfluss des R- Kurvenverhalten auf die Festigkeit bei gleicher Fehlergrößenverteilung [Kru-08], b) Bruchzähigkeit und Festigkeit bei Si₃N₄ Keramiken mit unterschiedlichen Seltenen Erdionen als Sinteradditive [Sat-02]

2.2.2 Einfluss der R- Kurve auf das unterkritische Risswachstum / zyklisches Risswachstum

Bei der dynamischen Messung des R- Kurvenverhaltens erhält man Risswachstum, wenn K_{I,tip} gleich der Rissspitzenzähigkeit, K₁₀, ist. Bis zum Erreichen der Tangentenbedingung herrscht stabiles Risswachstum, ab dann instabiles. Es gibt jedoch noch eine weitere Art des Risswachstums, das unterkritische Risswachstum. Das unterkritische Risswachstum ist ein zeitabhängiges Phänomen und wird durch das Aufbrechen von Atombindungen durch Wassermoleküle verursacht. Die Rissverlängerung tritt hierbei auf, bevor K_{I,tip} K_{I0} erreicht. Das Risswachstum wird nur durch den Spannungsintensitätsfaktor und die Umgebung (Atmosphäre, Temperatur, usw.) bestimmt.

Das unterkritische Risswachstum unterteilt sich in drei Bereiche. Der erste Bereich, der bei niedrigen Rissgeschwindigkeiten und Spannungsintensitätsfaktoren auftritt, ist dominiert durch den starken Umgebungseinfluss. Im zweiten Bereich steigt die Rissgeschwindigkeit nur noch langsam bei Erhöhen des Spannungsintensitätsfaktors an und ist durch die Transportgeschwindigkeit des korrosiven Mediums zur Rissspitze bestimmt. Der dritte Bereich zeigt wieder eine sehr steile Zunahme der Rissgeschwindigkeit und ist unabhängig vom Umgebungseinfluss [Sal-07].

Nur der erste Bereich ist für Lebensdauervorhersagen relevant. In diesem linearen Bereich gilt folgende Beziehung zwischen der Rissgeschwindigkeit, v, und des Spannungsintensitätsfaktors, K:

$$v = \frac{da}{dt} f(K_I) = AK_I^n = A^* \left(\frac{K_I}{K_{Ic}}\right)^n$$
 2-21

A, A* und n sind von Material, Umgebung und Temperatur abhängige Parameter. Einige Materalien, z.B. Gläser, weisen einen K- Wert auf, unterhalb dessen kein unterkritisches Risswachstum festgestellt werden kann. Dieser Schwellwert wird mit K_{th} bezeichnet.

Das unterkritische Risswachstum wird auch als statisches Risswachstum oder statische Ermüdung bezeichnet. Während bei stabilem Risswachstum $K_{tip} = K_{I0} =$ konst. ist, ändert sich bei statischem Risswachstum K_{tip} in Abhängigkeit von K_{appl} und K_{br} . Bei Materialien mit R- Kurvenverhalten steigt K_{appl} mit der Rissverlängerung nach einer Wurzelfunktion (~a^{1/2}). K_{br} erhöht sich ebenfalls bis der Plateauwert der R- Kurve erreicht ist und bleibt dann konstant. Somit verringert sich der an der Rissspitze anliegende Spannungsintensitätsfaktor K_{tip} und steigt anschließend wieder an. Dabei ändert sich, gemäß Formel 2-21, auch die Risswachstumsgeschwindigkeit. Dies konnten Fett und Munz [Fet-92] an Aluminiumoxid mit Makrorissen mit unterschiedlichen Belastungen (Abbildung 2-9: Kurven 1- 7) zeigen. Aus den Daten konnten Fett und Munz den Brückenspannungsintensitätsfaktor, K_{br} , unter Verwendung von Formel 2-22 ableiten (siehe dazu Abbildung 2-9b).


Abbildung 2-9: a) Risswachstumsgeschwindigkeit bei unterkritischem Risswachstum an Proben mit Makrorissen und b) Bestimmung von K_{br} aus diesen Daten [Fet-92].

Zyklisches Risswachstum, oder auch zyklische Ermüdung genannt, tritt bei den meisten Keramiken auf und basiert auf den gleichen Mechanismen wie die statische Ermüdung. Das Ermüdungsverhalten bei zyklischer Beanspruchung wird jedoch durch die Degradation der Verstärkungsmechanismen verstärkt. Aus diesem Grund weisen nur Keramiken mit einem R- Kurvenverhalten eine echte zyklische Ermüdung auf. Dies zeigte Gilbert [Gil-95],[Gil-97] an einem Al₂O₃ und Y₂O₃ dotierten Siliciumnitrid. Dabei ist zu beachten, dass die beiden vorwiegend auftretenden Verstärkungsmechanismen, Reibungsbrücken und elastische Brücken, unterschiedliche Degradationsraten aufweisen. Reibungsbrücken bauen sich durch Verschleiß der Reibflächen schneller ab, als die elastischen Brücken. In diesem Zusammenhang ist auch das R- Verhältnis von Bedeutung. Je größer das R- Verhältnis, desto kleiner ist der Reibweg und somit auch der Verschleiß der Reibungsbrücken [Gil-95].

3 Experimentelle Durchführung

3.1 Keramikherstellung

3.1.1 Pulverherstellung

Alle Keramikzusammensetzungen wurden nach dem gleichen Schema hergestellt. Die Ausgangspulver Si₃N₄ (SN-10, UBE, Japan), MgO (500A, UBE-Japan), Y₂O₃ (Grad C, fine, HC Starck), Lu₂O₃ (Lutetiumoxid 99,99, Treibacher Industrie AG), La₂O₃ (Lanthanoxid 99,99, Treibacher Industrie AG) und SiO₂ (Aerosil X50, Degussa) wurden nach den in Tabelle 3-1 aufgezeigten Gewichtsangaben in einem Attritor gemahlen. Durch die großen Pulvermengen, die für die Probenherstellung benötigt wurden, konnte der standardisierte Attritorbecher mit einem Fassungsvolumen von 560cm³ nicht verwendet werden. Stattdessen wurde ein größerer Attritormahlbecher mit einem Fassungsvermögen von 2000cm³ benutzt. Die Mahlparameter wurden so angepasst, dass die Partikelverteilung des großen Attritors der des Kleinen entsprach. Die Pulvermenge von ca. 450g pro Charge wurde mit Si₃N₄- Mahlkugeln (\emptyset ~1-2mm) und Isopropanol für 5h bei 1000 min⁻¹ homogenisiert und deagglomeriert.

	Si ₃ N ₄	MgO	Y ₂ O ₃	La ₂ O ₃	Lu ₂ O ₃	SiO ₂	Al ₂ O ₃
MgY	93	2	5				
MgLa	90,98	1,96		7,06			
MgLu	89,58	1,93			8,49		
SiY	93,5		5			1,5	
AIY	~94		~3				~3

Tabelle 3-1: Keramikzusammensetzung in Masse-%

Der entstandene Schlicker wurde nach dem Attritieren von den Mahlperlen getrennt und in einem Rotationsverdampfer getrocknet. Um die Restfeuchte zu entfernen wurden die Pulver für 24h bei 60 °C in einem Vakuumschrank gelagert.

Der Sauerstoffeintrag jeder Zusammensetzung, der durch die Pulverherstellung in die Pulvermischung eingebracht wurde, konnte mit Hilfe eines Stickstoff-Sauerstoffanalysators (TC 500, Leco, USA) bestimmt werden. Die gemessenen Werte wurden anschließend mit berechneten Werten verglichen. Der Sauerstoffanteil des Si₃N₄, von 1,26 Masse-%, wurde bei der Berechnung mit berücksichtigt. Die berechneten Werte wurden mit Hilfe der Mischungsregel der einzelnen Ausgangspulver und den Sauerstoff- und Stickstoffangaben der Hersteller bestimmt.

Über diese Prozessroute wurden die Zusammensetzungen MgY, MgLa, MgLu und SiY hergestellt, wohingegen die Zusammensetzung AIY eine kommerzielle Variante mit der Bezeichnung SL200 BG der Firma CeramTec AG ist. Von dieser Zusammensetzung wurden am IKM lediglich die Grünkörper hergestellt, Pulverherstellung und Sinterung erfolgte bei CeramTec.

3.1.2 Grünkörperherstellung

Die Grünkörper der verschiedenen Pulverzusammensetzungen wurden zuerst in Metallmatrizen uniaxial mit 14 MPa gepresst und anschließend kaltisostatisch bei 400 MPa nachverdichtet. Für Untersuchungen zum Sinterverhalten der einzelnen Zusammensetzungen wurden Proben mit den Maßen 8x24x50 mm³ aus 18g Pulver hergestellt. Aus diesen Platten wurden nach Kühne [Küh-93] Dilatometerproben mit den Maßen 8x8x22 mm³ heraus gearbeitet. Außerdem wurden Biegestäbchen zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften benötigt. Dazu wurden Grünkörperplatten mit den Maßen 8x42x60 mm³ mit 35g Füllgewicht hergestellt. Aus diesen Platten wurden nach dem Sintern in einem Hartbearbeitungsschritt die Biegestäbchen Prinzip bestimmt und betrugen ungefähr 55 % der theoretisch bestimmten Dichte.

3.1.3 Sinterung

Die Untersuchungen zum Sinterverhalten der einzelnen Zusammensetzungen erfolgten mit einem für die Heißisostatpresse QIH-6 (HIP) der Firma ASEA entwickelten Dilatometer [Küh-93]. Das Dilatometer ermöglicht, über einen induktiven Wegaufnehmer, die Messung der Längenänderung der Probe während des Sinterversuchs. Die Probe befindet sich während des Versuchs in einem Bornitridtiegel, welcher durch eine Auflage verschlossen ist. Ein Ringspalt von ca. 1 mm zwischen Bornitridtiegel und Auflage verhindert, auch bei starker Whiskerbildung, das Festsetzen der Auflage. Die Auflage liegt auf der quadratischen Fläche (8x8 mm²) der Dilatometerprobe auf, wobei die Auflage über ein Graphitgestänge mit dem Wegaufnehmer verbunden ist. Über dieses Messsystem ist es möglich, das Schwindungsverhalten der Probe druck- und temperaturabhängig darzustellen. Als Prozessgas wurde hochreiner Stickstoff verwendet.

Unter Annahme einer isotropen Schwindung lässt sich aus der gemessenen Längenänderung, I_i , der Anfangsdichte, ρ_0 , und der Anfangslänge, I_0 , die aktuelle Dichte der Proben mit Hilfe der Gleichung 3-1 berechnen.

$$\rho_i = \frac{\rho_0}{\left(\frac{l_i}{l_0}\right)^3}$$
 3-1

Durch die zeitliche Ableitung der linearen Schrumpfung erhält man die Schrumpfungsrate (dl/dt), welche in die drei Phasen der Flüssigphasensinterung (siehe Kapitel 2.1) unterteilt werden kann.

Die Proben für die mechanische Charakterisierung wurden ebenfalls in der Heißisostatpresse QIH-6 verdichtet. Hierfür wurde jedoch der Diatometerofen durch den Originalofen ersetzt, der es ermöglichte größere Mengen an Proben gleichzeitig zu verdichten. Dadurch konnten bis zu 6 Biegeplatten in einem Bornitridtiegel im Ofen platziert werden. In Tabelle 3-2 sind die optimierten Sinterparameter aufgelistet. Bei allen Proben wurde der Ofen bis 300 ℃ unter Vakuum mit 10 K/min aufgeheizt. Bei Erreichen der 300 ℃ Marke wurde ein Stickstoffdruck von ca. 2,5 bar aufgebaut, welcher sich durch die thermische Ausdehnung beim Aufheizen zur Sintertemperatur auf ca. 8 bar erhöht hat. Die Zusammensetzungen MgY, MgLa, MgLu wurden bis 1200 ℃ mit 25 K/min aufgeheizt. Bei der Variante SiY betrug die Aufheizrate ebenfalls 25 K/min, jedoch bis zu einer Temperatur von 1400 ℃. Bis zur Sintertemperatur betrug die Heizrate auch hier 10 K/min.

	Temperatur/Haltezeit in der Sinterstufe [℃]/[min]	Temperatur/Haltezeit in der Druckstufe [℃]/[min]	Gasdruck in der Druckstufe [MPa]
MgY	1750/60	1800/30	20
MgLa	1780/14	1780/30	10
MgLu	1750/15	1750/30	10
SiY	1920/25	1920/30	10

Tabelle 3-2: Sinterparameter

Am Ende der Sinterung wurde die schnellstmögliche Abkühlgeschwindigkeit erreicht, indem der Ofen direkt nach der Haltezeit in der Druckstufe ausgeschaltet wurde.

3.2 Gefügecharakterisierung

3.2.1 Dichtebestimmung

Bei allen Proben wurde die Dichte nach dem Archimedes Prinzip bestimmt, einerseits um den Grad der Verdichtung bestimmen zu können und andererseits als Qualitätskontrolle für die Verwendung von bestehenden Sinterparametern.

Zur Berechnung der Dichte wurde von jeder Probe das Trocken- (m_{tr}), das Feucht- (m_{feu}) und das Auftriebsgewicht ($m_{Auftr.}$) in deionisiertem Wasser nach der Sinterung bestimmt. Unter Verwendung der temperaturabhängigen Dichte des Wassers (ρ_{Wasser}) konnte die Dichte der Probe nach folgender Formel berechnet werden:

$$\rho = \frac{m_{tr}}{m_{feu} - m_{Auftr.}} \rho_{Wasser}$$
 3-2

Mit Hilfe der Mischungsregel kann aus den einzelnen Dichten der Anfangspulver die theoretische Dichte ($\rho_{theo.}$) der Keramik berechnet werden. In der Literatur wird meistens der Quotient aus theoretischer und gemessener Dichte angegeben, und als relative Dichte (ρ_{rel}) bezeichnet.

$$\rho_{rel} = \frac{\rho}{\rho_{theo.}}$$
 3-3

3.2.2 Herstellung von keramographischen Schliffen

Zur Untersuchung der Mikrostrukturentwicklung wurden bei jeder Optimierung Sinterparameter keramische Schliffe hergestellt, der um daraus die Korngrößenverteilung und die Streckungsgradverteilung bestimmen zu können. Dazu wurden hauptsächlich aus den Dilatometerproben, aber auch aus den Biegeplatten, Proben mit einer kunstharzgebundenen Diamanttrennscheibe herausgetrennt und anschließend warm eingebettet (SimpliMet 1000, Buehler). Die eingebetteten Proben wurden zuerst mit metallgebundenen, anschließend mit kunststoffgebundenen Diamantscheiben poliert. Als letzter Polierschritt wurden die Proben mit einer 1µm Diamantsuspension maschinell (Saphir 350E, ATM) poliert. Für rasterelektronenmikroskopische (REM) Aufnahmen wurden die Proben in einer Plasmaätzanlage (PT 7150, Bio- Rad) mit einem Gasgemisch CF₄:O₂ (4:2) für 2min behandelt. Beim Plasmaätzen werden die β- Si₃N₄ Körner stärker als die Korngrenzphase angegriffen, wodurch ein Höhenrelief entsteht, welches mit dem Elektronenstrahl des REMs gut auflösbar ist. Um Aufladungseffekte ausschließen zu können, wurden die Si₃N₄- Keramiken für 60s mit Gold oder Platin besputtert.

3.2.3 Röntgenographische Analysen

Bei allen Dilatometerexperimenten, sowie bei ausgesuchten Biegeplatten, wurde eine Phasenanalyse über das Röntgenbeugungsverfahren (D500, Siemens) durchgeführt. Die Proben wurden im Winkelbereich von 15- 50 °20 in 0,02° Schritten, mit einer Verweilzeit von 10s pro Schritt untersucht. Die einzelnen Phasen wurden mit einer PC-PDF Kartei identifiziert. Zur Bestimmung der α / β -Umwandlung wurde der α - Phasenanteil in Prozent nach folgender Formel bestimmt:

$$\alpha = \frac{I_{\alpha(102)} + I_{\alpha(210)}}{I_{\alpha(102)} + I_{\alpha(210)} + I_{\beta(101)} + I_{\beta(210)}} \cdot 100[\%]$$
 3-4

3.2.4 Mikroskopie

Untersuchungen zur Mikrostrukturentwicklung wurden an polierten, geätzten und besputterten Proben in einem REM (Stereoscan 440s, Leica) durchgeführt. Zur Bestimmung der Korngrößen- und Streckungsgradverteilung wurden Aufnahmen bei verschiedenen Vergrößerungen (15kX, 20kX) erstellt. Die REM- Aufnahmen wurde durch Nachzeichnen der Körner binarisiert und mittels der Auswertungssoftware Image C (Aquinto, Deutschland) ausgewertet. Um eine statistische Absicherung zu erhalten wurden von jeder Zusammensetzung zwischen 2600 und 3300 Körner nachgezeichnet. Die Ausgabedatei von Image C enthält pro Korn den minimalen und maximalen Ferretschen Durchmesser. Die räumliche Rückrechnung der Parameter aus den Daten des ebenen erfolgte Anschliffs mit einer weiteren Software Stereologie (Aquinto, Deutschland), welche auf mathematischen Grundlagen von Mücklich et.al [Müc-94],[Müc-99] beruht.

3.3 Mechanische Kenngrößen

Die mechanischen Kenngrößen der einzelnen Siliciumnitrid- Varianten wurden ausschließlich an Proben aus Biegeplatten (6x35x50 mm³) durchgeführt. Die

gewünschten Probengeometrien wurden anschließend in einem Hartbearbeitungsschritt aus den Biegeplatten herausgetrennt.

3.3.1 Härte, 4- Punktbiegefestigkeit, Bruchzähigkeit

Die Bestimmung der **Vickershärte** (HV10) aller Varianten erfolgte anhand von polierten Proben nach DIN EN 843-4 [DIN-05] mit einer halbautomatischen Härteprüfeinheit (Akashi AVK-C1, Leco). Die verwendete Eindringkraft betrug 98,8N und die Eindringzeit 15s. Nach dem Entlasten konnten die Eindruckdiagonalen mit dem implementierten Lichtmikroskop, bei einer 40fachen Vergrößerung vermessen werden. Die Möglichkeit zur Bestimmung der Bruchzähigkeit über die Indentermethode liefert ungenaue und nicht reproduzierbare Ergebnisse und wurde deswegen nicht durchgeführt [Qui-07]. Zur Bestimmung der R- Kurve von 2- dimensionalen Rissen wurden Risse bei unterschiedlichen Lasten (20N, 50N, 100N, 200N) mit einem Knoop- Prüfkörper erzeugt. Auch die **Knoophärte** wurden nach dem obengenannten DIN- Norm ausgewertet.

Die Messung der **4- Punktbiegefestigkeit** (Inertfestigkeit) erfolgte nach DIN EN 843-1 [DIN-95], entweder mit einer elektrodynamischen Prüfmaschine mit Linearmotor- Antriebstechnik der Firma Instron (Electropuls 3000) am Institut für Werkstoffkunde I des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) oder mit einer Universalprüfmaschine (Typ 10T, Firma UTS) des IKMs. Um unterkritisches Risswachstum ausschließen zu können, wurden Prüfgeschwindigkeiten von 1000 MPa/s (Electropuls 3000) oder 240 MPa/s (UTS) eingestellt. Die statistische Auswertung der 4- Punktbiegefestigkeit erfolgte nach der Weibulltheorie, wobei eine Probenanzahl von 20 bis 30 Stück verwendet wurde. Die Weibullparameter m und σ_0 wurden numerisch nach der Maximum-Likelihood- Methode bestimmt [Mun-99].

Zur Bestimmung von Art und Größe der bruchauslösenden Defekte, wurden die Bruchflächen nach den Festigkeitsversuchen mit Hilfe des REMs bei unterschiedlichen Vergrößerungen untersucht. Eine an das REM angeschlossene energiedispersive Röntgenanalyse (EDX) ermöglichte das Analysieren von Einschlüssen.

31

Die **Bruchzähigkeit** der Keramiken wurde mit 2 unterschiedlichen Methoden bestimmt. Die erste, die SEVNB- Methode (Single Edge V- Notch Beam) nach DIN CEN/TS 14425-5 [DIN-04], wurde an gekerbten Biegeproben durchgeführt. Dazu wurden Kerben mit definierter Geometrie in Standard Biegeproben ($3x4x45mm^3$) eingebracht. Die Kerbtiefe lag zwischen 0,8 und 1,20 mm. Die Proben wurden mit einer Diamantsäge vorgekerbt (Kerbtiefe = 0,5 mm) und anschließend mit einer Rasierklinge [Küb-97],[Nis-96] unter Verwendung von unterschiedlichen Diamantpasten ($3 \mu m$, $1 \mu m$, $0,25 \mu m$) auf die Endkerbtiefe gebracht. Diese Kerb-Poliertechnik ermöglichte Kerbradien kleiner 10 μm . Die Bruchzähigkeit wurde nach folgender Gleichung bestimmt:

$$K_{I_{c,SEVNB}} = \frac{F}{B\sqrt{W}} \frac{S_1 - S_2}{W} \frac{3\sqrt{\alpha}}{2(2-\alpha)^{1.5}} Y$$
 3-5

Die Geometriefunktion Y ist in nachfolgender Gleichung in ihrer vollen Form dargestellt.

$$Y = 1,9887 - 1,326\alpha - \frac{(3,49 - 0,68\alpha + 1,35\alpha^2)\alpha(1 - \alpha)}{(1 + \alpha)^2}$$
 3-6

Dabei ist F die Bruchlast, B und W die Probenbreite und -höhe, S₁ und S₂ der Abstand der Auflagerrollen und α die relative Kerbtiefe. Nach dem Versuch wurde die genaue Kerbtiefe auf den Bruchflächen bestimmt.

Die zweite Methode wurde von Chantikul et al. [Cha-81] entwickelt. Hierzu wird ein Vickerseindruck auf der Zugseite der Biegeproben (3x4x45 mm³) eingebracht. Der Eindruck wird mit der oben genannten Härteprüfmaschine erzeugt. Nach Bestimmung der Härte wurde jede Probe in einer 4- Punkt-Biegevorrichtung bis zum Bruch belastet. Mit Hilfe der nachfolgenden Formel kann anschließend die Bruchzähigkeit bestimmt werden.

$$K_{Ic,Chant.} = 0,59 \left(\frac{E}{H}\right)^{1/8} \left(\sigma_c F^{1/3}\right)^{3/4}$$
 3-7

E entspricht dem E- Modul, H der Härte, σ_C der Bruchspannung und F der Belastung beim Härteeindruck.

Die Bruchzähigkeitsbestimmungen für beide Methoden erfolgten mit einer Universalprüfmaschine (Typ 10T, Firma UTS).

3.3.2 Rissspitzenzähigkeitsbestimmung mit dem COD Verfahren

Die Rissspitzenzähigkeit der einzelnen Varianten wurde über die Rissöffnungsprofil-Methode (Crack Opening Displacement, COD) an Vickersrissen bestimmt. Während der Entlastungsphase des Härteversuchs entstehen halbkreisförmige Risse, die durch die Bedingung $K_{Ltip} = K_{10}$ charakterisiert sind. Alle Risse zur Messung des Rissöffnungsprofils wurden über Vickerseindrücke (HV10, 15s) in den Proben erzeugt.

Die Proben wurden zuvor maschinell mit metall- und kunststoffgebundenen Scheiben bis zu einer Diamantkörnung von 2µm poliert und abschließend mit Diamantsuspensionen (1 µm und 0,25 µm) fertig poliert. Anschließend wurden die Proben mit verkürzter Ätzzeit (40s) plasmageätzt (PT 7150, Bio- Rad), um den Rissverlauf besser sichtbar zu machen. Das Gasverhältnis der beiden Gase CF₄ und O₂ betrug während des Ätzvorgangs 4:2. Erst nach dem Ätzen wurden die Eindrücke erzeugt. Die Proben wurden anschließend für 50s mit Platin besputtert. Zur Bestimmung der Rissöffnung wurden Aufnahmen bei Vergrößerungen zwischen 60kX und 200kX mit Hilfe des REMs aufgenommen und anschließend mit einer Bildauswertesoftware (Analysis, Soft Imaging System) vermessen, wobei die Rissöffnung, 25, in Abhängigkeit des Abstandes, x, von der Rissspitze bestimmt wurde. In Abbildung 3-1a ist der guadratische Vickerseindruck schematisch mit der Diagonalen 2b, den vier kreuzförmigen Rissen der Länge 2a und der Laufkoordinate r dargestellt. Zur Bestimmung des momentan am Riss anliegenden Spannungsintensitätsfaktors, ist eine genaue Beziehung der Rissöffnung und des Spannungsintensitätsfaktors notwendig. Eine analytische Lösung wurde dazu von Fett et al. [Fet-05a] entwickelt und ist in Abbildung 3-1b zu sehen.



Abbildung 3-1: a) Geometrische Parameter des Vickerseindrucks und b) Rissöffnungsverschiebung: Vergleich der analytischen Lösung (Linie) und Nährungslösung (gestrichelt)

3.3.3 R- Kurven von 1-dimensionalen Rissen

Das R- Kurvenverhalten für 1- dimensionale Risse (durchgehende Kerbe) wurde an Proben mit der Geometrie 3x4x~25 mm³ bestimmt. Die Proben wurden analog zu den SEVNB- Proben gekerbt, jedoch wurde die Kerbtiefe erhöht und betrug zwischen 2 und 3 mm. Entsprechend den SEVNB- Proben waren die Kerbradien im Bereich von 10µm. Die Proben wurden auf beiden Seiten (4x25mm²) maschinell bis zu einer Körnung von 1µm poliert. Durch eine 4-Punktbiegevorrichtung erfolgte die Krafteinleitung. Abbildung 3-2 zeigt den schematischen Aufbau der Prüfvorrichtung. Diese äußerst steife Vorrichtung ermöglicht stabiles Risswachstum selbst bei sehr spröden Materialien. Die elastische Energie, die beim Aufbringen des Biegemoments in der Probe gespeichert ist, wird bei einer Rissverlängerung in einer Stahlplatte (Abbildung 3-2) oberhalb der Probe absorbiert. Stabiles Risswachstum unter Verwendung eines steifen Lastrahmens wurde als Methode von Fett et al. [Fet-95a] entwickelt und erfolgreich von Jelitto et al [Jel-07] angewandt. Diese Stahlplatte wird vor dem Versuch durch zwei Gewinde (1 und 2) mit einer Biegespannung beaufschlagt. Im Gegensatz zur schematischen Abbildung der Vorrichtung, erfolgte bei diesen Versuchen die Krafteinleitung über einen elektrischen

a)

Schrittmotor mit einem angeschlossenen Untersetzungsgetriebe. Die Kraftmessung erfolgte über eine sehr steife und empfindliche Quarz-Kraftmessdose (Quarz Drucksensor 9212, Kistler Instrumente GmbH) und die Verschiebung der krafteinleitenden Rollen über einen induktiven Wegaufnehmer. Im Kraftfluss vom Schrittmotor zur Probe befindet sich weiterhin ein Piezoaktor. welcher während des Versuchs die krafteinleitenden Rollen um einen Betrag von ca. 30nm bei einer Frequenz von 5 Hz oszillieren lässt. Dadurch war es möglich, die Nachgiebigkeitsänderung die Nachgiebigkeit und der Probe bei Rissverlängerung zu bestimmen. Die Kraft- und Durchbiegungswerte wurden während des Versuchs aufgezeichnet und abgespeichert.



Abbildung 3-2: 4- Punktbiegevorrichtung zur Messung der 1- dim. R- Kurven [Jel-07]

Über das LabView- Steuerprogramm konnte der Versuch halbautomatisch sich betrieben werden. Sobald die Nachgiebigkeit der Probe bei Rissverlängerung um einen vom Bediener eingestellten Wert verringerte, wurde die Belastung automatisch um ca. 10% reduziert. Dadurch wurde einerseits die Vermessung des Risses mit einem optischen Mikroskop bei einer 400 fachen Vergrößerung ermöglicht und anderseits das unterkritische Risswachstum auf ein nicht detektierbares Maß reduziert. Durch die sehr steife Vorrichtung, die vorgespannte Stahlplatte und das schnelle Entlasten der Probe bei Rissverlängerung, war es möglich bei diesen Siliciumnitrid Varianten den Riss in Schritten von 20 µm wachsen zu lassen.

Die steife Quarzkraftmessdose und der Ladungsverstärker weisen durch die große Empfindlichkeit von -11,3 pC/N einen Kraftdrift auf. Durch mehrmalige vollständige Entlastung der Probe während des Versuchs, kann die Abweichung der Kraftwerte von ihrem Startwert (0N) bestimmt werden. Die dadurch erhaltenen Kraftwerte, zuzüglich des Kraftwertes zu Beginn und des Kraftwertes am Ende der Messung, wurden mit Hilfe einer Funktion 2. bzw. 3. Grades gefittet. Anschließend wurden alle Kraftwerte mit dieser Korrekturfunktion neu berechnet.

Eine Verschiebungskorrektur (Durchbiegungskorrektur) war ebenfalls notwendig, da sich die gemessene Verschiebung der Krafteinleitungspunkte aus der reinen Durchbiegung der Probe (gewünschte Messgröße), der Verschiebung durch die Nachgiebigkeit der Probe an den Kontaktpunkten und der apparativen Nachgiebigkeit zusammensetzt. Durch eine Steifigkeitsmessung mit einem speziellen Auflager (Auflagerabstände 20 mm x 20 mm) konnten die letzten beiden Einflussgrößen mittels einer Korrekturfunktion aus den Messwerten heraus gerechnet werden [Jel-07].

3.3.4 R- Kurven von 2-dimensionalen Rissen

Messungen zur Bestimmung des R- Kurvenverhaltens von 2- dimensionalen halbkreisförmigen Rissen wurden an Proben mit den Maßen 3x4x~10 mm³ durchgeführt. Die Proben wurden auf der 3x10 mm² Fläche maschinell bis zu einer Körnung von 2 µm mit metall- und kunststoffgebunden Scheiben poliert. Anschließend wurden mit einem Knoopdiamanten fünf Härteeindrücke einer Belastungskraft in die polierte Seite eingebracht. Die Belastungskräfte wurden innerhalb einer Materialvariante im Bereich von 200 N bis zu 20 N variiert. Nach Erzeugen der Eindrücke wurden diese mit einem Lichtmikroskop vermessen. Zur Bestimmung der Risstiefe wurde eine Zielpräparation durchgeführt. Durch gezieltes abschleifen und anschließendes polieren, bis zu einer Körnung von 0,25 µm, senkrecht zur Eindruckslängsachse wurde Material bis zur Mitte des Eindrucks entfernt (Abbildung 3-3). Die Risstiefe wurde dann sowohl mittels Lichtmikroskop, als auch mit Hilfe des REMs vermessen. Die höhere Auflösung

des REMs ermöglichte eine genauere Vermessung der Risslänge. Dafür wurden die Proben ähnlich der COD- Bestimmung geätzt und besputtert.



Abbildung 3-3: Risserzeugung und Zielpräparation für 2- dimensionale R-Kurvenmessung

4 Ergebnisse

4.1 Sinterung

Die in dieser Arbeit untersuchten Mg- dotierten Siliciumnitridvarianten wurden von Satet [Sat-04] während ihrer Dissertation entwickelt. Sowohl die Zusammensetzungen der einzelnen Keramiken, als auch die Sinterparameter konnten größtenteils für diese Arbeit übernommen werden. Außerdem konnte die Zusammensetzung und überwiegend die Sinterparameter der SiY Variante aus der Dissertation von Geyer [Gey-98] verwendet werden.

Die Unterschiede zu den bestehenden Varianten beziehen sich ausschließlich auf die Sinterparameter und nicht auf die jeweiligen Zusammensetzungen. Bei der MgY Variante musste der Gasdruck in der Druckstufe von 10 MPa auf 20 MPa erhöht werden, um die Proben ausnahmslos zu konsolidieren. Für die anderen Mg- dotierten Varianten konnten die Sinterparameter vollständig übernommen werden. Eine Änderung der Haltezeit in der Sinterstufe der SiY Variante von 20 min auf 25 min war nötig, um den Porenabschluss vor der Druckstufe sicher gewähren zu können.

Die MgLa Variante konnte anfänglich nicht vollständig verdichtet werden. Auch eine Variation der Sinterparameter führte nicht zu porenfreien Proben. Zu jeder einzelnen Sintervariation wurden Schliffe erzeugt und eine Gefügeuntersuchung mit dem REM durchgeführt. Alle Varianten zeigten Poren, die in einer Art von Nestern auftraten und entlang der Korngrenzen verliefen. In Abbildung 4-1 ist eine Gefügeaufnahme der MgLa Keramik mit den Porennestern zu sehen.



Abbildung 4-1: Gefügeaufnahme mit Porennestern einer Dilatometerprobe der Variante MgLa vor dem Umbau der Heißisostatpresse

Erst ein Umbau der Heißisostatpresse mit einem zusätzlichen Drucksensor für den Niederdruckbereich (0-3 MPa) ermöglichte eine porenfreie Verdichtung der MgLa Variante. Der neue Drucksensor wurde für die Steuerung im unteren Drucksegment verwendet. Eine Erklärung für die vollständige Konsolidierung nach dem Umbau könnte in der exakteren Messung und Regelung des Gasdrucks während der Sinterstufe (~0,8 MPa) liegen. Der Drucksensor für den Hochdruck (0 - 200 MPa) weist einen hohen Fehler (±0,5 MPa) im unteren Drucksegment auf, welcher eventuell vor dem Umbau zu einer Zersetzung der MgLa Variante führte.

Alle in dieser Arbeit untersuchten Proben, sowohl die Mg- dotierten, als auch die SiY- Variante, wurden nach dem Umbau der Heißisostatpresse hergestellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die verwendeten Siliciumnitridvarianten auch unter Verwendung anderer Rohpulverlieferanten und anderer Pulvergemischherstellung (großer Attritor anstatt kleiner Attritor oder Planetenkugelmühle) reproduzierbar herstellen ließen.

4.2 Mikrostruktur

Alle Varianten weisen, mit den in Tabelle 3-2 aufgelisteten Sinterparametern, eine relative Dichte von mehr als 99% auf. Die röntgenographische Untersuchung aller Varianten ergab eine vollständige Umwandlung zur β-Siliciumnitrid Modifikation. Weitere kristalline Sekundärphasen, wie Disilikate oder Oxinitride, wurden nicht detektiert.

Abbildung 4-2 zeigt REM- Aufnahmen der einzelnen Gefüge. Die polierten Schliffe wurden plasmageätzt und mit Gold besputtert. Das Plasmaätzen erzeugt ein Höhenrelief, indem Flurradikale mit dem Silicium der Siliciumnitridkörner reagiert, wodurch die Körner abgetragen werden. Die Siliciumnitridkörner sind in den Gefügeaufnahmen dunkel und die Sekundärphase hell dargestellt.



Abbildung 4-2: Mikrostruktur der einzelnen Siliciumnitrid Varianten

Die Auswertung der Streckungsgrad- (Kornlänge / Korndurchmesser) und Kornlängenverteilung ergab vergleichbare Mikrostrukturen für die Mg- dotierten Varianten. Dies wurde von Satet [Sat-02] durch eine Optimierung der Sinterparameter gezielt eingestellt. Die Variante SiY zeigt im Vergleich zu den Mg- dotierten etwas kürze Kornlängen und kleinere Streckungsgrade. Die Gefügeparameter der kommerziellen Variante AIY sind mit der SiY Variante vergleichbar, weisen jedoch einen noch kleineren Streckungsgrad auf.

Die stereologischen Auswertungen der einzelnen Varianten sind in den Konturplots in Abbildung 4-3 gezeigt. Die Ordinatenachse zeigt die Kornlänge, die Abszisse den räumlichen Streckungsgrad der Körner. Die Häufigkeiten sind





Bei fast allen Varianten ist eine Bimodalität des Streckungsgrads zu erkennen. Es ergibt sich ein Hauptpeak bei Streckungsgraden von ca. 9 und ein zweiter Peak bei ungefähr 16 für die Varianten MgY und MgLa. Die Variante MgLu hat ihren Hauptpeak bei einem Streckungsgrad von ca. 7, zeigt jedoch im Gegensatz zu den beiden anderen Magnesiumdotierten keinen ausgeprägten zweiten Peak. Es ergeben sich dennoch Streckungsgrade von bis zu 24 bei der MgLu- Zusammensetzung. Die AIY Variante zeigt ihren Hauptpeak bei einem Streckungsgrad von ungefähr 3 und einen Weiteren bei 10. Eine ähnliche Verteilung zeigt die SiY Variante mit dem Hauptpeak bei 4 und einen zweiten Peak bei 13.

Auch bei den gemessenen Kornlängen zeigt sich ein Unterschied zwischen den magnesiumdotierten und den beiden anderen Varianten. Die Mg- dotierten erreichen Kornlängen zwischen 12 und 14 µm, wobei die Varianten ohne Magnesium, maximale Kornlängen um 9 µm aufzeigen.

Die Mg- dotierten Zusammensetzungen (MgY und MgLa) haben unter Verwendung des Streckungsgrads (~9) und der Kornlänge (~1 µm) der jeweiligen Hauptpeaks einen Korndurchmesser von ungefähr 110 nm. Die MgLu Variante hat mit ihrem etwas kleineren Streckungsgrad (~7) und Kornlängen um 1µm beim Hauptpeak, im Vergleich zu den anderen Mg- dotierten Varianten einen Korndurchmesser von 140 nm. Einen Korndurchmesser von ca. 300 nm, und somit den Größten, zeigt die AIY- Variante bei einem Streckungsgrad von 3 und einer Kornlänge von 1 µm. Unter Verwendung eines Streckungsgrads von 4 und einer Kornlänge von 1 µm ergibt sich für die SiY Zusammensetzung ein Korndurchmesser ungefähr 250 nm. von Bei der Berechnung der Korndurchmesser der zweiten Häufigkeit ergeben sich vergleichbare Werte wie für den Hauptpeak. Die Mg- dotierten Zusammensetzungen weisen folglich ein Gefüge aus dünneren und längeren Körnern auf, als die Varianten AIY und SiY.

Eine sequentielle Untersuchung der Anzahl der untersuchten Körner ergab, dass sich die Verteilungen des Streckungsgrads und der Kornlängen ab einer Kornanzahl von ca. 2000 nicht mehr signifikant ändern. Dadurch kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die hier durchgeführte Mikrostrukturauswertung das Gefüge der Varianten hinreichend gut beschreibt.

43

4.3 Mechanische Eigenschaften

4.3.1 Härte

Die gemessenen Vickers- und Knoophärten der untersuchten Siliciumnitrid-Varianten, bei Belastungskräften von 98 N, sind in Tabelle 4-1 angegeben.

Härte	MgY	MgLa	MgLu	SiY	AIY
HV 10	1506 ± 26	1479 ± 20	1531 ± 15	1488 ± 20	1486 ± 30
HK 10	1363 ± 9	1270 ± 15	1350 ± 6	1278 ± 8	1326 ± 12

Tabelle 4-1: Härtewerte nach Vickers und Knoop

Das arithmetische Mittel der Härteangaben wurde im Fall der Vickersprüfkörper aus 10 Einzelmessungen und beim Knoopprüfkörper aus 5 Einzelmessungen bestimmt. Die mit Magnesium dotierten Keramiken zeigen eine leicht höhere Vickershärte auf, als die SiY und AIY- Varianten. Dennoch sind die mittleren Härtewerte der einzelnen Varianten als gleichwertig anzusehen, da sie im Streubereich der Messungen liegen. Durch die Verwendung der unterschiedlichen Eindruckkräfte (20- 200N) beim Knoopprüfkörper kann die Abhängigkeit der Härte zur Eindruckkraft dargestellt werden. Die Knoophärte nahm hierbei um ca. 11% von der minimalen zur maximalen Eindruckkraft ab. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 4-4 dargestellt.



Abbildung 4-4: Knoophärte über der Eindruckkraft

4.3.2 Festigkeit

Die Bruchfestigkeiten der Varianten MgY (30 Proben), MgLa (20 Proben), MgLu (30 Proben), AlY (24 Proben) und SiY (30 Proben) wurden mittels eines 4 Punkt-Biegeversuchs bestimmt. Die im folgenden Weibulldiagramm (Abbildung 4-5) abgebildete Verteilung kann mit der allgemeinen Formel 4-1 dargestellt werden,

$$F(\sigma_{4PB}) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{\sigma_{4PB}}{\sigma_0}\right)^m\right]$$
4-1

wobei σ_0 die charakteristische Festigkeit und m der Weibullmodul ist. Die SiY-Variante weist mit einer charakteristischen Festigkeit von 621 MPa den niedrigsten Wert auf. Mit einer Festigkeit um 1 GPa liegen die anderen Varianten sehr nahe beieinander (MgLu = 990 MPa, MgLa = 1008 MPa, MgY = 1011 MPa, AIY = 1044 MPa). Die Weibullmoduli, m, liegen, bei den am IKM hergestellten Varianten, zwischen 8,2 und 9,9 und somit eng beieinander, was auf eine vergleichbare Defektgrößenverteilung hinweist. Die kommerzielle Variante hat durch den optimierten Herstellungsprozess einen etwas höheren Weibullmodul (m = 11,5).



Abbildung 4-5: Weibullverteilung der 5 untersuchten Si₃N₄- Keramiken

Ein Auszug aus den bruchauslösenden Defekten ist in Abbildung 4-6 zu sehen. Bei denen am IKM hergestellten Varianten sind vorwiegend Poren und Einschüsse der bruchauslösende Defekt (a-c), wobei bei der kommerziellen Variante AIY der bruchauslösende Defekt meist auf die Hartbearbeitung zurück zuführen ist (d).



Abbildung 4-6: Auszug der bruchauslösende Defekte der einzelnen Varianten. a) Pore in der Nähe der Oberfläche (MgLa), b) Volumendefekt (Pore) in der MgLu-Variante, c) Einschluss (Fe, Si) in der SiY- Keramik, d) Oberflächenriss in der AlY- Variante

4.3.3 Zähigkeit

Die zur Grundcharakterisierung durchgeführten Bruchzähigkeitsbestimmungen, anhand der SEVNB- und der Chantikul- Methode [Cha-81], liefern für die fünf Siliciumnitrid- Varianten Zähigkeitswerte von 2,7 MPam^{1/2} bis 6,8 MPam^{1/2}. Es zeigte sich für beide Prüfmethoden eine gute Übereinstimmung. Die SiY-Variante besitzt mit Bruchzähigkeitswerten um 2,7 MPam^{1/2} ein sehr sprödes Verhalten, wobei die Mg- dotierten Zusammensetzungen ein sehr hohes Bruchzähigkeitsniveau von 6,8- 7,8 MPam^{1/2} zeigen. Die kommerzielle Variante AlY liegt mit Werten um 5,5 MPam^{1/2} im Mittelfeld.

	MgY	MgLa	MgLu	SiY	AIY
SEVNB	6,77 ± 0,28	7,04 ± 0,19	6,48 ± 0,14	3,59 ± 0,78	5,65 ± 0,25
Chantikul	6,87 ± 0,24	7,78 ± 0,07	7,06 ± 0,08	2,73±0,08	5,42 ± 0,10

Tabelle 4-2: Bruchzähigkeit mittels SEVNB und Chantikul in MPam^{1/2}

4.3.4 Rissspitzenzähigkeit

Zur Bestimmung der Rissspitzenzähigkeit, K_{10} , wurde die Rissöffnung, 2δ , in Abhängigkeit des Abstandes zur Rissspitze, x, vermessen. In Abbildung 4-7 ist ein Riss im Material AIY exemplarisch bei unterschiedlichen Vergrößerungen abgebildet.



Abbildung 4-7: Riss mit Rissspitze in der AIY Zusammensetzung zur Bestimmung der Rissspitzenzähigkeit

Um den Spannungsintensitätsfaktor an der Rissspitze, K_{10} , im Fall von Vickerseindrücken bestimmen zu können, ist eine Beziehung zwischen der Rissöffnungsverschiebung, δ , und dem Spannungsintensitätsfaktor nötig (siehe

dazu Abbildung 3-1b). Eine analytische Lösung zur Beziehung der Rissöffnungsverschiebung und dem Spannungsintensitätsfaktors erarbeitete Fett et al. [Fet-05a]. Schneider und Fett [Sch-06] publizierten eine vereinfachte Lösung für a/b> 1,4 und x/a<0,5. Die zur Berechnung der Risspitzenzähigkeit herangezogene Lösung (Formel 4-2)

$$K = \frac{\delta}{\left(\sqrt{\frac{8}{\pi}\frac{x}{b}} + A_1\left(\frac{x}{b}\right)^{3/2} + A_2\left(\frac{x}{b}\right)^{5/2}\right)}\frac{E'}{\sqrt{b}}$$
4-2

beinhaltet nur die beiden Führungskoeffizienten A₁ und A₂. Die Führungskoeffizienten beinhalten die geometrischen Abhängigkeiten vom Vickerseindruck und den Rissen und sind nachfolgend definiert.

$$A_1 \approx 11,7 \exp\left[-2,063\left(\frac{a}{b}-1\right)^{0.28}\right] - \frac{0,898}{\frac{a}{b}-1}$$
 4-3

$$A_2 \cong 44.5 \exp\left[-3.712 \left(\frac{a}{b} - 1\right)^{0.28}\right] - \frac{0.898}{\left(\frac{a}{b} - 1\right)^{3/2}}$$
 4-4

Der effektive Elastizitätsmodul E' ist definiert durch:

$$E' = \begin{cases} E & \text{Ebener Spannungszustand} \\ E/(1-\nu^2) & \text{Ebener Dehnungszustand} \end{cases} 4-5$$

mit dem Elastizitätsmodul, E, und der Querkontraktionszahl, v.

Da ein ebener Spannungszustand an der Oberfläche der Probe herrscht, wurde der mittels Ultraschalllaufzeitmessungen erhaltene Elastizitätsmodul mit $E = E^{2} = 310$ GPa für alle Varianten verwendet.



Abbildung 4-8: Rissöffnung, 2δ, vs. Abstand von der Rissspitze, x, aller 5 Varianten (a-e). f) Vergrößerter Ausschnitt der MgY Zusammensetzung, wobei die Volllinie nach Gleichung 4-2 und die gestrichelte nach Gleichung 4-6 berechnet wurde.

In Abbildung 4-8 sind die Ergebnisse der einzelnen Daten und die zugehörigen Fit- Kurven nach Gleichung 4-2 dargestellt. Die AIY Zusammensetzung hat eine Rissspitzenzähigkeit von 1,86 MPam^{1/2}. Eine etwas höhere intrinsische Risszähigkeit von 1,95 MPam^{1/2} weist die Variante MgLa auf. Ebenfalls eine Rissspitzenzähigkeit unter 2,0 MPam^{1/2} hat die Variante MgY mit 1,99 MPam^{1/2}. Die Varianten MgLu mit $K_{10} = 2,34 \text{ MPam}^{1/2}$ und SiY mit $K_{10} = 2,44 \text{ MPam}^{1/2}$ haben beide eine Rissspitzenzähigkeit über 2,0 MPam^{1/2}.

Die Irwin- Parabel zur Darstellung der Beziehung des Spannungsintensitätsfaktors an der Rissspitze zur Rissöffnungsverschiebung eines jeden Risses, erhält man aus Gleichung 4-2 durch Nullsetzen der Koeffizienten A₁ und A₂. In Gleichung 4-6 ist die Irwin Gleichung dargestellt.

$$K_{I0} = \frac{\delta}{\sqrt{x}} \frac{E}{\sqrt{\frac{8}{\pi}}}$$
 4-6

Diese Methode liefert durch einen Fit der ersten Datenpunkte (x<6µm) mit Gleichung 4-6 im Vergleich zur Näherungslösung (Gleichung 4-2) ein hinreichend gutes Ergebnis für die Rissspitzenzähigkeit. In Abbildung 4-8f ist ein vergrößerter Ausschnitt von Abbildung 4-8a gezeigt, in welchem die gute Übereinstimmung der beiden Formeln zu erkennen ist.

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Rissspitzenzähigkeit an Hand des Rissöffnungsprofils, ist das Auftragen der gemessenen Rissöffnung, 2δ , gegen eine berechnete Rissöffnung, $2\delta_{ber}$. Die Berechnung der Rissöffnung erfolgt nach Gleichung 4-2 mit einem Spannungsintensitätsfaktor von K=1 MPam^{1/2}. Exemplarisch ist dies an Variante MgLa in Abbildung 4-9 gezeigt. Es sind bei dieser Auftragung der Daten zwei unterschiedliche Steigungen zu sehen. Einen linearen Fit durch den Anfangsbereich, $0<2\delta<0,09$ liefert die Steigung 1,95. Aus der Steigung kann direkt auf den Spannungsintensitätsfaktor, in diesem Fall K=1,95 MPam^{1/2}, an der Rissspitze geschlossen werden.



Abbildung 4-9: Gemessene Rissöffnung vs. berechnete Rissöffnung mit K=1 MPam^{1/2}

In einem weiteren Schritt wurde ebenfalls mit Hilfe von COD- Messungen die intrinsische Bruchzähigkeiten der Siliciumnitridkörner bestimmt. Dazu wurden von Paul F. Becher vom Oak Ridge National Laboratory (USA) anhand würfelförmiger Prüfkörper Risse in übersättigten oxinitridischen Gläsern erzeugt und anschließend Aufnahmen der Risse, welche in den Siliciumnitridkörnern endeten, mit einem REM aufgenommen. Das Vermessen und auswerten erfolgte nach der oben beschriebenen Methode. In Abbildung 4-10a) ist ein Riss gezeigt, welcher in einem Winkel von 55° zur Längsachse (c- Achse) in das Korn eingetreten ist.



Abbildung 4-10: a) Riss in einem Si₃N₄- Korn zur Bestimmung der Bruchzähigkeit b) Effektiver E- Modul der anisotropen Siliciumnitridkörner in Abhängigkeit des Winkels zur c- Achse des Korns

Da die Gleichung 4-6 nur zur Beschreibung des Rissöffnungsprofils im Nahfeld der Rissspitze und für isotrope Materialien gilt, musste wegen der Anisotropie der Elastizitätskonstanten der β - Si₃N₄ Körner [Hay-98], [Oga-04] ein effektiver E- Modul, E_{eff}, bestimmt werden. Dazu wurde in Kooperation mit dem Institut für Technische Mechanik des Karlsruher Institut für Technologie in einer FEM Simulation ein Riss in einem Siliciumnitridkorn eingebracht und anschließend der Steifigkeitstensor des Siliciumnitidkorns winkelabhängig geändert. Bei jedem einzelnen Winkelschritt wurde das Korn mit dem Riss belastet und das Rissuferverschiebungsprofil berechnet. Zur Normierung des E- Moduls waren begleitende Simulationen an isotropem Material, in diesem Fall an einem oxinitridischen Glas, nötig. Mit Hilfe von Gleichung 4-7 und den berechneten Rissuferverschiebungen δ_{Glas} , δ_{SN} und dem isotropen E- Modul des Glases konnte der effektive E- Modul des Siliumnitridkorns, E'_{eff,SN} bestimmt werden.

$$E'_{Eff,SN} = \frac{\delta_{Glass}}{\delta_{SN}} E'_{Glass}$$
 4-7

Gleichung 4-7 leitet sich aus der Irwin- Gleichung 4-6 ab, indem in der Simulation gleiche Probengeometrien und Randbedingungen (z.B. die angelegte Spannung), für das Glas und das Silicumnitridkorn verwendet wurden. Dadurch sind die Spannungsintensitätsfaktoren an der Rissspitze in beiden Fällen identisch. Der E- Modul des Glases betrug für den ebenen Dehnungszustand 155 GPa [Sat-02].

Der winkelabhängige effektive E- Modul, E_{eff} , für das Siliciumnitridkorn ist in Abbildung 4-10b) über dem Winkel φ dargestellt. Die fünf Stützpunkte sind anhand der Simulationen bestimmt worden.

Aus diesen Berechnungen ergab sich eine maximale Bruchzähigkeit senkrecht zur c- Achse des Korns von ungefähr 11,5 MPam^{1/2} und eine minimale Bruchzähigkeit parallel zur c- Achse von ca. 4,0 MPam^{1/2}. Trifft ein Riss in einem Winkel zwischen den beiden Extremen auf ein Korn, dann ruft die Anisotropie des Korns einen Mode-II Spannungsintensitätsfaktor hervor, welcher jedoch mit einem Anteil von ca. 4% des Mode-I Spannungsintensitätsfaktors vernachlässigt werden kann.

4.3.5 R- Kurven (1- dimensionale Risse)

Die R- Kurvenmessung an 1- dimensionalen Rissen erfolgte an gekerbten Biegestäbchen. Der steife Rahmen und das halbautomatische, schnelle Entlasten der Probe erlaubten stabiles Risswachstum in den Varianten MgY, MgLa, MgLu und AIY. Bei der Variante SiY war stabiles Risswachstum nicht möglich. In Abbildung 4-11 sind die vier R- Kurven nach der Korrektur der Kraftund Verschiebungswerte gezeigt. Der Spannungsintensitätsfaktor, K_R, wurde mittels optisch gemessener Risslänge nach Gleichung 2-5 berechnet.



Abbildung 4-11: a) R- Kurven über eine Rissverlängerung von 1,2 mm und b) die ersten 100 μm Rissverlängerung

Die Datenpunkte, die bei ca. 100, 250 und 500 µm parallel zur Ordinate verlaufen (deutlich bei der AIY Variante), wurden aus Kraftwerten, die während den Vollentlastungen zur Kraftkorrektur aufgenommen wurden, berechnet. Bei den Vollentlastungen konnte keine Rissverlängerung festgestellt werden.

In Abbildung 4-11b sind die ersten 100 µm Rissverlängerung der einzelnen R-Kurven dargestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass die ersten gemessenen Risslängen im Bereich von 7,5 bis 20 µm liegen. Der, aus dieser Risslänge berechnete, K_R- Wert liegt bei allen Zusammensetzungen nahezu am Plateauwert. Ein Anstieg der R- Kurve ausgehend von der Rissspitzenzähigkeit, K₁₀, konnte nicht ermittelt werden. Die erhaltenen Plateauwerte liegen für die AIY- Variante mit ungefähr 5,5 MPam^{1/2} am niedrigsten und mit knapp 8 MPam^{1/2} für die MgY am höchsten. Die beiden yttriumdotierten Varianten zeigen ein relativ konstantes Plateauniveau. Bis zu einer Rissverlängerung von ca. 500µm zeigt die MgLu- Variante ebenfalls einen nahezu konstanten Verlauf des Plateauwerts bei ungefähr 7 MPam^{1/2} und steigt dann wieder leicht an. Die K_B-Werte der MgLa- Variante steigen konstant von ca. 6,5 bis 8 MPam^{1/2} an. Alle 4 Varianten zeigen einen steilen Anstieg der K_R- Werte bei Rissverlängerungen um 1 mm auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei großen a/H (Risslänge/Probenhöhe)- Verhältnissen die Geometriefunktion, Y, stark ansteigt. Hauptgrund dafür ist, dass das Spannungsfeld vor der Rissspitze von der Rückwand der Probe beeinflusst wird.

Um nun den Anstieg der R- Kurve sichtbar zu machen, wurden die Kraft-Durchbiegungswerte des Versuchs herangezogen. Bedingt durch den Versuchsaufbau und die Probengeometrien mussten diese Werte, zusätzlich zur Kraft- und Durchbiegungskorrektur, noch weitere, im Folgenden beschriebene, Korrekturschritte durchlaufen.

Kerbe- Riss- Konfiguration

Die konventionelle Methode zur Berechnung der R- Kurve basiert auf den Kraftund Rissverlängerungsmessungen unter Verwendung der "Langrisslösung". Die Kerbe wird dabei als Riss angesehen (Abbildung 4-12a). Der Stern * indiziert die konventionellen Methoden zur Berechnung der einzelnen Größen.

$$K^* = \sigma_{\sqrt{\pi(a)}} F(W) \tag{4-8}$$

Der Spannungsintensitätsfaktor in Formel 4-8 setzt sich aus der Spannung, σ , der zusammengesetzten Risslänge, $a=a_0+l$, und der Geometriefunktion, F, zusammen.

Der neue Ansatz zur Berechnung des Spannungsintensitätsfaktors geht von einer Kerbe und einem Riss aus, welcher im Kerbgrund entspringt (Abbildung 4-12b). Die Größe, *l*, wurde eingeführt, um die Risslänge ausgehend von der Kerbe zu beschreiben.



Abbildung 4-12: a) Lang- Riss Lösung und b) Kerbe mit Riss

Die sich unter der Annahme der Langrisslösung ergebene Nachgiebigkeitsänderung, ΔC^* , ist wie folgt definiert:

$$\Delta C^* = \frac{9}{2} \frac{L^2 \pi}{BW^4 E'} \int_{a_0}^{a_0+l} F^2 a' d(a')$$
 4-9

In Gleichung 4-9 ist $L=S_1-S_2=10$ mm der Auflagerabstand, B und W sind die Probenbreite bzw. Probenhöhe und a' die Integrationsvariable.

Einfluss des Kerbeffekts

Der Einfluss des Kerbradius auf den Spannungsintensitätsfaktor wurde in der Literatur [Fet-95c], [Fet-06] bereits hinreichend behandelt, jedoch selten bei der Berechnung des Spannungsintensitätsfaktors bei Rissen im Nahfeld des Kerbgrundes berücksichtigt.

Der Spannungsintensitätsfaktor, K^{*}, aus Gleichung 4-8 ist näherungsweise richtig, solange die Risslänge, Δa , deutlich größer als der Kerbradius, R, ist. Bei Risslängen, *l*, in der Größenordnung des Kerbradius, R, weicht der tatsächliche

Spannungsintensitätsfaktor, K, deutlich von dem bisherigen K* ab. Der korrekte Spannungsintensitätsfaktor, K, kann unter Berücksichtigung folgender geometrischer Abhängigkeiten berechnet werden: der Riss muss von einer dünnen Kerbe ausgehen und des Weiteren muss der Kerbradius, R, vernachlässigbar klein zur Kerbtiefe, a₀, und anderen Probenmaßen sein. Dies wurde bei diesen Experimenten erfüllt. Die graphische Darstellung der Formel 4-10 ist in Abbildung 4-13 wieder gegeben.

$$K/K^{*} \cong \tanh[A\sqrt{l/R}]$$

$$A = 2,243$$
4-10
$$A = 2,243$$

$$A = 2,244$$

Abbildung 4-13: Beziehung zwischen dem wahren Spannungsintensitätsfaktor, K, und dem konventionell berechneten Spannungsintensitätsfaktor, K*, für einen Riss vor einer Kerbe

Es ist klar zu erkennen, dass für l > 1,5R die Kerbeffekte von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Nachgiebigkeitsänderung, ∆C, die von einem Riss vor einer dünnen Kerbe hervorgerufen wird, kann mittels Gleichung 4-11 berechnet werden.

$$\Delta C = \frac{9}{2} \frac{L^2 \pi}{BW^4 E'} \int_{a_0}^{a_0+l} F^2(a_0+l)' \tanh^2 \left[A\sqrt{l'/R}\right] d(l')$$
 4-11

Eine analytische Näherung der Gleichung 4-11, kann wie folgt beschrieben werden:

$$\Delta C \cong \left(1 + \frac{2}{A^2} \frac{R}{l} \ln\left(\cosh\left[A\sqrt{l/R}\right]\right) - \frac{2}{A}\sqrt{R/l} \tanh\left[A\sqrt{l/R}\right]\right) \Delta C^*$$
4-12

In Formel 4-12 ist ΔC^* die konventionell berechnete Nachgiebigkeit nach Gleichung 4-9 und ΔC entspricht der gemessenen Nachgiebigkeitsänderung.

Durch das Einsetzen der gemessenen Nachgiebigkeit, ΔC , kann die Gleichung 4-11, unter der Beachtung des oberen Integrationslimits, nach *l* aufgelöst werden. Für diese Berechnung wurde das Modul "Find Root" von Mathematica verwendet.

Zur Beschreibung der Rissverlängerung eines Risses, der aus einer Kerbe startet, wird davon ausgegangen, dass ein kleiner Riss der Länge, l_0 , durch das Bearbeiten bereits entstanden ist. Dieser Startriss verlängert sich bei Belastung um einen Betrag von Δl . Es gilt:

$$l = l_0 + \Delta l \tag{4-13}$$

Der Vorgang zur Berechnung der korrigierten Spannungsintensitätswerte, K_B, mit Hilfe der aus den Nachgiebigkeitsmessungen erhaltenen Risslängen, li, wird schematisch an der Variante MgLa gezeigt. Es werden dabei sowohl die Korrektur der "Lang- Riss- Lösung", als auch die Korrektur des Einflusses des Kerbradius mit berücksichtigt. Abbildung die In 4-14 ist Kraft-Durchbiegungskurve (a) und die Kraft- Nachgiebigkeitsänderungskurve (b) für den Bereich um 96 N dargestellt. In diesem Bereich kam es bei der MgLa Variante mit einer Kerblänge von 2,63 mm durch Rissverlängerung zur ersten messbaren Nachgiebigkeitsänderung.



Abbildung 4-14: a) Kraft- Durchbiegungswerte mit einer Fit- Geraden für die ΔC -Berechnung, b) zeigt die Messdaten über der Nachgiebigkeitsänderung

Die Startrisslänge, l_0 , kann mit der Gleichung 4-14 nährungsweise durch das Vergleichen von K₁₀ (Kapitel 3.3.2) und der Kraft bei der ersten Rissverlängerung P₀ -> σ_0 bestimmt werden.

$$l_0 \cong \frac{R}{A^2} \left(\tanh^{-1} \left[\frac{K_{I0}}{\sigma_0 F(a_0/B) \sqrt{\pi a_0}} \right] \right)^2$$
 4-14

Für die MgLa Zusammensetzung mit einer Rissspitzenzähigkeit, K₁₀, von 1,95 MPam^{1/2}, ist die effektive Startrisslänge $l_0 = 0,19\mu m$.

Zur Berechnung der Nachgiebigkeitsänderung bei Rissverlängerung wurde im linearen Bereich zwischen 89 bis 95N eine Fit- Gerade erzeugt. Diese Fit Gerade ist in Abbildung 4-14a abgebildet. Für jeden Datenpunkt (δ_i , P_i) wurde die Durchbiegungsänderung zur Fit- Gerade bestimmt $\Delta \delta_i = \delta_i - \delta_{fit}$. Die Nachgiebigkeitsänderung ergibt sich durch:

$$\Delta C_i(\Delta l) = \frac{\Delta \delta_i}{P_i}$$
 4-15

Das Ergebnis ist in Abbildung 4-14b) zu sehen, wobei die gestrichelten Linien den Streubereich der Daten wiedergeben.

Anhand der einzelnen Nachgiebigkeitsänderungen, ΔC_i , kann dann Gleichung 4-11 nach den jeweiligen Risslängen, l_i , aufgelöst werden. Diese Risslängen l_i werden darauffolgend in Gleichung 4-8 zur Bestimmung von K*_i verwendet. Der erhaltene Spannungsintensitätsfaktor, K*_i, und die Risslänge, l_i , dienen anschließend in Gleichung 4-10 der Berechnung des "korrekten" Spannungsintensitätsfaktors, K_i.

Alle R- Kurven wurden mit diesen Korrekturschritten überarbeitet. Die korrigierten R- Kurven sind in Abbildung 4-15 dargestellt, wobei der Anfangsbereich (~20µm) der R- Kurven aus den "korrigierten" Kraft-Durchbiegungswerten bestimmt wurde. Der weitere Verlauf der R- Kurve besteht aus den Daten, die mit der konventionellen Methode, dem Lichtmikroskop, ermittelt wurden.


Abbildung 4-15: R- Kurven mit korrigiertem Anfangsbereich, b) Ausschnitt aus a) Die AlY- Variante zeigt den flachsten Anstieg der K_R- Werte zum Plateau bei 5,5 MPam^{1/2}. Die MgLa- Variante weist einen etwas steileren Anstieg, als die der AlY auf. Bei dieser Variante ist der Übergang von der "berechneten" zur gemessenen R- Kurve bei ca. 15 µm Rissverlängerung am deutlichsten sichtbar. Es ergibt sich ein "Sprung" in den K_R- Werten von 5,6 MPam^{1/2} auf 6,4 MPam^{1/2}. Die MgLu und MgY Zusammensetzungen zeigen bis zu einem K_R- Wert von ca. 5,5 MPam^{1/2} einen vergleichbaren Anstieg, wobei die MgLu Variante ab diesem Wert einen flacheren Anstieg aufweist und bei ca. 6,5 MPam^{1/2} in ihren Plateauwert übergeht. Im Gegensatz zur MgLu Variante steigt die MgY Variante noch bis zu einem Wert von 6,5 MPam^{1/2} mit der primären Steigung weiter an und geht erst dann in das Plateau über.

4.3.6 Brückenspannungsbestimmung

Die Bestimmung der Brückenspannungen erfolgt direkt aus den Daten der R-Kurven nach einer Methode von Fett et al. [Fet-95a]. Eine R- Kurve kann dabei wie folgt beschrieben werden:

$$K_{R} = K_{I0} - K_{sh}, \quad K_{sh} = K_{Br} < 0$$
 4-16

Der "shielding" Spannungsintensitätsfaktor, K_{sh}, in Gleichung 4-16 wird künftig als Brückenspannungsintensitätsfaktor, K_{Br}, bezeichnet, da in Siliciumnitrid das Abschirmen (shielding) der Rissspitze über Rissflankeneffekte erfolgt, welche die Rissflanken "überbrücken".

Die Brückenspannungsberechnung der Variante SiY war durch die fehlende R-Kurve nicht möglich. Die Berechnung der Brückenspannung erfolgt über einen iterativen Lösungsweg. Um diesen Lösungsweg zu veranschaulichen werden die beiden durchzuführenden Berechnungsschleifen separat behandelt.

Äußere Schleife

Da das Brückenspannungsgesetz, $\sigma_{Br} = f(\delta)$, nicht bekannt ist, konnte kein Brückengesetz, wie in Kapitel 2.2 gezeigt, verwendet werden. Daher wird eine Reihenentwicklung in Abhängigkeit von δ und unbekannten Koeffizienten, A_n, zur Beschreibung des Brückenspannungsgesetzes herangezogen. Die verwendete Reihenentwicklung ist in Formel 4-17 dargestellt. Die totale Rissöffnungsverschiebung, δ , setzt sich hierbei aus der angelegten Rissöffnungsverschiebung, δ_{appl} , und der Rissöffnungsverschiebung, δ_{Br} , hervor gerufen durch die am Riss wirkenden Brückenspannungen, zusammen.

$$\sigma_{Br} = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \delta^n \cong \sum_{n=0}^{N} A_n \delta^n = A_0 + A_1 (\delta_{appl} + \delta_{Br}) + A_2 (\delta_{appl} + \delta_{Br})^2 + \dots$$
 4-17

Das obere Reihenlimit wird auf eine endliche Anzahl von Koeffizienten (N~4) beschränkt, um dadurch den Rechenaufwand zu beschränken.

Um die unbekannten Koeffizienten, A_n, bestimmen zu können, sind mindestens N+1 Gleichungssysteme notwendig. Aus diesem Grund gibt man das Brückenspannungsgesetz (Formel 4-17) an mindestens N+1 "innere Schleifen" weiter. Die "inneren Schleifen" unterscheiden sich dabei nur durch unterschiedlich vorgegebene Risslängen, a_i. Die Risslängen werden dabei so gewählt, dass die aus den folgenden Berechnungen erhaltenen K_R- Werte mit den gemessenen K_R- Werten der R- Kurve verglichen werden können. Dabei liegt der Bereich des größten Interesses im Anstieg der R- Kurve.

Aus jeder der "inneren Schleifen" werden die σ_{Br} (x, δ)- , δ_{Br} - und K_{Br}- Werte an die "äußere Schleife" ausgegeben. Die jeweiligen K_{Br}- Werte können anschließend zu den zugehörigen K_R- Werten mit Hilfe von Gleichung 4-16 verrechnet werden.

In der ersten Iteration werden in der "äußeren Schleife" die Koeffizienten, A_n, frei gewählt und mit den Risslängen, a_i, an die "inneren Schleifen" übergeben. Nach der ersten Iteration und Rückgabe der Werte aus den "inneren Schleifen" an die "äußere" werden die erhaltenen K_R- Werte mit den gemessenen verglichen.

Anschließend werden die Koeffizienten, A_n , variiert und wieder zurück in die "inneren Schleifen" übergeben. Die Risslängen unterliegen keiner Variation. Ziel ist dabei einen Koeffizientensatz, A_n , zu erhalten, mit welchem die berechnete R-Kurve (aus den N+1 K_R- Werten) mit der experimentell erhaltenen R- Kurve übereinstimmt. Die tolerierte Abweichung zwischen gemessener und gerechneter R- Kurve sollte unter 1% liegen.

Innere Schleife

Jede "innere Schleife" erhält von der "äußeren" eine Risslänge, a_i , und den Koeffizientensatz, A_n . Die geometrischen Zusammenhänge sind in Abbildung 4-16 dargestellt, wobei die Kerbtiefe mit a_0 , die Risslänge mit a und die Laufkoordinaten mit x und a` bezeichnet sind.



Abbildung 4-16: Schematische Darstellung der geometrischen Abhängigkeiten Die "anliegende" Rissöffnungsverschiebung, δ_{appl} , wird durch folgende Formel beschrieben:

$$\delta_{appl} = \frac{1}{E'} \int_{x}^{a} h(x,a') K_{appl} da' = \frac{1}{E'} \sigma_0 \int_{x}^{a} h(x,a') da' \int_{0}^{a} (1 - \frac{2x}{W}) dx'$$
 4-18

Durch den Biegeversuch ist die Spannungsverteilung zur Berechnung des anliegenden Spannungsintensitätsfaktors, K_{appl}, wie folgt definiert:

$$\sigma_{appl} = \sigma_0 \left(1 - \frac{2x}{W} \right); K_{appl} = K_{ip} = K_{I0} - K_{Br} \quad K_{Br} < 0$$
 4-19

W entspricht dabei der Probenhöhe. Die Gewichtsfunktion [Fet-97] in Gleichung 4-18 hat die Form

$$h = \sqrt{\frac{2}{\pi a}} \frac{1}{\sqrt{1-\rho}} \left[1 + \sum_{\nu,\mu} \frac{A_{\nu\mu} \alpha^{\mu}}{(1-\alpha)^{3/2}} (1-\rho)^{\nu+1} \right], \ \rho = \frac{x}{a}, \ 0 \le \alpha = \frac{a}{W} \le 0.85$$
 4-20

und kann mit den Koeffizienten, $A_{\nu\mu}$, der nachfolgenden Tabelle berechnet werden.

V	µ=0	1	2	3	4
0	0,4980	2,4463	0,0700	1,3187	-3,067
		-			
1	0.5416	-5,0806	24,3447	-32,7208	18,1214
	,	,	,	,	,
2	-0,19277	2,55863	-12,6415	19,7630	-10,986
	,	,		,	,

Tabelle 4-3: Koeffizienten Avu für Gewichtsfunktion h

Des Weiteren wird für die "innere Schleife" die Berechnung der Rissöffnungsverschiebung, δ_{Br} , benötigt, die an Hand der Formel 4-21 unter Verwendung der Gewichtsfunktion in Gleichung 4-20 bestimmt werden kann.

$$\delta_{Br} = \frac{1}{E'} \int_{x}^{a} h(x, a') da' \int_{0}^{a} h(x', a') \sigma_{Br}(x') dx' = \delta - \delta_{appl}$$
 4-21

Im ersten Iterationsschritt wird δ_{Br} = 0 gesetzt und man erhält dadurch aus Gleichung 4-19 $K_{appl} = K_{I0}$. Dieser anliegende Spannungsintensitätsfaktor, K_{appl} , dient zur Berechnung der anliegenden Rissöffnungsverschiebung, δ_{appl} , aus Gleichung 4-18. Da $\delta_{Br} = 0$ ist, kann aus Gleichung 4-17 die Brückenspannungsverteilung bestimmt werden und anschließend auch der Brückenspannungsintensitätsfaktor, KBr. Der erste Iterationsschritt der "inneren Schleifen" ist abgeschlossen.

Im nächsten Iterationsschritt, wird nun ein "neues" Kappl aus Gleichung 4-19 und dem aus der ersten Iteration berechneten K_{Br} bestimmt. Nachfolgend kann dann weiteres δ_{appl} Gleichung 4-18 berechnet ein nach werden. Die Brückenspannungsverteilung aus dem vorherigen Iterationsschritt dient des von Gleichung 4-21. Durch die "neuen" Rissöffnungsverschiebungen, δ_{Br} , und δ_{appl} kann eine weitere Brückenspannungsverteilung aus Gleichung 4-17 abgeleitet werden. Diese Iterationen werden solange wiederholt, bis sich σ_{Br} , δ_{Br} bzw. K_{br} nicht mehr ändern. Die "innere Schleife" konvergiert jedoch nur bei realistisch gewählten Anfangskoeffizienten, A_n.

Nachdem die Werte der "inneren Schleifen" konvergierten, werden sie an die "äußere Schleife" übergeben. In der "äußeren Schleife" wird dann aus den jeweiligen Risslängen und K_{Br}- Werten die R- Kurve nachgebildet. Diese berechnete R- Kurve wird nun mit der gemessenen verglichen. Die Differenz zwischen berechneter und experimentell bestimmter R- Kurve wird verkleinert, indem die Koeffizienten, A_n, angepasst und in die "inneren Schleifen" zurück übergeben werden. Die Berechnung der "inneren" und "äußeren" Schleifen werden solange durch geführt, bis die berechnete der gemessenen R –Kurve entspricht. Um die Konvergenz zwischen berechneter und gemessener R- Kurve zu erleichtern, empfiehlt es sich die gemessene R- Kurve mit der Gleichung 4-22 zu fitten (Abbildung 4-17a).

$$K_{R} = K_{10} + C_{0} [1 - \exp(-C_{1}\Delta a)] + C_{2} [1 - \exp(-C_{3}\Delta a)] + C_{4} [1 - \exp(-C_{5}\Delta a)]$$
 4-22

Zur Berechnung der jeweiligen Fit- Kurven, werden die Rissspitzenzähigkeiten, K₁₀, aus Kapitel 3.3.2 verwendet.

Die erhaltene Brückenspannungsverteilung kann nun mit Hilfe eines Brückenspannungsgesetzes gefittet werden. Durch den Fit- Vorrang erhält man die typischen Parameter σ_0 und δ_0 des Brückenspannungsgesetzes. Für den Bereich $\delta \leq 0,3 \mu m$ können die Kurven mit Gleichung 4-23 angenähert werden.

$$\sigma_{Br} \approx \sum \sigma_n \frac{\delta}{\delta_n} \exp\left[-\frac{\delta}{\delta_n}\right]$$
4-23

In Abbildung 4-17a ist die gemessene R- Kurve und die zugehörige FIT- Kurve der Variante MgLa nach Gleichung 4-22 gezeigt. Des Weiteren sind für alle vier Keramiken die gefitteten Brückenspannungen über der Rissöffnungsverschiebung, δ dargestellt (Abbildung 4-17b).



Abbildung 4-17: a) Gemessene und nach Gleichung 4-22 gefittete R- Kurve, b) Brückenspannungsverteilung über der Rissöffnungsverschiebung (FIT- Funktion)

Die FIT- Parameter (σ_n , δ_n) für die Brückenspannungen sind in Tabelle 4-4 zusammengefasst.

Material	-σ ₀ [MPa]	δ ₀ [μm]	-σ ₁ [MPa]	δ ₁ [μm]
MgY	4670	0,0116	325	0,072
MgLa	3375	0,0176	450	0,0476
MgLu	4370	0,0105	700	0,044
AIY	3500	0,0100	200	0,037

Tabelle 4-4: Koeffizienten für die Berechnung des Brückenspannungsgesetzes nach Gleichung 4-23

Die Varianten MgLu und MgY zeigen fast identische Peakspannungen mit ca. 1750 MPa bei einer Rissöffnungsverschiebung von ca. 12 nm. Im Bereich der Rissöffnungsverschiebungen von 50 bis ca. 120 nm zeigt die MgLu Zusammensetzung etwas größere Brückenspannungen als die MgY Variante. Dies kann über den leichten Anstieg der R- Kurve bei größeren Rissverlängerungen der MgLu Variante erklärt werden. Mit einer Peakhöhe von ca. 1300 MPa sind die Varianten MgLa und AlY nahezu übereinstimmend. Jedoch unterscheiden sich die Peaklage und die Peakbreite deutlich. Die MgLa Zusammensetzung zeigt ihren Peak bei Rissöffnungen um 19 nm, die AlY bei ca. 10 nm. Weiterhin weist die MgLa Variante den breitesten Peak aller 4 Varianten auf.

4.3.7 R Kurven (2-dimensionale Risse)

a)

Bei der Bestimmung der R- Kurve von 2- dimensionalen Rissen, d.h. Risse die in zwei Dimensionen (z.B. Probenhöhe und –breite) wachsen können, wurde die Risstiefe, a, in Abhängigkeit der Eindruckkraft, P, bestimmt. Die Risse wurden mit einem Knoopprüfkörper für vier Eindruckkräfte (20 N, 50 N, 100 N, 200 N) erzeugt und anschließend mittels Zielpräparation freigelegt. Die Risstiefe, a, wurde mit dem REM vermessen, um eine maximale Auflösung zu erreichen (Abbildung 4-18a). In Abbildung 4-18b sind die geometrischen Abhängigkeiten des halbelliptischen Risses und der Eigenspannungszone schematisch nach Marshall [Mar-83] dargestellt.



Abbildung 4-18: a) Knoopriss nach der Zielpräparation in der Variante MgY bei einer Eindruckskraft von 200N. b) Schematische Darstellung des halbelliptischen Risses und der Eigenspannungszone nach Marshall [Mar-83]

Die Eigenspannungszone, hervorgerufen durch die plastische Deformation der Keramik unterhalb des Eindringkörpers, hat die Länge $2b_1$ und die Tiefe nach einem Vorschlag von Keer et al. [Kee-86] mit $b_2=b_1/3$. Der Riss an der Oberfläche besitzt die Länge, 2c, und der Eindruck des Knoopprüfkörpers hat die Länge, L. Unter Berücksichtigung der Eigenspannungen kann der Spannungsintensitätsfaktor für den höchstbelasteten Punkt A mit der nachfolgenden Gleichung berechnet werden:

$$K_{A} = \chi \left(\frac{E}{H}\right)^{1/2} \frac{P}{(\pi a)^{3/2}} F_{A} = \chi \left(\frac{E}{H}\right)^{1/2} \frac{P}{(\pi c)^{3/2}} \left(\frac{c}{a}\right)^{3/2} F_{A}$$
 4-24

Der Kalibrierungsfaktor, χ , kann aus Referenzmessungen der Risslängen an Materialien ohne, bzw. mit flacher R- Kurve bestimmt werden. Die weiteren Größen sind der E- Modul, E, und die Knoophärte, H, in GPa. Der Geometriefaktor, F_A, kann wie folgt mit λ =c/b₁ angenähert werden.

$$F_{A} \approx 1,831 \frac{a}{c} - 0,505 + \left(0,624 + 0,385 \frac{a}{c}\right) \exp\left[-\left(1,584 + 0,5388 \frac{a}{c}\right)\sqrt{\lambda - 0,97}\right]$$

$$f \ddot{u}r \ \lambda > 1$$
4-25

Die Größe der Eigenspannungszone konnte nicht ermittelt werden, weswegen auf Werte aus der Literatur zurückgegriffen wurde. Lube [Lub-01] konnte, an gasdruckgesintertem Siliciumnitrid mit 3ma% MgO als Sinteradditiv, die Eigenspannungszone mit einer Größe von $b_1/b_2 \approx 3\pm0,5$ bestimmen. Weiterhin war eine Abschätzung des Verhältnisses der Länge der Eigenspannungszone, 2b₁, zur Eindruckslänge, L, mit 2b₁/L=0,8 möglich.

Abschätzung des Kalibrierungsfaktors χ

Der unbekannte Kalibrierungsfaktor, χ , kann mit Materialien, die keine R- Kurve aufweisen, bestimmt werden. Bei solchen Materialien sollte der Kalibrierungsfaktor unabhängig von der Risslänge sein. Eine Möglichkeit χ zu ermitteln, ist die Messung der Risslänge für unterschiedliche Eindruckkräfte in Glas. Das Materialverhalten von Glas ist jedoch nicht charakteristisch für hoch zähe Keramiken. Aus diesem Grund wurde die MgLu- Variante, mit ihrer sehr steil ansteigenden R- Kurve und dem anschließenden fast waagerechten Plateau, zur Kalibrierung herangezogen. Für die kürzesten erzeugten Knooprisse, von ca. 50 µm, ist die 1-dimensionale R- Kurve der MgLu-Zusammensetzung schon lange auf ihrem Plateauwert ($K_{\rm R}$ - Wert = 7 MPam^{1/2}) und zeigt somit keine Bruchzähigkeitssteigerung bei weiterer Rissverlängerung. Aus dieser Überlegung ergibt sich folgender Wert für χ :

$$\chi \simeq 0.108 \tag{4-26}$$

Die Kurvenbestimmung Rfür 2 dimensionale Risse für die war Zusammensetzung SiY nicht möglich. Es entstanden während der Zielpräparation Ausbrüche von einigen 100 µm an der Oberfläche, wodurch die Messung der Risstiefe nicht möglich war.

Für die anderen vier Varianten wurden die Parameter $2b_1/L = 0.8$ und a/c = 0.85 für eine besser Vergleichbarkeit verwendet. In Abbildung 4-19 zeigt die linke Ordinate die Größe P/(πa)^{3/2} (E/H)^{1/2}F_A ohne den Kalibrierungsfaktor, χ , und die rechte Ordinate die zugehörgien K_R- Werte, die durch Gleichung 4-24 und dem Kalibrierungsfaktor aus Gleichung 4-26 bestimmt wurden.



Abbildung 4-19: 2- dimensionale R- Kurven erzeugt von Knoopeindrücken für alle vier Siliciumnitridvarianten

Alle vier Siliciumnitridvarianten zeigen für die vier Eindruckskräfte einen nahezu horizontalen Verlauf der R- Kurve. Die Anstiege der R- Kurven ausgehend von den intrinsischen Rissspitzenzähigkeiten, K₁₀, konnte nicht festgestellt werden. Die Zusammensetzungen MgY und MgLu weisen ein sehr ähnliches Niveau des Plateauwerts von 7,3 MPam^{1/2} auf. Einen etwas niedrigeren Plateauwert mit ungefähr 6,2 MPam^{1/2} hat das Material MgLa. Den niedrigsten Plateauwert hat die Variante AlY mit einem Wert um 5,3 MPam^{1/2}.

5 Diskussion

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Messungen und Berechnungen der mechanischen Eigenschaften diskutiert. Hauptaugenmerk der Diskussion liegt dabei auf dem Erklärungsversuch der steilen R- Kurven und den daraus resultierenden hohen Brückenspannungen.

Die gemessenen und ausgewerteten R- Kurven zeigen alle einen sehr kurzen Anstiegsbereich von ca. 20 µm, in welchem sie bereits über 80% ihres Plateauwerts erreichen. Am Beispiel der MgLu- Variante ist dies ein Anstieg von $K_{10} = 2,34 \text{ MPam}^{1/2}$ auf 6,8 MPam^{1/2} in 20 µm Rissverlängerung. Bisherige Untersuchungen zu R- Kurvenmessungen an Siliciumnitrid konnten diesen Anstieg mess- und auswertetechnisch nicht auflösen. Dieser steile Anstieg der R- Kurve spiegelt sich auch in den hohen Brückenspannungen von bis zu 1750 MPa wieder. Die Brückenspannungen wirken im gleichen Bereich (bis ~20 µm hinter der Rissspitze), welchen die R- Kurve für ihren Anstieg benötigt. Berücksichtigt man die Mikrostruktur, dann sind nur wenige Kornlagen am Anstieg der R- Kurve beteiligt. Eine Erklärung dieses steilen Anstiegs durch konventionelle Verstärkungsmechanismen, wie Rissablenkung oder Reibbrücken ist nur bedingt möglich. Reibbrücken benötigen funktionsbedingt eine möglichst große Rissöffnung, um darüber einen hinreichend großen Reibweg zu erhalten. Im interessanten Bereich der Rissverlängerungen von 20 µm liegt die Rissöffnung nach Gleichung 4-6 in der Größenordnung von ca. 100 nm.

Im Folgenden wird eine Erklärung gegeben, mit welcher das R- Kurvenverhalten und die hohen Brückenspannungen der gemessenen Siliciumnitridvarianten beschrieben werden kann.

Erklärung für steile R- Kurven und hohe Brückenspannungen

Als Grundlage zur Beschreibung der steilen R- Kurven und den hohen Brückenspannungen dient sowohl die Grenzflächenfestigkeit zwischen β- Si₃N₄ Korn und der Sekundärphase, als auch die Mikrostruktur. Ein Maß für die Grenzflächenfestigkeit ist der kritische Einfallswinkel und die Ablöselänge (Debondinglänge), welche in Kapitel 2.1.2 erläutert wurden.

Die Grenzflächenfestigkeiten für die Varianten MgLa und MgLu wurden von Satet [Sat-02] an oxinitridischen Gläsern gemessen und sind in Abbildung 5-1a dargestellt. Der kritische Einfallswinkel, Okrit, der Lutetium dotierten Variante ist mit 40° um 20° geringer, als der kritische Einfallswinkel der Lanthan dotierten. Ablöselängen bis zu 5 µm sind bei lanthandotierten Die von der Zusammensetzung deutlich länger als bei der lutetiumdotierten Variante. Demnach ist die Grenzflächenfestigkeit der lanthandotierten Variante, aufgrund der größeren Ablöselänge und dem größeren kritischen Einfallswinkel geringer, als die der lutetiumdotierten.

Untersuchungen zur Grenzflächenfestigkeit von Al und Y dotierten Gläsern, mit unterschiedlichen Al/Y- Verhältnissen und Stickstoffgehalten, wurde von Becher et al. [Bec-96] durchgeführt. Jedoch wurde nicht, wie bei Satet [Sat-02], gezielt versucht die Glaszusammensetzung der AIY Variante herzustellen. Aus diesem Grund gibt es keine Messung zur Grenzflächenfestigkeit der AIY Zusammensetzung. Dennoch hat die Glaszusammensetzung mit 20 Equivalentprozent Stickstoff (Abbildung 5-1b) eine sehr große Übereinstimmung mit der Zusammensetzung der AIY- Variante. Der kritische Einfallswinkel, Okrit, betrug in diesem Fall 50°. Für die gleiche Zusammensetzung maß Sun et al. einen Einfallswinkel von 55° [Sun-99]. Bei der weiteren Betrachtung wird der kritischer Einfallswinkel für die AIY Variante auf $\Theta_{krit} = 50^{\circ}$ fest gesetzt. Es ist zu beachten, dass die β- Siliciumnitridkörner beim Wachstum in einer Al und Y dotierten oxinitridischen Schmelze von einer SiAION Schicht umgeben sind und diese auch nach der Herstellung der Gläser weiterhin vorliegt. Dies erschwert den direkten Vergleich der Grenzflächenfestigkeit mit den magnesiumdotierten Zusammensetzungen, welche keine SiAION Schicht aufweisen.



Abbildung 5-1: Ergebnisse von Grenzflächenfestigkeitsmessungen an a) MgLa und MgLu dotierten Gläsern [Sat-02] und b) an Gläsern mit Al/Y als Sinteradditiv und unterschiedlichen Äquivalentprozenten von Stickstoff [Bec-96].

Zur Grenzflächenfestigkeit der MgY Variante gibt es ebenfalls keine Messdaten, jedoch schlussfolgerte Satet [Sat-02] für magnesiumdotierte Gläser, dass mit steigendem Ionenradius der kritische Einfallswinkel zunimmt und somit die Grenzflächenfestigkeit abnimmt. Der Ionenradius von Yttrium (0,89 Å) liegt zwischen Lutetium (0,85 Å) und Lanthan (1,06 Å) [Sat-02]. Für die weitere Diskussion wird für die MgY dotierte Zusammensetzung ein kritischer Einfallswinkel, Θ_{krit} , von 50° angenommen.

Messungen zur Grenzflächenfestigkeit der SiY Zusammensetzung sind nicht bekannt. Das liegt unter anderem daran, dass ohne Zugabe von Mg oder Al kein glasbildender Zusammensetzungsbereich existiert. Da bei dieser Variante die Bestimmung der R- Kurven von 1- dimensionalen und 2- dimensionalen Rissen nicht möglich war, wird sie bei der folgenden Betrachtung nicht weiter berücksichtigt.

In Abhängigkeit des kritischen Einfallswinkels lässt sich der prozentuale Anteil an länglichen Körner abschätzen, die bei Interaktion mit einem Riss brechen ohne davor eine Ablösung der Grenzfläche zu zeigen. Dies lässt sich in Bezug zum Θ_{krit} mit einem sanduhrförmigen Raum innerhalb des kugelförmigen Raums der statistischen Verteilung aller Körner zur Rissebene erklären. Dies ist in Abbildung 5-2a dargestellt, wobei die waagerecht Linie die Rissebene wiedergibt.

Der prozentuale Anteil lässt sich wie folgt berechnen:

$$p = 1 - \sin \Theta_{krit}$$
 5-1

Daraus folgt, dass bei der MgLa- Variante ($\Theta_{krit}=60^{\circ}$) ca. 14% aller stängelförmigen Körner ohne Debonding brechen, bei der MgLu- Variante mit $\Theta_{krit}=40^{\circ}$ ca. 36%. Bei einem angenommenen kritischen Einfallswinkel von 50° ergibt sich ein prozentualer Anteil von 24% für die MgY- Variante. Da die AlY-Variante ebenfalls einen kritischen Einfallswinkel von 50° aufweist, brechen auch bei ihr ca. 24% der stängelförmigen Körner ohne zuvor ein Ablösen der Grenzfläche zu zeigen.



Abbildung 5-2: a) Sanduhrförmiger Raum der Kornorientierung zur Rissebene in dem kein Ablösen der Grenzfläche auftritt. b) Einteilung der R- Kurve in 3 Bereiche in Abhängigkeit der Verstärkungseffekte.

Im Folgenden wird nun der Anstieg der R- Kurve, von der intrinsischen Risszähigkeit bis zum Plateauwert, an Hand von drei Stadien in abstrahierter Weise erklärt. Die drei Stadien sind schematisch in Abbildung 5-2b gezeigt. Um das K- Konzept für die Beschreibung verwenden zu können, werden zur Vereinfachung die E- Moduli der Körner und der Matrix gleich gesetzt. Diese Vereinfachung ist nur notwendig, wenn die Rissspitze direkt mit Phasen unterschiedlicher E- Moduli in Kontakt ist. Das wäre einerseits der Fall beim Übergang des Risses von der Sekundärphase in das Korn oder umgekehrt und andererseits wenn ein Riss entlang eines Siliciumnitridkorns wächst.

Stadium I

Das erste Stadium ist durch die höchste Rate an Risszähigkeitszuwachs pro Rissverlängerung definiert. Im ersten Stadium spielen nur die stängeligen βSi₃N₄ Körner eine Rolle, die keine Grenzflächenablösung zeigen. Um eine vereinfachte Beschreibung zu gewährleisten wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Körner, die in diesen Bereich fallen, genau senkrecht zur Rissebene stehen. Alle anderen Körner und die Sekundärphase bilden eine Matrix, wobei die Risszähigkeit der Matrix deutlich kleiner ist, als die der senkrecht stehenden Körner, K_{IC, β-Korn} > K_{IC, Matrix}. Abbildung 5-3 zeigt eine schematische Darstellung eines von einer Kerbe ausgehenden Risses und senkrecht zur Rissebene stehenden Siliciumnitridkörner.



Abbildung 5-3: Schematisch Darstellung einer Kerbe, Rissfront und Körner die senkrecht zur Rissebene stehen.

Im Folgenden wird für die bessere Darstellung nur der markierte Bereich in Abbildung 5-3 gezeigt. Das jeweils obere Bild zeigt die Draufsicht auf die Rissebene und das untere die Seitenansicht in der Ebene A-A.

	Am Anfang bewegt sich die Rissfront		
	in der Matrix von der Kerbe aus nach		
	Rechts, dies ist bedingt durch die		
	geringere Bruchzähigkeit der Matrix.		
	An den senkrecht stehenden Körnern		
	wird die Rissfront konkav		
	ausgebuchtet. In Bereichen, in denen		
	der Riss vor eilen kann, liegt die		
	Rissfront konvex vor.		
Pingéiogo	Wird nun K weiter erhöht		
niigiisse	verbinden sich die konveyen		
	Ausbuchtungen der Rissfront und es		
	entstehen um die senkrecht		
	stehenden Körner Bingrisse Die		
	primäro Dissfront kann sich daboi		
	weiter von der Kerbe weg bewegen		
	weiter von der Neibe weg bewegen.		
	Die von den Ringrissen umgebenden		
	senkrechtstehenden Körner fungieren		
	nun als Brückenelemente. Bei		
	weiterem Erhöhen von K _{appl} bewegt		
	sich die primäre Rissfront weiter. Die		
	Rissöffnung wird dadurch vergrößert		
	und somit steigt zusätzlich die		
$\stackrel{\lambda}{\longrightarrow}$	Belastung an den als Brücken-		
	elementen dienenden Körnern. Die		
	Körner brechen, sobald ihre Bruch-		
	zähigkeit erreicht ist.		

Abbildung 5-4: Detailzeichnung von Abbildung 5-3. Schematische Darstellung des Rissfortschritts im ersten Stadium

Es entsteht eine konstante Schleppe mit der Länge, λ , aus sich bildenden und brechenden Brückenelementen. Die maximalen Brückenspannungen, die durch

die senkrecht stehenden Körner übertragen werden können, ist durch die Bruchzähigkeit der β - Si₃N₄ Körner bestimmt. Anders ausgedrückt kann kein größerer Spannungsintensitätsfaktor angelegt werden, als die Bruchzähigkeiten der β - Si₃N₄ Körner. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Bruchzähigkeit der β - Si₃N₄ Körner die Höhe der R- Kurve limitiert.

Durch die Bedingung, dass kein größerer Spannungsintensitätsfaktor an der Probe angelegt werden kann, als die als Brückenelemente dienenden Siliciumnitridkörner ertragen können, ist der maximale Plateauwert der R- Kurve $K_{R,max} = 11,5 \text{ MPam}^{1/2}$ (Kapitel 4.3.4). Damit kann im Stadium I eine Bruchzähigkeit von 11,5 MPam^{1/2} als oberer Grenzwert für Siliciumnitridkeramiken angesehen werden.

Stadium II

In Stadium I wurden nur die Körner als Verstärkungselemente berücksichtigt, die keine Ablösung zwischen Korn und Sekundärphase (debonding) zeigen. Dennoch tritt auch im ersten Stadium debonding ein. Der Verstärkungseffekt im Stadium II wird mit Hilfe von Spannungsintensitätsfaktoren erklärt. Trifft ein Riss beim Rissfortschritt auf ein Korn, das unter einem Winkel O< Okrit zur Rissebene geneigt ist (Abbildung 5-5a), wird der Riss am Korn abgelenkt. Unmittelbar nach dem Abknicken des Risses, d.h. bei einer debonding Länge, Idb, gegen Null, fällt der Spannungsintensitätsfaktor an der Rissspitze schlagartig ab (Abbildung 5-5b). Der Abfall des Spannungsintensitätsfaktors, K_I, beim Abknicken eines Risses wurde von Noda und Oda [Nod-92] nummerisch berechnet und liegt je nach Abknickwinkel und Rissgeometrie im einstelligen Prozentbereich. Um den Riss weiter entlang des Korns wachsen zu lassen, muss der Spannungsintensitätsfaktor an der Rissspitze erhöht werden bis der KIC der Grenzfläche erreicht wird. Durch die abgeknickte Rissgeometrie wurde die Struktur im Bereich des abgelenkten Risses "erweicht". Dies führt zu einer größeren Nachgiebigkeit um dieses Korn. Die benachbarten Körner, die kein Grenzflächenablösen zeigen, sind steifer und müssen einen prozentual größeren Anteil der angelegten Spannungen ertragen. Dies führt dazu, dass der von außen angelegte Spannungsintensitätsfaktor, bzw. die angelegte Rissöffungsverschiebung, erhöht werden muss, bis an der Rissspitze des abgeknickten Risses ein kritischer Spannungsintensitätsfaktor erreicht wird. Der Riss wächst dabei solange am Korn weiter, bis entweder die Bruchzähigkeit des Korns an der Rissspitze erreicht wurde und der Riss durch das Korn wächst (Abbildung 5-5c) oder bis das Ende des Korns erreicht ist.



Abbildung 5-5: Ablösevorgang zwischen Korn und Sekundärphase bei Rissfortschritt

Durch das Abfallen des Spannungsintensitätsfaktors beim Abknicken des Risses und der zusätzlichen Entlastung der umgebenden Struktur, setzt der tatsächliche Verstärkungseffekt des Stadiums II erst bei größeren Rissuferverschiebungen ein, folglich bei größeren Rissverlängerungen.

Stadium III

Im dritten und letzten Stadium der Ausbildung von Verstärkungsmechanismen kommt es zu den bekannten Rissflankeneffekten, wie Reibbrücken oder Pullout. Sie tragen, im Verhältnis zu den beiden ersten Stadien, nur einen geringen Anteil zur Verstärkung bei und setzen erst bei deutlich größeren Rissverlängerungen ein.

Eine Abgrenzung der einzelnen Stadien ist beim realen Materialverhalten nicht möglich. Alle Mechanismen der drei Stadien wirken zu jedem Zeitpunkt der Rissverlängerung, jedoch überwiegen die Mechanismen des jeweiligen Stadiums.

Stadium II und III sind umso stärker ausgeprägt, desto weniger Körner ohne eine Grenzflächenablösungen aufzuzeigen brechen, d.h. je größer der kritische Einfallswinkel, Θ_{krit} , ist. Die beiden letzten Stadien zeigen, im Gegensatz zum ersten Stadium, ein größeres zyklisches Ermüdungspotential. In Stadium I ist die Ermüdung der Keramik über das Ermüdungsverhalten der Siliciumnitridkristalle bestimmt. Messungen von Asoo et al. [Aso-00] zum Ermüdungsverhalten von Saphir zeigen tatsächlich keine zyklische Ermüdung. Es kann angenommen

werden, dass Siliciumnitrideinkristalle ebenfalls keine nennenswerte zyklische Ermüdung aufweisen. Die Verstärkungsmechanismen im dritten Stadium werden bei zyklischer Beanspruchung primär über den Verschleiß der sich relativ zueinander bewegenden Reibflächen degradieren. Im zweiten Stadium könnte man sich die Ermüdung über minimale Relativbewegungen der Rissflanken des abgeknickten Risses vorstellen. Dabei wäre je nach Winkel des abgeknickten Risses ein Teil der Relativbewegung in Schubrichtung und würde dadurch die Kontaktflächen polieren.

Allein mit der Hilfe dieser 3 Stadien lassen sich die gemessenen R- Kurven jedoch nicht erklären, da nicht nur die Grenzflächenfestigkeit für das R-Kurvenverhalten relevant ist, sondern auch die Mikrostruktur. Über die Grenzflächenfestigkeit lässt sich somit eine Aussage über die Steigung des Anstiegs der R- Kurve machen. Je größer die Grenzflächenfestigkeit, desto weniger langgestreckte Körner zeigen ein Ablösen der Grenzflächen (Debonding) und können dadurch im ersten Stadium eine größere Spannung übertragen. Die R- Kurve wird demzufolge steiler. Die Größe des Beitrags zum Niveau der R- Kurve nimmt vom ersten Stadium zum dritten deutlich ab. Die Höhe des Plateauwerts kann jedoch nicht ausschließlich über die Grenzflächenfestigkeit erklärt werden.

Zur Beschreibung der Höhe des Plateauwertes der R- Kurve gibt es zwei Erklärungsversuche, die nachfolgend vorgestellt und bewertet werden. Für beide Erklärungen gelten folgende Grundüberlegungen: Die Höhe des Plateauwerts wird durch die Mikrostruktur bestimmt und soll beispielhaft an den Varianten MgY und AIY dargestellt werden. Beide Varianten zeigen den gleichen kritischen Einfallswinkel von 50°, und folglich ist die Steigung des Anstiegs im Stadium I gleich. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt in deren Mikrostruktur, somit ist anzunehmen, dass darüber die Höhe des Plateauwerts vorgegeben wird.



Abbildung 5-6: R- Kurven der Varianten MgY und AIY zeigen unterschiedliche Plateauwerte bei gleicher Steigung im Stadium I

In Abbildung 5-6 sind die R- Kurven im Bereich der ersten 500 μm Rissverlängerung der beiden Varianten zusehen. Der Anstieg im ersten Stadium ist bei beiden Varianten sehr ähnlich, wobei die AIY Zusammensetzung bei 5,5 MPam^{1/2} ihren Plateauwert erreicht und die MgY Keramik erst bei ungefähr 7,5 MPam^{1/2}.

Die erste Erklärungsmöglichkeit bezieht sich auf die Festigkeit der einzelnen Körner. Beide Keramikvarianten besitzen vergleichbare Volumenanteile an Sekundärphase und eine statistische Verteilung der Körner. Dadurch kann folgende Annahme getroffen werden: Die Summe der Querschnittsflächen, der senkrecht stehenden Körner, ist bei beiden Keramiken gleich. Die MgY Zusammensetzung hat mit einem mittleren Korndurchmesser von 110 nm, beim Hauptpeak der Kornlängen- und Streckungsgradverteilung (Kapitel 4.2), etwa halb so dünne, langgestreckte Körner wie die AlY Variante mit einem mittleren Korndurchmesser von 300 nm. Der flächige Anteil an Körnern, die senkrecht zur Rissebene stehen ist dennoch bei beiden Zusammensetzungen gleich. Aufgrund des linear elastischen Verhaltens der Körner kann davon ausgegangen werden, dass die Festigkeit der Körner mit steigendem Volumen abnimmt. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die dünneren Körner der MgY Variante eine höhere kritische Spannung ertragen können als die Körner der AlY Variante. Dies

spiegelt sich in einem weiteren Anstieg der R- Kurve in den Stadium I und II wieder.

Gegen diese erste Erklärung spricht allerdings, dass der von außen eingebrachte Fehler durch den anliegenden Riss, um mehr als eine Größenordnung größer ist, als die Defekte im Siliciumnitridkristall. Somit ist der von außen eingebrachte Fehler immer der bruchauslösende Defekt.

Die zweite Erklärung bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Riss um ein langgestrecktes Korn herum wachsen kann, ohne es zu brechen. Der Streckungsgrad der beiden Keramiken ist mit Werten von 9 für die MgY Zusammensetzung und 3 für die AIY Variante sehr unterschiedlich. Die Kornlänge ist jedoch mit 1 µm nahezu identisch (Kapitel 4.2). Wird ein symmetrischer Körper in einem Zugversuch beansprucht, bildet sich ein homogener Spannungszustand im Körper aus. An den Enden, bei der Krafteinleitung, entsteht jedoch ein inhomogener Spannungszustand. Dies ist durch die schematischen Zeichnungen in Abbildung 5-7 dargestellt, wobei in a) zwei gleich lange Körner mit unterschiedlichem Korndurchmesser und in b) die Verteilung der Schubspannungskomponente für ein Korn gezeigt sind. Die in b) abgebildeten Schubspannungskomponenten wirkt entlang des Korns und sind aus Symmetriegründen in der Mitte des Korns Null. An den Kornenden steigen die Schubspannungen an und führen dazu, dass ein Riss, der in diesem Bereich senkrecht auf ein Korn trifft, zu den Kornenden hin abgelenkt wird und innerhalb der Grenzflächen weiter wachsen kann. Den Bereich in dem es zu einem schubspannungsbedingten Abknicken eines Risses kommen kann, beträgt etwa ein Kornradius.



Abbildung 5-7: a) Schematische Darstellung zweier gleichlanger aber unterschiedlich dünner Körner, b) Schubspannungsverlauf entlang eines Siliciumnitridkorns

Somit kann mit den geometrischen Eigenschaften der Körner (Durchmesser und Länge) eine Aussage getroffen werden, über die Höhe der Wahrscheinlichkeit, dass ein Riss um das Korn laufen kann oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Riss **nicht** um ein Korn laufen kann, sei folgendermaßen definiert:

$$P \approx \frac{l - 2\frac{d}{2}}{l} = 1 - \frac{d}{l} = 1 - \frac{1}{SG}$$
 5-2

In der Wahrscheinlichkeitsberechnung Formel 5-2 entspricht *l* der Kornlänge, d dem Korndurchmesser und SG dem Streckungsgrad. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Riss nicht um ein Korn wachsen kann alleine vom Streckungsgrad abhängig. Am Beispiel der beiden Varianten MgY und AlY ergeben sich die Wahrscheinlichkeiten: $P_{MgY} = 89\%$ und $P_{AIY} = 67\%$. Im Fall der MgY Variante existieren 33% mehr Körner als in der AlY Zusammensetzung, die nicht vom Riss umwachsen werden können und somit den in Stadium I beschriebenen Beitrag zur R- Kurve bringen. Das Verhältnis der beiden Wahrscheinlichkeiten zueinander beträgt $P_{MgY}/P_{AIY} = 1,33$ und entspricht dem Verhältnis der Plateauwerte $K_{R,max,MgY}/K_{R,max,AIY} = 1,36$. Die zweite Erklärung liefert anschauliche Werte, die direkt durch einen Vergleich der Plateauwerte überprüfbar sind. Die Plausibilität dieser zweiten Erklärung wird auch durch den Vergleich der AIY zur MgLu Zusammensetzung bestätigt. Die Verhältnisse P_{MgLu}/P_{AIY} mit 1,28 und das der Plateauwerte $K_{R,max,MgLu}/K_{R,max,AIY}$ mit 1,27 zeigen ebenfalls eine hohe Übereinstimmung.

Mit Hilfe dieser Überlegung lässt sich die Höhe des Plateauwerts bei allen 4 Zusammensetzungen erklären. Für die magnesiumdotierten Varianten liegt eine vergleichbare Mikrostruktur vor, wodurch alle Unterschiede der R- Kurven durch die 3 Stadien beschrieben werden können. Die MgLa- Zusammensetzung hat die geringste Grenzflächenfestigkeit und demnach den flachsten primären Anstieg (Stadium I). Durch die geringere Korngrenzfestigkeit erhöht sich der Beitrag des zweiten und dritten Stadiums zum R- Kurvenanstieg. Die MgLa Zusammensetzung zeigt einen deutlichen Anstieg der R- Kurve in den beiden letzten Stadien. Im Bereich von 20 µm bis 1 mm Rissverlängerung steigt sie von 6,5 MPam^{1/2} bis auf über 8 MPam^{1/2} an.

Die MgLu und MgY Varianten, mit ihrer höheren Grenzflächenfestigkeit, zeigen einen ausgeprägteren ersten Anstieg und anschließend einen flacheren Verlauf der R- Kurve, als die MgLa Zusammensetzung. Dieser prinzipielle Verlauf der R-Kurve konnte im Experiment bestätigt werden. Die MgLu Zusammensetzung sollte, mit ihrer etwas größeren Grenzflächenfestigkeit, den steilsten Anstieg und einen flachen Verlauf in den Stadien II und III aufzeigen. Dies konnte in den Experimenten zur R- Kurvenmessung bei 1- dimensionalen Rissen nicht beobachtet werden. Überraschenderweise zeigt die MgY Variante den steilsten Anstieg im ersten Stadium und beendet diesen ca. 0,5 MPam^{1/2} höher, bei 6,8 MPam^{1/2}, als die MgLu Zusammensetzung. Der leicht steilere Anstieg der Rerklärt Kurve der MgY Variante kann darüber werden, dass die Grenzflächenfestigkeit, nicht wie zuvor postuliert, kleiner als die der MgLu Variante ist. Die Vermutung, dass die Grenzflächenfestigkeit mit steigendem Ionenradius abnimmt, konnte in diesem Experiment nicht bestätigt werden. Es kann daraus gefolgert werden, dass der kritische Einfallswinkel der MgY Variante nicht größer, sondern kleiner als der, der MgLu Variante sein muss. Der niedrigere Plateauwert der MgLu Variante kann über die Mikrostruktur erklärt werden. Bei Betrachtung der Mikrostrukturauswertung ergibt sich ein

Streckungsgrad von 7 für die MgLu Variante und einer von 9 für MgY Zusammensetzung. Unter Verwendung der zweiten Hypothese ergeben sich für die Varianten MgY und MgLu folgende Verhältnisse $P_{MgY}/P_{MgLu} = 1,03$ und $K_{R,max,MgY}/K_{R,max,MgLu} = 1,07$.

Man kann nur spekulieren, aus welchem Grund kein stabiles Risswachstum bei der SiY Variante möglich war. Durch die Bruchzähigkeitsmessung ist bekannt, dass der Plateauwert im Bereich von 2,7 bis 3,6 MPam^{1/2} liegen muss, wenn die Zusammensetzung bei Rissverlängerungen bis 1 mm ein Plateau aufweist. Mit der Rissspitzenzähigkeit, K₁₀, von 2,44 MPam^{1/2} ist der Anstieg der R- Kurve auf ca. 1,2 MPam^{1/2} begrenzt und fällt im Vergleich zur AIY Zusammensetzung, mit einem Brückenspannungsintensitätsfaktor von ca. 4 MPam^{1/2}, sehr gering aus. Die Grenzflächenfestigkeit dieser Zusammensetzung wurde bisher nicht bestimmt und es kann somit nur spekuliert werden, wie groß der kritische Einfallswinkel, O_{krit}, ist. Beachtet man die charakteristische Festigkeit von 621 MPa und setzt voraus, dass die Defektgröße vergleichbar mit den magnesiumdotierten Zusammensetzungen ist, muss die R- Kurve im Stadium I steil angesteigen, damit sich diese Festigkeit ergibt.

Da die Brückenspannungen eine direkte Ableitung der R- Kurve darstellen, kann daraus schlussgefolgert werden, je steiler und höher die R- Kurve im Anfangsbereich (Stadium I) ist, desto höher fallen die Brückenspannungen aus. Die beiden magnesiumdotierten Varianten MgY und MgLu zeigen den steilsten Anstieg der R-Kurve und erreichen K_R- Werte von 6,5 MPam^{1/2} nach nur 10-20 µm Rissverlängerung. Damit die R- Kurve so schnell von ihrem Startwert, K₁₀, ansteigen kann, müssen hohe Spannungen über die Verstärkungsmechanismen übertragen werden. Die erreichten hohen Brückenspannungen von 1750 MPa der beiden Varianten MgY und MgLu bedingen sich durch den steilen Anstieg der R- Kurve bei sehr kurzen Rissverlängerungen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass bei den Berechnungen der Brückenspannung in Kapitel 4.3.6 keine Annahmen zum Verlauf der Brückenspannungen, bzw. kein Brückenspannungsgesetz vorgegeben Die wurde. im Vergleich zu Literaturangaben sehr hohen Brückenspannungen haben verschiedene Ursachen.

Einerseits gibt es nur sehr wenige, bzw. keine Experimente zu R-Kurvenmessungen an Siliciumnitrid, die den Anfangsbereich (Stadium I) der ersten 10 µm Rissverlängerung auflösen konnten. R- Kurvenmessungen von Pezzotti al. [Pez-99][Pez-01] zeigen Messpunkte et erste bei Rissverlängerungen von ca. 100 µm. Die Brückenspannungen die parallel, zu den R-Kurvenmessungen mittels Raman- Spektroskopie gemessen wurden, zeigten jedoch ebenfalls Spitzenwerte von bis zu 1 GPa. Durch die Größe des Laserbrennflecks bei der Ramanspektroskopie kommt es zu einer Mittelwertbildung und dadurch zu geringeren Spannungen.

Andererseits wird der Brückenspannungsintensitätsfaktor zur Bestimmung der Brückenspannungen benötigt. Der Brückenspannungsintensitätsfaktor lässt sich nach Gleichung 4-16 aus dem K_B- Wert und der Rissspitzenzähgikeit, K_{I0}, bestimmen. Ist die Rissspitzenzähigkeit nicht bekannt und es wird auf den niedrigsten, bzw. ersten Wert der R- zurückgegriffen, dann wird der Brückenspannungsintensitätsfaktor unterschätzt. Demzufolge fallen die so bestimmten Brückenspannungen zu niedrig aus. Experimente Rzu Kurvenmessungen an Siliciumnitridkeramiken von Maniette [Man-91], zeigen einen R- Kurvenverlauf über eine Rissverlängerung von ca. 1 mm mit einem Startwert von 4,3 MPam^{1/2} und einen Plateauwert von 6,5 MPam^{1/2}. Die daraus berechneten Brückenspannungen weisen eine Peakspannung von 90 MPa auf. Dennoch zeigt das Brückenspannungsgesetz einen ähnlichen Verlauf, wie die in dieser Arbeit bestimmten Brückenspannungen.

Hätte man bei der Brückenspannungsberechnung der 4 Siliciumnitridvarianten ebenfalls die niedrigsten K_{R} - Werte der korrigierten R- Kurven verwendet und nicht die Rissspitzenzähigkeit, so wären die Brückenspannungen nur ca. halb so groß. Die niedrigsten K_{R} - Werte lagen nach der Korrektur der Kraft- und Durchbiegungswerte im Bereich von 3,3 bis 4,5 MPam^{1/2}.

Vorhersagen von R- Kurven

Wie schon in Kapitel 2.2 beschrieben, ist das Brückenspannungsgesetz das einzige Materialgesetz, welches von der Geometrie (Probe und Riss) und der Belastung unabhängig ist. Es lässt sich jedoch nicht direkt auf einen Belastungsfall anwenden, um daraus ein Materialverhalten vorhersagen zu können. Dies ist allerdings möglich, indem man das Brückenspannungsgesetz verwendet, um R- Kurven für einen Belastungsfall vorher zu sagen. Das Vorhersagen einer R-Kurve wird hier anhand der Brückenspannungen der R-Kurve von 1- dimensionalen Rissen beschrieben. Die R- Kurve lässt sich mit Formel 4-16 beschreiben, wobei die Rissspitzenzähigkeit, K₁₀, als unabhängig vom Belastungsfall angesehen wird. Somit wird der Verlauf der R- Kurve durch den Brückenspannungsintensitätsfaktor, K_{br}, bestimmt. Dieser lässt sich über die Brückenspannungen und die Gewichtsfunktion, h(x,a), berechnen. Da die Brückenspannungen vom Belastungsfall unabhängig sind, lassen sich die R-Kurven über die Verwendung der jeweiligen Gewichtsfunktion vorhersagen. Dies soll hier am Beispiel von 2- dimensionalen Rissen gezeigt werden. Risse, die in 2 Dimensionen wachsen können, geben das R- Kurvenverhalten bei Rissverlängerung von natürlichen Rissen besser wieder, als R- Kurven, die an Makrorissen (Kerben mit 1- dimensionalem Risswachstum) bestimmt wurden. Der notwendige Brückenspannungsintensitätsfaktor, K_{br}, kann mit Hilfe der Gleichung 2-12 unter Verwendung der zuvor bestimmten Brückenspannungen und der Gewichtsfunktion für 2- dimensionale Risse bestimmt werden. Eine Gewichtsfunktion für 2- dimensionale, halbkreisförmige Risse, kann wie folgt beschrieben werden [Fet-97]:

$$h_{halbkreis} = \frac{2r[1+c(1-r/a)]}{\sqrt{\pi a(a^2+r^2)}} \text{ mit } c = \frac{0,04+0,104(1-\sin\varphi)^2}{1-\frac{\pi}{4}}$$
5-3

Die geometrischen Abhängigkeiten sind in Abbildung 5-8a dargestellt, wobei r, den Abstand eines beliebigen Punktes, ϕ dem Winkel und a der Risstiefe, bzw. dem Rissradius entspricht.



Abbildung 5-8: a) Geometrische Abhängigkeiten eines halbkreisförmigen Risses b) Vergleich der R- Kurven von 1- dimensionalen und 2- dimensionalen Rissen

Die berechneten R- Kurven für die Varianten MgLu und AIY sind in Abbildung 5-8b gezeigt (Punktlinie). Zum Vergleich sind die gefitteten R- Kurven der 1dimensionalen Risse mit eingeblendet (Volllinie). Der Fit der 1 dimensionalen R-Kurven wurde mit Hilfe von Gleichung 4-22 berechnet. Die beiden 2dimensionalen R- Kurven zeigen einen flacheren Anstieg zum Plateauwert als 1- dimensionalen R- Kurven. Dieser wird nach 75 bis die 125 µm Rissverlängerung erreicht. Ergebnisse aus der Literatur zu 1- dimensionalen R-Kurven halbkreisförmigen Rissen (natürliche Risse) zeigen und bei Aluminiumoxid einen viel deutlicheren Unterschied zwischen den beiden R-Kurven [Fet-92a]. Dies ergibt sich über den prinzipiellen Verlauf der R- Kurve. Es gilt, je steiler die R- Kurven von 1- dimensionalen Rissen, desto schneller steigen die R- Kurven der 2- dimensionalen Risse an. Die von Fett et al. [Fet-92a] gemessene R- Kurve an Al₂O₃ zeigt einen sehr flachen Verlauf der R-Kurve von 1- dimensionalen Rissen, somit steigt die R- Kurve der natürlichen Rissen noch langsamer an. Bei den hier gemessenen R- Kurven an Siliciumnitrid steigen die R- Kurven sehr schnell an, weshalb die Abweichungen der beiden R-Kurven zu einander sehr gering sind.

Die experimentellen Ergebnisse der R- Kurven von 2- dimensionalen Rissen (Knoop) sind ebenfalls in Abbildung 5-8b zu sehen und zeigen ein ähnliches Niveau, wie die vorhergesagten R- Kurven. Die Abweichungen der experimentellen Ergebnisse zu den berechneten können verschiedene Ursachen haben. Einerseits ist die Messung der Risslängen bei den Knooprissen äußerst schwierig, da diese im Gegensatz zu den Vickersrissen, nicht die maximale Rissöffnung durch das Eigenspannungsfeld aufweisen. Die Rissöffnung nach dem Eindruck beträgt nur ca.1/3 der Öffnung während der Risswachstumsphase. Anderseits konnte bei den 4 verwendeten Siliciumnitridvarianten die Eigenspannungszone (b₁ & b₂), sowie das Rissverhältnis a/c der Knooprisse nicht bestimmt werden. Auch unter Verwendung von Farbeindringmitteln (Methylenblau oder Met-L-Check 2000, Helling) konnte die Risskontur nicht dargestellt werden. Aus diesen Gründen wurde zur Berechnung der Spannungsintensitätsfaktoren der Knooprisse auf Werte aus der Literatur zurück gegriffen, welche jedoch nicht vollständig das Werkstoffverhalten, der hier verwendeten Keramiken, widerspiegeln müssen.

Rissspitzenzähigkeit

Die Rissspitzenzähigkeiten der einzelnen Varianten liegen im Bereich von 1,86 bis 2,44 MPam^{1/2}. Die Auswertung des Rissuferverschiebungsfelds erfolgte bei den jeweiligen Zusammensetzungen an jeweils einem Riss. Eine statistische Absicherung durch das Vermessen von mehreren Rissen wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchgeführt. Somit ist eine klare Aussage darüber, welche Variante tatsächlich die höchste oder die niedrigste Rissspitzenzähigkeit hat nicht möglich.

Das gemessene Rissuferverschiebungsfeld, wie in Kapitel 4.3.6 beschrieben, ist von den Brückenspannungen beeinflusst. Besitzt eine Keramik eine R- Kurve, dann verkleinert sich die angelegte Rissöffnung, $2\delta_{appl}$, durch die wirkenden Brückenspannungen. Dies ist schematische in Abbildung 5-9a dargestellt, wobei r den Abstand zur Rissspitze wiedergibt und δ die tatsächlich gemessene Rissöffnungverschiebung.



Abbildung 5-9: a) Allgemeine Darstellung der Rissöffnung in Abhängigkeit der Entfernung zur Rissspitze, b) totale Rissöffnung bei Vickersrissen für K_{I0} und K_{max} , sowie zu erwartender Verlauf der Messpunkte

Rissöffnungsverschiebungsfeld von Vickersrissen weicht durch die Das wirkenden Eigenspannungen vom parabelförmigen Verlauf (Abbildung 5-9a) ab. Außerdem beeinflusst der R- Kurveneffekt auch die Rissöffnung von Vickersrissen. Der Einfluss der R- Kurve auf die Rissuferverschiebung ist in Abbildung 5-9b schematisch an der Variante MgLa gezeigt. Die beiden Volllinien geben den Verlauf der totalen Rissöffnung, 25, über dem Abstand zur Rissspitze, für konstante Spannungsintensitätsfaktoren wieder und wurden mit Hilfe der Gleichung 4-2 berechnet. Die untere Kurve zeigt den Verlauf mit der $(1.95 \text{ MPam}^{1/2})$ Rissspitzenzähigkeit und der mit obere einem Spannungsintensitätsfaktor nahe dem Plateauwert (6,5 MPam^{1/2}). Das reale Verschiebungsprofil bei Keramiken mit R- Kurvenverhalten, liegt zwischen den beiden Extremen und folgt zuerst bei r→0 der unteren Kurve und nähert sich bei größeren Abständen zur Rissspitze der oberen Kurve an. Dies ist schematisch durch die Punkte in Abbildung 5-9 gezeigt.

Die Rissuferverschiebung nahe der Rissspitze, $r \rightarrow 0$, ist jedoch von den Brückenspannungen nicht betroffen, d.h. die Kurven für K₁₀ und die der gemessenen Messpunkte sind anfänglich identisch. Das hat zur Folge, dass die Rissspitzenzähigkeit mit der Irwingleichung 4-6 bestimmt werden kann, solange genügend Messpunkte im Nahfeld der Rissspitze vorhanden sind. Bei den vermessenen Siliciumnitrid- Varianten waren die Abstände zur Rissspitze, in dem die Irwingleichung anwendbar war, kleiner 2µm.

Festigkeit – R- Kurve

Die Tatsache, dass die R- Kurve und die Defektgröße (Startriss) die Festigkeit von spröden Materialien bestimmen, wurde in Kapitel 2.2.1 gezeigt und erklärt. Im Folgenden sollen die Festigkeiten der fünf Siliciumnitrid- Varianten in Abhängigkeit der R- Kurve und Defektgröße diskutiert werden.

Die Defektgrößen wurden einerseits auf den Bruchflächen vermessen und andererseits mit Hilfe der R- Kurven und den Bruchfestigkeiten berechnet. Hierfür wurden alle gemessenen R- Kurven von 1- dimensionalen Rissen mit Gleichung 4-22 gefittet. Für die Berechnungen der natürlichen Defektgrößen wären die R- Kurven für 2- dimensionale Risse besser geeignet, jedoch liegen für diese R- Kurven keine Messergebnisse im Anstiegsbereich vor. Aus diesem Grund wurde auch nicht auf die berechnete R- Kurve (R- Kurvenvorhersage) zurück gegriffen.

Um die Variante SiY mit in die Diskussion einbinden zu können, wurde die R-Kurve dieser Variante mit Hilfe der Formel 2-20 berechnet. Darin enthalten ist die gemessene Rissspitzenzähigkeit, $K_{I0} = 2,44$ MPam^{1/2}, und K_{max} wurde mit der Bruchzähigkeit, $K_{IC} = 3,95$ MPam^{1/2}, gleich gesetzt. Der Wert des Faktors zur Normierung der Risslänge, λ , wurde mit 20 µm angenommen, wodurch der Anstieg der R- Kurve in 20 µm erfolgte.

Die Defektgröße aller Varianten wurde für jeweils 2 ausgewählte, repräsentative Konfidenzintervallsgrenzen Bruchspannungen, den 90%der Festigkeitsverteilungen, zugehörigen R-Kurven und den über die Tangentenbedingung bestimmt. Die obere Konfidenzintervallsgrenze ist mit σ_0 und die untere mit σ_u bezeichnet. Die Berechnung und graphische Darstellung der Defektgrößenbestimmung wurde mit dem Programm "Mathematica" durchgeführt. Der Verlauf des Spannungsintensitätsfaktors, Kappl, wurde unter Verwendung von Gleichung 2-5 mit den beiden Bruchspannungen σ_u und σ_o berechnet. Zum einfacheren Vergleichen der Ergebnisse wurde bei allen Varianten und für beide Spannungen ($\sigma_o \& \sigma_u$) ein halbkreisförmiger Oberflächenriss mit einem Geometriefaktor, Y = 1,3, angenommen. Abbildung 5-10a-e zeigt die graphische Auswertung der Defektgrößenbestimmung, in Tabelle 5-1 sind die Ergebnisse zusammengefasst.

88



Abbildung 5-10: a)-d) gefitteten R- Kurven und der Spannungsintensitätsfaktorverlauf der 90%- Konfidenzintervallsgrenzen (die Volllinie ist σ_u und die gestrichelte σ_o); e) Die berechnete R- Kurve der SiY Variante und den zugehörigen Bruchspannungen. f) Die R- Kurve der MgLu-Variante mit der Spannung der Bruchzähigkeitsbestimmung (SEVNB)

Die Verläufe der anliegenden Spannungsintensitätsfaktoren, K_{appl} , in Abbildung 5-10a-e sind jeweils in einer Volllinie für die untere und gestrichelt für die obere Konfidenzintervallsgrenze gehalten.

In Tabelle 5-1 sind für jede Zusammensetzung und den zugehörigen Bruchspannungen die K_R- Werte des Schnittpunktes von K_{appl} mit der R- Kurve, die Anfangsrisslängen (Defektgröße), a_0 , und die stabilen Rissverlängerungen, Δa , angegeben.

		MgY	MgLa	MgLu	AIY	SiY
	$K_R [MPam^{1/2}]$	6,7	5,6	6,21	4,9	3,8
σ_{u}	a₀ [µm]	23,9	13,4	20,0	10,4	19,2
	∆a [µm]	4,2	6,24	5,2	3,8	4,5
	K _R [MPam ^{1/2}]	6,7	5,41	6,12	4,9	3,8
σ _o	a₀ [µm]	20,5	10,6	16,4	8,8	16,0
	∆a [µm]	3,8	5,1	4,5	3,4	4,2

Tabelle 5-1: Ergebnisse der Tangentenbedinung der R- Kurven mit dem K_{appl} -Verlauf der 90%- Konfidentintervallsgrenzen

Bezogen auf die untere Bruchspannung, σ_u , ist die Anfangsrissgröße (Defektgröße) für die Varianten MgY, MgLu und SiY mit ungefähr 21 µm sehr ähnlich, wobei die Defektgröße der Variante MgLa mit 13,4 µm deutlich kleiner ist und in der Größenordnung der Defektgröße der kommerziellen Variante AlY liegt. Bei der Spannung der oberen Konfidenzintervallsgrenze verhält es sich ähnlich wie beim unteren, nur dass die Defektgrößen etwas kleiner aus fallen. Interessant ist bei dieser Darstellung der Verknüpfung von Bruchfestigkeit und R- Kurve, dass die stabile Rissverlängerung, Δa , mit ca. 5µm bei allen Varianten sehr gering ist.

Die am IKM hergestellten Varianten bieten hinsichtlich ihrer Anfangsrissgröße noch Entwicklungspotential. Würde man durch einen optimierten Herstellungsprozess die Defektgröße auf das Niveau der kommerziellen Variante bringen können, so könnten die Bruchfestigkeiten drastisch erhöht werden. Am Beispiel der MgY Variante würde die Bruchspannung der unteren Konfidenzintervallsgrenze von 980 MPa auf ungefähr 1350 MPa ansteigen und die der oberen von 1044 MPa auf ca. 1500 MPa.

In Abbildung 5-10f ist der Spannungsverlauf für einen Bruchzähigkeitstest mit der SEVNB- Methode für die Zusammensetzung MgLu gezeigt. Hierbei wurde die Bruchspannung des Experiments mit 103 MPa und den zugehörigen Geometriefaktor mit Y = 1,95 vorgegeben. Die Anfangsrisslänge, a_0 , die durch die Berechnung der Tangentenbedingung erhalten wurde, liegt mit 1107 µm nur ca. 47 µm über der gemessen Kerbtiefe. Der Fehler liegt somit unter 5%.

Interessant ist auch hier, dass der Tangentenpunkt schon nach ca. 24 µm Rissverlängerung erreicht wurde.

Zur Bestimmung der Werte in Tabelle 5-1 und der Graphen in Abbildung 5-10a-e wurde die Annahme getroffen, dass die bruchauslösenden Defekte halbkreisförmige Oberflächenrisse sind. Volumendefekte mit Saumriss oder oberflächennahe Defekte wurden nicht berücksichtigt. Die Berechnung des jeweils am Riss anliegenden Spannungsintensitätsfaktors ist äußerst kompliziert. Zudem würde dies den Vergleich der einzelnen Varianten untereinander erschweren. Um dennoch die Annahme zu überprüfen, wurde eine Bruchfläche der Variante MgLu mit oberflächennahem Defekt ausgewertet. In Abhängigkeit der Bruchspannung (706 MPa) wurde die "Anfangsrissgröße", a0.ber., mit der zuvor beschriebenen Methode berechnet. Die, auf der Bruchfläche gemessene Anfangsrissgröße, a_{0.gem}, ist mit ca. 40 µm, 2µm kleiner als die Berechnete. Der bruchauslösende Defekt ist in Abbildung 5-11 mit den gemessenen und berechneten Defektgrößen gezeigt.



Abbildung 5-11: Bruchauslösender Defekt in der Variante MgLu

6 Zusammenfassung

Siliciumnitrid ist eine Strukturkeramik, welche bei großen mechanischen Belastungen, wie dem Drahtwalzen oder in Kugellagern eingesetzt wird. Zur Optimierung der mechanischen Eigenschaften für die jeweiligen Anwendungen, ist eine genaue Kenntnis des Werkstoffverhaltens notwendig. In dieser Arbeit wurden 5 Siliciumnitrid Varianten hinsichtlich ihrer mechanischen Kenngrößen untersucht. Die jeweiligen Bezeichnungen der Keramiken leiten sich von den verwendeten Sinteradditiven ab. Die Varianten MgY, MgLa, MgLu und SiY wurden mit einem Sinter/HIP Verfahren am Institut für Keramik im Maschinenbau (IKM) hergestellt, wobei die Variante AlY eine kommerzielle Keramik der Firma CeramTec AG mit der Bezeichnung SL200 BG ist. Das Hauptaugenmerk der Versuche lag auf dem R- Kurvenverhalten der jeweiligen Keramiken. Die R-Kurven konnten bei den Varianten MgY, MgLa, MgLu und AlY für 1dimensionale und 2- dimensionale Risse gemessen werden. Die Variante SiY besitzt ein sehr sprödes Werkstoffverhalten und es war nicht möglich deren R-Kurven zu messen.

Die vier übrigen Siliciumnitrid- Zusammensetzungen zeigen einen sehr steilen Anstieg der R- Kurven von der Rissspitzenzähigkeit, K_{I0}, bis hin zum Plateauwert, sowohl bei den 1- dimensionalen, als auch bei den 2dimensionalen Rissen. Nach nur 10 bis 20 µm Rissverlängerung wurde bei allen Varianten über 80% des Anstiegs zum Plateauwert bei R- Kurven von 1 dimensionalen Rissen zurückgelegt. Die Experimente zur Bestimmung der R-Kurve für 1- dimensionale Risse wurden in einem sehr steifen Lastrahmen mit einer 4 Punktbiegevorrichtung und gekerbten Proben durchgeführt. Das Darstellen des Anstiegs war mit der konventionellen Methode, welche die Risslänge mit einem optischen Mikroskop bestimmt, nicht möglich.

Aus diesem Grund wurde eine Methode zur Korrektur der Kraft- und Durchbiegungswerte des Versuchs (Langrisslösung & Kerbeinfluss) zur Berechnung der Risslängen entwickelt und angewandt. Dadurch konnte der "tatsächlich" anliegende Spannungsintensitätsfaktor berechnet werden und der Anstieg der R- Kurve abgebildet werden. Diese hochauflösende Abbildung des Anstiegs der R- Kurve war bisher bei Siliciumnitrid nicht möglich Nach Rissverlängerungen von mehr als $20 \,\mu m$ (~2xKerbradius) konnte die konventionelle Methode zur Bestimmung der R- Kurve wieder verwendet werden. Die erreichten Plateauwerte lagen zwischen 5,5 MPam^{1/2} für die AlY Variante und 8 MPam^{1/2} für die MgY Zusammensetzung.

Der Startwert der R- Kurve wurde anhand von Rissöffnungsmessungen (COD) berechnet. Hierfür wurden Risse in den Keramiken mit einem Vickersprüfkörper erzeugt. Anhand dieser Risse wurde die Rissöffnung in Abhängigkeit des Abstandes zur Rissspitze bestimmt und daraus die Rissspitzenzähigkeit berechnet. Die Werte für die Rissspitzenzähigkeit lagen zwischen 1,86 MPam^{1/2} und 2,44 MPam^{1/2}.

Der sehr steile Anstieg der R- Kurve kann nur erfolgen, wenn die Brückenspannungen hohe Werte zur Abschirmung der Rissspitze von der äußeren Belastung aufweisen. Die Brückenspannungen wurden direkt aus den korrigierten R- Kurven, ohne Vorgabe eines Brückenspannungsgesetzes, berechnet. Die typischen Brückenspannungsparameter, σ_0 und δ_0 , konnten durch einen Fit der zuvor berechneten Spannungsverteilung ermittelt werden. Im Gegensatz zu den R- Kurven ist das Brückenspannungsgesetz von der Belastung, der Geometrie der Probe und des Risses unabhängig. Die erreichten maximalen Brückenspannungen lagen zwischen 1300 MPa für die MgLa Variante und 1750 MPa für die MgLu Zusammensetzung.

Die Brückenspannungen wurden des Weiteren verwendet um eine R- Kurve, unter Verwendung einer der Belastung entsprechenden Gewichtsfunktion, vorherzusagen. In diesem Fall wurde eine R- Kurve für 2- dimensionale Risse berechnet und mit Experimenten an Rissen von Knoopeindrücken überprüft. Es konnte eine gute Übereinstimmung des Plateauwerts festgestellt werden, jedoch konnte in diesen Versuchen der Anstieg der R- Kurve experimentell nicht verifiziert werden.

Des Weiteren wurde ein neuer Erklärungsversuch für die sehr steil ansteigenden R- Kurven an Hand von drei Stadien gegeben. Als Grundlage der Beschreibung diente die Grenzflächenfestigkeit zwischen dem Siliciumnitridkorn und der Korngrenzphase (Sekundärphase). Das erste Stadium trägt am meisten zum Anstieg bei und ist dominiert durch Siliciumnitridkörner, die senkrecht zur
Rissebene stehen und ohne ein Ablösen der Grenzfläche (Debonding) zu zeigen die Rissflächen überbrücken. Im zweiten Stadium werden die Siliciumnitridkörner als Verstärkungsmechanismen aktiviert, die im Stadium I ein Ablösen der Grenzfläche aufzeigten. Das dritte Stadium weist die bekannten Verstärkungsmechanismen wie Reibbrücken oder Pull- out auf. Der Winkel des Anstiegs im ersten Stadium ist über die Grenzflächenfestigkeit bestimmt. Je größer die Grenzflächenfestigkeit, desto mehr Körner zeigen kein Ablösen der Grenzflächen und können somit als Brücken dienen.

Die Höhe des Plateauwerts kann jedoch nicht alleine über die drei Stadien erklärt werden. Eine Möglichkeit zur Beschreibung der Höhe des Plateauwerts liefert die Mikrostruktur, d.h. vor allem die Streckungsgradverteilung. Bei Siliciumnitridkörnern mit gleicher Kornlänge aber unterschiedlichem Streckungsgrad, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Riss um ein Korn wachsen kann ohne es zu brechen (Stadium I) mit steigendem Streckungsgrad. Je größer der Streckungsgrad bei gleicher Kornlänge, desto mehr Körner tragen zum Stadium I bei.

Es konnte des Weiteren aufgezeigt werden, dass es für Siliciumnitridkeramiken einen oberen Grenzwert für die Bruchzähigkeit gibt. Wie zuvor beschrieben, hängt die Höhe des Plateauwerts einerseits vom Streckungsgrad der Körner ab, und andererseits auch von der Bruchzähigkeit der Siliciumnitridkörner im ersten Stadium. Es kann kein größerer Spannungsintensitätsfaktor an der Probe angelegt werden, als die einzelnen Körner, die als Brückenelemente dienen, ertragen können. Mittels COD- Messungen an Vickersrissen, die in Siliciumnitridkörnern endeten, konnte die Bruchzähigkeit der Körner in Abhängigkeit ihrer Orientierung bestimmt werden. Die maximale Bruchzähigkeit wurde senkrecht zur c- Achse mit 11,5 MPam^{1/2} bestimmt und dient somit als obere Grenze der zu erreichenden Bruchzähigkeit im ersten Stadium in Siliciumnitridkeramiken.

Über den maximal erreichbaren Plateauwert der R- Kurve von 11,5 MPam^{1/2} und einer Defektgröße im Bereich der AIY Variante (~10 µm) lässt sich eine obere Festigkeitsgrenze von 2200 MPa für Siliciumnitrid abschätzen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass eine steile R- Kurve mit hohem Plateauwert in der Siliciumnitridkeramik erwünscht ist. Dies kann über eine starke Grenzflächenfestigkeit und Siliciumnitridkörner mit hohem Streckungsgrad erreicht werden kann.

A. Anhang

Die Berechnung der Brückenspannungen aus den R- Kurven erfordert einen große Rechenaufwand und ist zudem äußerst komplex. Eine Möglichkeit zur Abschätzung der Brückenspannungen, genauer gesagt deren prinzipiellen Verlauf und die ungefähre Peakhöhe, ist eine Näherung Erster- und Zweiter Ordnung. Die Näherung nach der **Ersten Ordnung** beinhaltet dabei folgende Rechenschritte:

Durch die Ableitung der Gleichung 4-16 nach der Risslänge, a, erhält man folgende Formel, worin r den Abstand von der Rissspitze darstellt.

$$\frac{dK_{br}}{da} = -\frac{dK_{R}}{da}$$
$$= h(r,a)\sigma_{br}(r,a)\Big|_{r=\Delta a} + \int_{a_{0}}^{a} \frac{\partial h(r,a)}{\partial a}\sigma_{br}(r,a)dr + \int_{a_{0}}^{a} h(r,a)\frac{\partial \sigma_{br}(r,a)}{\partial a}dr$$
A-1

Die Brückenspannungen ergeben sich dann durch umformen der Gleichung A-1

$$\sigma_{br}\big|_{r=\Delta a} = -\frac{1}{h\big|_{r=\Delta a}}\frac{dK_R}{da} - \frac{1}{h\big|_{r=\Delta a}}\int_{a_0}^{a}\frac{\partial h(r,a)}{\partial a}\sigma_{br}(r,a,\Delta a)dr - \frac{1}{h\big|_{r=\Delta a}}\int_{a_0}^{a}h(r,a)\frac{\partial\sigma_{br}(r,a,\Delta a)}{\partial a}dr \qquad A-2$$

Durch die Verwendung von $\sigma_{br}(r) = \sigma_{br}|_{r=\Delta a}$ ergibt sich aus Gleichung A-2 die Lösung der Ersten Ordnung. Die Näherung nach der Ersten Ordnung ist dann durch die folgende Formel gegeben.

$$\sigma_{br}^{(1)}(r) = -\frac{1}{h} \bigg|_{\Delta a = r} \frac{dK_R}{da} \bigg|_{\Delta a = r}$$
A-3

Der Index $\Delta a=r$ in Gleichung A-3 bedeutet hierbei, dass bei der Berechnung der Brückenspannung im Abstand r von der Rissspitze, die Ableitung der R- Kurve an der Stelle $\Delta a=r$ erfolgen muss und die Gewichtsfunktion an der Stelle $\Delta a=r$ einzufügen ist. Es ist zu beachten, das bei der Näherung nach der ersten Ordnung, die Brückenspannungen nur vom Abstand zur Rissspitze, r, abhängen.

Die Näherung der **Zweiten Ordnung** verwendet zusätzlich zum ersten Term der Gleichung A-2 auch das erste Integral. Dadurch wird der Einfluss der Risslänge,

a, auf die Gewichtsfunktion mit berücksichtigt. Zur Lösung der Zweiten Ordnung ist ein Iterativer Rechenvorgang nötig. Unter Verwendung der Brückenspannungsverteilung der Ersten Ordnung (A-3), $\sigma^{(1)}{}_{br}$ ergibt sich für die erste Iteration folgende Gleichung.

$$\sigma_{br}^{(2,1)}(r) = \sigma_{br}^{(1)}(r) - \frac{1}{h\Big|_{r=\Delta a}} \int_{a_0}^{a} \frac{\partial h(r',a)}{\partial a} \sigma_{br}^{(1)}(r') dr'$$
 A-4

Die einzelnen Iterationen verwenden jeweils die zuvor berechneten Brückenspannungen und nur beim Start der Berechnung wird auf die Lösung der Näherung nach der Ersten Ordnung zurück gegriffen.

Literaturverzeichnis

- [Aso-00] Asoo, B.; McNaney, J. M.; Mitamura, Y. & Ritchie, R. O. Cyclic fatigue-crack propagation in sapphire in air and simulated physiological environments *J. BIOMED. MATER. RES. Part A*, **2000**, *52*, 488-491
- [AST-01] Standard Test Method for Measurement of Fatigue Crack Growth Rates The American Society for Testing and Materials; ASTM E647, 2001
- [Bal-84] Ballarini, R.; Shah, S. P. & Keer, L. M. Crack Growth in Cement- based Composites
- Eng. Fract. Mech., 1984, 20, 433-445
 [Bec-96] Becher, P. F.; Sun, E. Y.; Hsueh, C. H.; Alexander, K. B.; Hwang, S. L.; Waters, S. B. & Westmoreland, C. G. Debonding of interfaces between beta-Silicon Nitirde whiskers and
 - Si-Al-Y oxynitride glasses *Acta mater.,* **1996**, *44*, 3881-3893
- [Bec-98] Becher, P. F.; Sun, E. Y.; Plucknett, K. P.; Alexander, K. B.; Hsueh, C. H.; Lin, H. T.; Waters, S. B.; Westmoreland, C. G.; Kang, E. S.; Hirao, K. & Brito, M. E.
 Microstructural Design of Silicon Nitride with Improved Fracture Toughness: I, Effect of Grain Shape and Size J. Am. Ceram. Soc., 1998, 81, 2821-2830
- [Bec-05] Becher, P. F.; Painter, G. S.; Lance, M. J.; Ii, S. & Ikuhara, Y. Direct Observation of Debonding of Reinforcing Grains in Silicon Nitride Ceramics Sintered with Yttria Plus Alumina Additives J. Am. Ceram. Soc., 2005, 88, 1222-1226
- [Bec-08] Becher, P. F.; Painter, G.; Shibata, N.; Waters, S. & Lin, H. T. Effects of Rare Earth (RE) Intergranular Adsorption on the Phase Transformation, Microstrucure Evaluation and Mechanical Properties in Silicon Nitride withe RE₂O₃ + MgO Additives: RE = LA, Gd, Lu *J. Am. Ceram. Soc.*, **2008**, *91*, 2328-2336
- [Bel-08] Belmonte, M.; de Pablos, A.; Osendi, M. I. & Miranzo, P. Effects of seeding and amounts of Y₂O₃:Al₂O₃ additives on grain growth in Si₃N₄ ceramics *Mater. Sci. Eng.*, **2008**, A 475, 185-189
- [Cha-81] Chantikul, P.; Anstis, G. R.; Lawn, B. R. & Marshall, D. B. A Critical-Evaluation of Indentation Techniques for Measuring Fracture-Toughness .2. Strength Method J. Am. Ceram. Soc., 1981, 64, 539-543
- [Chi-00] Ching, W. Y.; Ouyang, L. & Gale, J. D.
 Full ab initio geometry optimization of all known crystalline phases of Si₃N₄
 Physical Review B, **2000**, *61*, 8696-8700

- [Col-55] Collins, J. F. & Gerby, R. W. New Refractory Uses For Silicon Nitride Reported *Journal of Metals*, **1955**, *7*, 612-615
- [Dau-92] Dauskardt, R. H.; James, M. R.; Porter, J. R. & Ritchie, R. O. Cyclic Fatigue- Crack Growth in a SiC- Whisker- Reinforced Alumina Ceramic Composite: Long- and Small- Crack Behavior J. Am. Ceram. Soc., 1992, 75, 759-771
- [Dee-61] Deeley, G. G.; Herbert, J. M. & Moore, N. C. Dense Silicon Nitride *Powder Metallurgy*, **1961**, *8*, 145-151
- [DIN-95] Hochleistungskeramik Monolithische Keramik- Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur -Teil 1: Bestimmung der Biegefestigkeit Normenausschuss Materialprüfung; DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 843-1, 1995
- [DIN-04] Hochleistungskeramik- Prüfverfahren zur Bestimmung der Bruchzähigkeit von monolithischer Keramik- Teil 5: Verfahren für Biegeproben mit VKerb (SEVNBVerfahren) Normenausschuss Materialprüfung; DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN CEN/TS 14425-5, 2004
- [DIN-05] Hochleistungskeramik- Mechanische Eigenschaften monolithischer Keramik bei Raumtemperatur- Teil4: Härteprüfung nach Vickers, Knoop und Rockwell *Normenausschuss Materialprüfung; DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 843-4*, **2005**
- [Döb-06] Döblinger, M.; Winkelmann, G. B.; Dwyer, C.; Marsh, C.; Kirkland, A.
 I.; Cockayne, D. J. H. & Hoffmann, M. J.
 Structural and compositional comparison of Si3N4 ceramics with different fracture modes
 Acta Metall., 2006, 54, 1949-1956
- [Dwy-06] Dwyer, C.; Ziegler, A.; Shibata, N.; Winkelman, G. B.; Satet, R. L.; Hoffmann, M. J.; Cinibulk, M. K.; Becher, P. F.; Painter, G. S.; Browning, N. D.; Cockayne, D. J. H.; Ritchie, R. O. & Pennycook, S. J. Interfacial structure in silicon nitride sintered with lanthanide oxide J. Mater. Sci., 2006, 41, 4405-4412
- [Fet-91] Fett, T.; Martin, G.; Munz, D. & Thun, G. Determination of da/dN-ΔK₁ curves for small cracks in alumina in alternating bending tests *J. Mater. Sci.*, **1991**, *26*, 3320-3328
- [Fet-92a] Fett, T. & Munz, D. Why can microcracks in ceramics propagate at extremely low stress intensity factors? J. Mater. Sci. Lett., 1992, 11, 257-260

[Fet-92]	Fett, T. & Munz, D. Subcritical Crack Growth of Macrocracks in Alumina with R- curve Behavior <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1992 , <i>75</i> , 958-963
[Fet-93]	Fett, T. & Munz, D. Evaluation of R- curve effects in ceramics <i>J. Mater. Sci.,</i> 1993 , <i>28</i> , 742-752
[Fet-95]	Fett, T. & Munz, D. Estimation of Bridging Interactions for Natural Cracks from Bending Strength of Coarse- Grained Al ₂ O ₃ <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1995 , <i>78</i> , 188-192
[Fet-95a]	Fett, T.; Munz, D.; Thun, G. & Bahr, H. A. Evaluation of Bridging Parameters in Aluminas from R-Curves by Use of the Fracture Mechanical Weight Function <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1995 , <i>78</i> , 949-951
[Fet-95b]	Fett, T. & Munz, D. Bridging Stress Relations for Ceramic Materials <i>J. Eur. Ceram. Soc.</i> , 1995 , <i>15</i> , 377-383
[Fet-95c]	Fett, T. Notch effects in determination of fracture toughness and compliance <i>Int. J. Fracture</i> , 1995 , <i>72</i> , R27-R30
[Fet-96]	Fett, T.; Munz, D.; Seidel, J.; Stech, M. & Rödel, J. Correlation between Long and Short Crack R-curves in Alumina using the Crack Opening Displacement and Fracture Mechanical Weight Function Approach <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1996 , <i>79</i> , 1189-1196
[Fet-97]	Fett, T. & Munz, D. Stress Intensity Factors and Weight Functions Computational Mechanics Publications 1997
[Fet-00]	Fett, T.; Munz, D.; Dai, X. & White, K. W. Bridging stress relation from a combined evaluation of the R- curve and post- fracture tensile tests <i>Int. J. Fracture</i> , 2000 , <i>104</i> , 375-385
[Fet-02]	Fett, T. Crack- tip toughness from wide- range COD measurements International Journal of Fracture, 2002 , 114, L29-L32
[Fet-05]	Fett, T.; Munz, D.; Njiwa, A. B. K.; Rödel, J. & Quinn, G. D. Bridging stresses in sintered reaction-bonded Si ₃ N ₄ from COD measurements <i>J. Eur. Ceram. Soc.</i> , 2005 , <i>25</i> , 29-36
[Fet-05a]	Fett, T.; Nijwa, A. B. K. & Rödel, J. Crack opening displacements of Vickers indentation cracks

[Fet-06]	Fett, T. & Munz, D. Influence of narrow starter notches on the initial crack growth resistance curve of ceramics <i>Archive of Applied Mechanics</i> , 2006 , <i>76</i> , 667-679
[Gey-98]	Geyer, A. Potential des Sinter- HIP- Verfahrens in der Entwicklung von Siliziumnitridwerkstoffen für den Hochtemperaturbereich Doktorarbeit, Institut für Keramik im Maschinenbau, Universität Karlsruhe (TH), IKM 25, 1998
[Gil-95]	Gilbert, C. J.; Dauskardt, R. H. & Ritchie, R. O. Behavior of Cyclic Fatigue Cracks in Monolithic Silicon Nitride <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1995 , <i>78</i> , 2291-2300
[Gil-96]	Gilbert, C. J.; Cao, J. J.; Moberlychan, W. J.; Dejonghe, L. C. & Bitchie, B. O.
	Cyclic fatigue and resistance- curve behavior of an in situ toughened silicon carbide with AI-B-C additions <i>Acta mater.</i> , 1996 , <i>44</i> , 3199-3214
[Gil-97]	Gilbert, C. J.; Dauskardt, R. H. & Ritchie, R. O. Microstructural Mechanisms of Cyclic Fatigue- Crack Propagation in Grain- Bridging Ceramics <i>Ceram. Int.</i> , 1997 , <i>23</i> , 413-418
[Gri-20]	Griffith, A. A. The Phenomena of Rupture and Flow in Solids <i>Philosophical Transactions,</i> 1920 , <i>221</i> , 163-198
[Ham-81]	Hampshire, S. & Jack, K. Taylor, D. & Popper, P. <i>(ed.)</i> The Kinetics of Densification and Phase Transformation of Nitrogen Ceramics <i>Special Ceramics. 7. Proc. Brit. Ceram. Soc. , Hrsg. ,</i> 1981 , 37 - 49
[Ham-07]	Hampshire, S. Silicon nitride ceramics - review of structure, processing and properties <i>JAMME</i> , 2007 , <i>24</i> , 43-50
[Ham-08]	Hampshire, S. Oxynitride glasses <i>J. Eur. Ceram. Soc.,</i> 2008 , <i>28</i> , 1475-1483
[Har-57]	Hardie, D. & Jack, K. H. Crystal Structures of Silicon Nitride <i>Nature,</i> 1957 , <i>180</i> , 332-333
[Hay-98]	Hay, J. C.; Sun, E. Y.; Pharr, G. M.; Becher, P. F. & Alexander, K. B. Elastic Anisotropy of β- Silicon Nitride Whiskers <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1998 , <i>81</i> , 2661-2669

[Hof-95]	Hoffmann, M. J. Relationship between microstructure and mechanical properties of silicon nitride ceramics <i>Pure Appl. Chem.</i> , 1995 , <i>67</i> , 939-946
[Hof-95a]	Hoffmann, M. J. High-Temperature Properties of Si ₃ N ₄ Ceramics MBS Bulletin 1995 20 28-32
[Hof-99]	Hoffmann, M. J.; Geyer, A. & Oberacker, R. Potential of the Sinter-HIP-technique for the Development of High- temperature Resistant Si ₃ N ₄ -ceramics <i>J. Eur. Ceram. Soc.</i> , 1999 , <i>19</i> , 2359-2366
[lrw-56]	Irwin, G. R. Onset of fast crack propagation in high strength steel and aluminum alloys <i>Naval Research Laboratory</i> , 1956
[Jel-07]	Jelitto, H.; Felten, F.; Swain, M. V.; Balke, H. & Schneider, G. A. Measurement of the Total Energy Release Rate for Cracks in PZT Under Combined Mechanical and Electrical Loading <i>J. Appl. Mech.</i> , 2007 , <i>74</i> , 1197-1211
[Kee-86]	Keer, L. M.; Farris, T. N. & Lee, J. C. Knoop and Vickers Indentation in Ceramics Analyzed as aThree- Dimensional Fracture <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1986 , <i>69</i> , 392-396
[Kin-58a]	Kingery, W. D. Densification during Sintering in the Presence of a Liquid Phase. I. Theory <i>J. Appl. Phys.,</i> 1958 , <i>30</i> , 301-306
[Kin-58b]	Kingery, W. D. & Narasimhan, M. D. Densification during Sintering in the Presence of a Liquid Phase. II. Experimental <i>J. Appl. Phys.</i> , 1958 , <i>30</i> , 307-310
[Kit-06]	Kitayama, M.; Hirao, K. & Kanzaki, S. Effect of Rare Earth Oxide Additives on the Phase Transformation Rates of Si ₃ N ₄ <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 2006 , <i>89</i> , 2612-2618
[Kle-93]	Kleebe, H. J.; Cinibulk, M. K.; Cannon, R. M. & Rühle, M. Statistical Analysis of the Intergranular Film Thickness in Silicon Nitride Ceramics <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1993 , <i>76</i> , 1969-1977
[Krä-93]	Krämer, M.; Hoffmann, M. J. & Petzow, G. Grain growth kinetics of Si ₃ N ₄ during α /β - transformation <i>Acta Metall. Mater.,</i> 1993 , <i>41</i> , 2939-2947

[Kru-03]	Kruzic, J. J. & Ritchie, R. O. Determining the Toughness of Ceramics from Vickers Indentations Using the Crack- Opening Displacements: An Experimental Study <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 2003 , <i>86</i> , 1433-1436
[Kru-04]	Kruzic, J. J.; Cannon, R. M. & Ritchie, R. O. Crack-size effects on cyclic and monotonic crack growth in polycrystalline alumina: Quantification of the role of grain bridging <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 2004 , <i>87</i> , 93-103
[Kru-05]	Kruzic, J. J.; Cannon, R. M.; III, J. W. A. & Ritchie, R. O. Fatigue threshold R-curves for predicting reliability of ceramics under cyclic loading <i>Acta mater.</i> , 2005 , <i>53</i> , 2595-2605
[Kru-08]	Kruzic, J. J.; Satet, R. L.; Hoffmann, M. J.; Cannon, R. M. & Ritchie, R. O. The utility of R- Curves for Understanding Fracture Toughness- Strength Relations in Bridging Ceramics <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 2008 , <i>91</i> , 1986-1994
[Küb-97]	Kübler, J. Fracture Toughness of Ceramics Using The Sevnb Method: First Result Of A Joint Vamas/ Esis Round Robin <i>Ceram. Eng. Sci. Proc.,</i> 1997 , <i>18, no.4</i> , 155-162
[Küh-93]	Kühne, A. Herstellung von dichtem Si ₃ N ₄ mit geringem Additivgehalten durch optimierte Sinter/HIP Konsolidierung Doktorarbeit, Institut für Keramik im Maschinenbau, Universität Karlsruhe (TH), IKM 11, 1993
[Leh-06]	Lehner, W.; Kleebe, H. J. & Ziegler, G. Variation of sintering parameters at an early stage of densification affecting β - Si ₃ N ₄ - microstructure <i>J. Eur. Ceram. Soc.</i> , 2006 , <i>26</i> , 201-208
[Li-95]	Li, C. W.; Lui, S. C. & Goldacker, J. Relation between Strength, Microstructure, and Grain- Bridging Characteristics in In- Situ Reinforced Silicon Nitride <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1995 , <i>78</i> , 449-459
[Lof-04]	Lofaj, F.; Satet, R.; Hoffmann, M. J. & de Arellano Lopez, A. R. Thermal expansion and glass transition temperature of the rare-earth doped oxynitride glasses <i>J. Fur. Ceram. Soc.</i> , 2004 , <i>24</i> , 3377-3385
[Lub-01]	Lube, T. Indentation crack profiles in silicon nitride <i>J. Eur. Ceram. Soc.</i> , 2001 , <i>21</i> , 211-218
[Man-91]	Maniette, Y.; Inagaki, M. & Saki, M. Fracture Toughness and Crack Bridging of a Silicon Nitride Ceramic <i>J. Eur. Ceram. Soc.</i> , 1991 , <i>7</i> , 255-263

[Mar-83]	Marshall, D. B. Controlled Flaws in Ceramics: A Comparison of Knoop and Vickers Indentation <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1983 , <i>66</i> , 127-131
[Mar-88]	Marshall, D. B. & Swain, M. V. Crack resistance Curves in Magnisa- Partially- Stabilized Zirconia <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1988 , <i>71</i> , 399-407
[Mes-78]	Messier, D. R.; Riley, F. L. & Brook, R. J. The α/β silicon nitride phase transformation <i>Journal of Materials Science</i> , 1978 , <i>13</i> , 1199-1205
[Müc-94]	Mücklich, F.; Hartmann, S.; Hoffmann, M. J.; Schneider, G. A.; Ohser, J. & Petzow, G. Quantitative Describtion of Si3N4 Microstructures <i>Key. Eng. Mat.</i> , 1994 , <i>89-91</i> , 465-470
[Müc-99]	Mücklich, F.; Ohser, J.; Blank, S.; Katrakova, D. & Petzow, G. Stereological Analysis of Grain Size and Grain Shape Applied to Silicon Nitride Ceramics <i>Z. Metallkd.</i> , 1999 , <i>90</i> , 557-561
[Mun-99]	Munz, D. & Fett, T. Ceramics;Failure, Material Selection, Design <i>Springer, Berlin,</i> 1999
[Mun-07]	Munz, D. What can we learn from R- Curve Measurements? <i>J. Am. Ceram. Soc.,</i> 2007 , <i>90</i> , 1-15
[Nis-96]	Nishida, T.; Pezzotti, G.; Mangialardi, T. & Paolini, A. E. Fracture mechanics evaluation of ceramics by stable crack- propagation in bend bar specimens <i>Fract. Mech. Ceram.</i> , 1996 , <i>11</i> , <i>Eds. R.C. Bradt, D.P.H. Hasselman</i> , <i>D. Munz, M. Sakai, V.Y. Shevchenko</i> , 107-114
[Nod-92]	Noda, N. & Oda, K. Numerical solutions of the singular integral equations in the crack analysis using the body force method <i>Int. J. Fracture</i> , 1992 , <i>58</i> , 285-304
[Oga-04]	Ogata, S.; Hirosaki, N.; Kocer, C. & Shibutani, Y. A comparative ab initio study of the "ideal" strength of single crystal α - and β - Si3N4 Acta mater., 2004 , <i>52</i> , 233-238
[Pai-04]	Painter, G. S.; Becher, P. F.; Shelton, W. A.; Satet, R. L. & Hoffmann, M. First- principles study of rare- earth effects on grain growth and microstructure in β - Si ₃ N ₄ ceramics <i>Phys. Rev.</i> , 2004 , <i>B 70</i> , 1-4

[Pet-02]	Petzow, G. & Hermann, M. Jansen, M. <i>(ed.)</i> Silicon Nitride Ceramics <i>High Performance Non-Oxide Ceramics II,</i> 2002 , <i>102</i> , 47-167
[Pez-99]	Pezzotti, G.; Muraki, N.; Maeda, N.; Satou, K. & Nishida, T. In Situ Measurement of Bridging Stresses in Toughened Silicon Nitride Using Raman Microprobe Spectroscopy <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1999 , <i>82</i> , 1249-1256
[Pez-01]	Pezzotti, G.; Ichimaru, H.; Ferroni, L. P.; Hirao, K. & Sbaizero, O. Raman Microprobe Evaluation of Bridging Stresses in Highly Anisotropic Silicon Nitride <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 2001 , <i>84</i> , 1785-1790
[Plu-05]	Plucknett, K. P. & Lin, H. T. Sintering Silicon Nitride Ceramics in Air <i>J. Am. Ceram. Soc.,</i> 2005 , <i>88</i> , 3538-3541
[Qui-07]	Quinn, G. D. & Bradt, R. C. On the Vikers Indentation Fracture Toughness Test <i>J. Am. Ceram. Soc.,</i> 2007 , <i>90</i> , 673-680
[Ram-91]	Ramachandran, N. & Shetty, D. K. Rising Crack- Growth- Resistance (R- Curve) Behavior of Toughened Alumina and Silicon Nitride <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1991 , <i>74</i> , 2634-2641
[Ril-00]	Riley, F. L. Silicon Nitride and Related Materials <i>J. Am. Ceram. Soc.,</i> 2000 , <i>82</i> , 245-265
[Röd-92]	Rödel, J. Crack Closure Forces in Ceramics: Characterization and Formation <i>J. Eur. Ceram. Soc.</i> , 1992 , <i>9</i> , 323-334
[Sal-07]	Salmang, H. & Scholze, H. Telle, R. <i>(ed.)</i> Keramik, <i>Springer, Berlin, 2007</i>
[Sat-02]	Satet, R. L. Einfluss der Grenzflächeneigenschaften auf die Gefügeausbildung und das mechanische Verhalten von Siliciumnitrid-Keramiken Doktorarbeit, Institut für Keramik im Maschinenbau, Universität Karlsruhe (TH), IKM 38, 2002
[Sat-04]	Satet, R. L. & Hoffmann, M. J. Grain growth anisotropy of ß-silicon nitride in rare-earth doped oxynitride glasses <i>J. Eur. Ceram. Soc.</i> , 2004 , <i>24</i> , 3437-3445
[Sat-05]	Satet, R. L. & Hoffmann, M. J. Influence of the rare-earth element on the mechanical properties of RE-Mg bearing silicon nitride <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 2005 , <i>88</i> , 2485-2490

[Sch-96]	Schmitt, R.; Fett, T. & Munz, D. Cyclic Fatigue of Zirconia <i>Fatigue Fract. Eng. M.,</i> 1996 , <i>19</i> , 1411-1420
[Sch-06]	Schneider, G. A. & Fett, T. Computation of the Stress Intensity Factor and COD for Submicron Sized Indentation Cracks <i>J. Ceram. Soc. Jpn.</i> , 2006 , <i>114</i> , 1044-1048
[She-89]	Shetty, D. K. & Wang, J. S. Crack Stability and Strength Distribution of Ceramics That Exhibit Rising Crack- Growth- Resistance (R- Curve) Behavior <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1989 , <i>72</i> , 1158-1162
[Shi-05]	Shibata, N.; Painter, G. S.; Satet, R. L.; Hoffmann, M. J.; Pennycook, S. J. & Becher, P. F. Rare- earth adsorption at intergranular interfaces in silicon nitride ceramics: Subnanometer observations and theory <i>Phys. Rev.</i> , 2005 , <i>B 72</i> , 1-4
[Ste-88]	Steinbrech, R. W. & Schmenkel, O. Crack resistance curves for surface cracks in alumina <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1988 , <i>71</i> , C271-C273
[Ste-90]	Steinbrech, R. W.; Reichl, A. & Schaarwächter, W. R- curve Behavior of Long Cracks in Alumina <i>J. Am. Ceram. Soc.,</i> 1990 , <i>73</i> , 2009-2015
[Ste-98]	Stemmer, S.; Roebben, G. & van der Biest, O. Evolution of grain boundary films in liquid phase sintered silicon nitride during high- temperature testing <i>Acta Metall.</i> , 1998 , <i>46</i> , 5599-5606
[Sue-97]	Suematsu, H.; Mitomo, M.; Mitchell, T. E.; Petrovic, J. J.; Fukunaga, O. & Ohashi, N. The α - β Transformation in Silicon Nitride Single Crystals <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1997 , <i>80</i> , 615-620
[Sun-98]	Sun, E. Y.; Becher, P. F.; Plucknett, K. P.; Hsueh, C. H.; Alexander, K. B.; Waters, S. B.; Hirao, K. & Brito, M. E. Microstructural design of silicon nitride with improved fracture toughness:II, effects of yttria and alumina additives <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1998 , <i>81</i> , 2831-2840
[Sun-99]	Sun, E. Y.; Becher, P. F.; Hsueh, C. H.; Painter, G. S.; Waters, S. B.; Hwang, S. L. & Hoffmann, M. J. Debonding behavior between β - Si ₃ N ₄ whiskers and oxynitride glasses with or without an epitaxial β - SiAlON interfacial layer <i>Acta mater.</i> , 1999 , <i>47</i> , 2777-2785
[Swa-87]	Swanson, P. L.; Fairbanks, C. J.; Lawn, B. R.; Mai, Y. W. & Hockey, B. J. Crack- Interface Grain Bridging as a Fracture Resistance Mechanism in Ceramics: I, Experimental Study on Alumina <i>J. Am. Ceram. Soc.</i> , 1987 , <i>70</i> , 279-289

- [Tho-67] Thompson, D. S. & Pratt, P. L. Stewart, G. H. *(ed.)* The structure of Silicon Nitride *Sience of Ceramics*, **1967**, *3*
- [Uen-96] Ueno, A.; Kishimoto, H.; Kawamoto, H. & Asakura, M. Crack propagation behavior of sintered silicon nitride under cyclic loads of high stress ratio and high frequency *Eng. Fract. Mech.*, **1991**, *40*, 913-920
- [Usa-86] Usami, S.; Kimoto, H.; Takahashi, I. & Shida, S. Strength of Ceramic Materials Containing Small Flaws *Eng. Fract. Mech.*, **1986**, *23*, 745-761
- [Wad-01] Wada, S.; Hattori, T. & Yokoyama, K. Sintering of Si₃N₄ Ceramics in Air Atmosphere Furnace J. Ceram. Soc. Jpn., 2001, 109, 281-283
- [Wad-04] Wada, S.; Chaiyapak, P.; Jinawath, S.; Wasanapiarnpong, T. & Yano, T.
 Sintering of Si₃N₄ Ceramics in Air Atmosphere Furnace(Part 2)-Agglomeration of Packing Powder and Deterioration of Al₂O₃ Crucible J. Ceram. Soc. Jpn., 2004, 112, 234-237
- [Wan-96] Wang, C. M.; Pan, X.; Hoffmann, M. J.; Cannon, R. M. & Rühle, M. Grain Boundary Films in Rare-Earth-Glass-Bases Silicon Nitride *J. Am. Ceram. Soc.*, **1996**, *79*, 788-792
- [Win-05] Winkelmann, G. B.; Dwyer, C.; Hudson, T. S.; Nguyen-Manh, D.; Döblinger, M.; Satet, R. L.; Hoffmann, M. J. & Cockayne, D. J. H. Three- dimensional organization of rare- earth atoms at grain boundaries in silicon nitride *Appl. Phys. Lett.*, **2005**, *87*, 1-3
- [Wit-91] Wittmann, F. H. & Hu, X. Fracture process zone in cementitious materials Int. J. Fracture, **1991**, *51*, 3-18
- [Yu-90] Yu, C. S. & Shetty, D. K. Transformation yielding, plasticity and crack- growth- resistance (Rcurve) behavior of CeO2- TZP J. Mater. Sci., 1990, 25, 2025-2035
- [Zer-99] Zerr, A.; Miehe, G.; Serghiou, G.; Schwarz, M.; Kroke, E.; Riedel, R.; Fueß, H.; Kroll, P. & Boehler, R. Synthesis of cubic silicon nitride *Nature*, **1999**, *400*, 340-342

ISSN 1436-3488 ISBN 978-3-86644-470-6

